

P_c = Puissance collecteur max.

I_c = Courant collecteur max.

V_{ce} max = Tension collecteur émetteur max.

F_{max} = Fréquence max.

Ge = Germanium

Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Matériau	Type	V _{ce} max	I _c max	F _{max}	P _c max	Gain		Type	Équivalent		
							h _{FE}	h _{FE}		Transistor	Commutateur	
2 N 5770	Si	NPN	0,700	0,050	15	900	40		T092	MPSH 17	2 N 4874	
2 N 5771	Si	PNP	0,625	0,050	15	850	35		T092	2 N 5057	BSW 25	
2 N 5772	Si	NPN	0,625	0,200	15	350	30		T092	2 N 5770	2 N 4874	
2 N 5773	Si	NPN	5	0,500	35		20	200	T0117	PT 3540	2 N 4127	
2 N 5774	Si	NPN	18	1,5	35		20	200	T0129	2 SC 737	PT 4690	
2 N 5775	Si	NPN	40	3	35		10	150	F21	2 N 5177		
2 N 5776	Si	NPN	70	6	35		10	150	F21	2 N 5714		
2 N 5777 4)	Si	NPN	0,200	0,004	25	1	2,5 K		T092	2 N 5779	MRD 148	
2 N 5778 4)	Si	NPN	0,200	0,004	40	1	2,5 K		T092	2 N 5780	MRD 148	
2 N 5779 4)	Si	NPN	0,200	0,008	25	1	5 K		T092	2 N 5777	MRD 148	
2 N 5780 4)	Si	NPN	0,200	0,008	40	1	5 K		T092	2 N 5778	MRD 148	
2 N 5781	Si	PNP	10	3,5	80	8	20	100	T05	2 N 6190	2 N 6191	
2 N 5782	Si	PNP	10	3,5	65	8	20	100	T05	2 N 3720	MJ 8100	
2 N 5783	Si	PNP	10	3,5	45	8	20	100	T05	2 N 3719	2 N 3782	
2 N 5784	Si	NPN	10	3,5	80		20	100	T05	2 N 5335	2 N 6416	
2 N 5785	Si	NPN	10	3,5	65		20	100	T05	2 N 5334	2 N 6413	
2 N 5786	Si	NPN	10	3,5	45		20	100	T05	BSX 62	2 N 6412	
2 N 5793 d)	Si	NPN	0,500	0,600	40	200	25		T078	2 N 5794		
2 N 5794 d)	Si	NPN	0,500	0,600	40	200	50		T078	2 N 5793		
2 N 5795 d)	Si	PNP	0,500	0,600	60	200	40		T078	2 N 5796		
2 N 5796 d)	Si	PNP	0,500	0,600	60	200	100		T078	2 N 5795		
2 N 5797 3)	Si	CalP	0,200	0,010 (lg) 15 (Vds)			gfs 0,060	(mhos) 0,225		T072	2 N 5798	MFE 4008
2 N 5798 3)	Si	CalP	0,200	0,010 (lg) 15 (Vds)			0,100	0,400		T072	2 N 5799	MFE 4009
2 N 5799 3)	Si	CalP	0,200	0,010 (lg) 15 (Vds)			0,160	0,500		T072	2 N 5798	MFE 4010
2 N 5800 3)	Si	CalP	0,200	0,010 (lg) 15 (Vds)			0,250	0,700		T072	2 N 5799	MFE 4011
2 N 5804	Si	NPN	62	5	300	15	10	100	T03	BDY 43	2 N 5839	
2 N 5805	Si	NPN	62	5	375	15	10	100	T03	BDY 44	BU 326	
2 N 5810	Si	NPN	0,500	0,750	25	150	60	200	T018 ou X55	2 N 5812	BC 338-16	
2 N 5811	Si	PNP	0,500	0,750	25	150	60	200		T018 ou X55	2 N 5813	BC 328-16
2 N 5812	Si	NPN	0,500	0,750	25	165	150	500	T018 ou X55	2 N 5810	BC 338-40	
2 N 5813	Si	PNP	0,500	0,750	25	165	150	500		T018 ou X55	2 N 5811	BC 328-40
2 N 5814	Si	NPN	0,500	0,750	40	120	60	200	T018 ou X55	2 N 5816	BC 337-16	
2 N 5815	Si	PNP	0,500	0,750	40	120	60	200		T018 ou X55	2 N 5817	BC 327-16

3) transistors FET

d) transistors doubles

4) Photo-DARLINGTON

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 5816	Si	NPN	0,500	0,750	40	135	100	200	T018 ou X55	2 N 5814	BC 337-16
2 N 5817	Si	PNP	0,500	0,750	40	135	100	200	T018 ou X55	2 N 5815	BC 327-16
2 N 5818	Si	NPN	0,500	0,750	40	150	150	300	T018 ou X55	2 N 5816	BC 337-25
2 N 5819	Si	PNP	0,500	0,750	40	150	150	300	T018 ou X55	2 N 5817	BC 327-25
2 N 5820	Si	NPN	0,500	0,750	60	115	60	120	T018 ou X55	2 N 5822	BCW 91 A
2 N 5821	Si	PNP	0,500	0,750	60	115	60	120	T018 ou X55	2 N 5823	BCW 93 A
2 N 5822	Si	NPN	0,500	0,750	60	135	100	200	T018 ou X55	2 N 5820	BCW 91 A
2 N 5823	Si	PNP	0,500	0,750	60	135	100	200	T018 ou X55	2 N 5821	BCW 93 A
2 N 5824	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	60	120	T018 ou X55	2 N 5825	BF 291
2 N 5825	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	100	200	T018 ou X55	2 N 5826	BF 291
2 N 5826	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	150	300	T018 ou X55	2 N 5825	2 N 3947
2 N 5827	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	250	500	T018 ou X55	2 N 5827 A	TIS 97
2 N 5827 A	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	250	500	T018 ou X55	2 N 5827	2 N 5828 A
2 N 5828	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	400	800	T018 ou X55	2 N 5828 A	TIS 97
2 N 5828 A	Si	NPN	0,360	0,100	40	150	400	800	T018 ou X55	2 N 5828	2 N 5827 A
2 N 5829	Si	PNP	0,200	0,030	30	1,2 GHz	20		T072	2 N 4957	2 N 4959
2 N 5830	Si	NPN	0,625	0,600	100	100	60		T092	BF 117	2 N 1715
2 N 5831	Si	NPN	0,625	0,600	140	100	60		T092	2 N 5832	A 5 T 5550
2 N 5832	Si	NPN	0,625	0,600	140	100	125		T092	2 N 5831	2 SC 1670
2 N 5833	Si	NPN	0,625	0,600	180	100	50		T092	2 N 5965	BFW 36
2 N 5834	Si	PNP	5	1	40		10		T039	BFS 94	MM 4019
2 N 5835	Si	NPN	0,200	0,015	10	2,5 GHz	25		T072	2 N 6595	40915
2 N 5836	Si	NPN	2	0,200	10	2 GHz	25		T046	BFT 51	
2 N 5837	Si	NPN	2	0,300	5	1,7 GHz	25		T046	BFT 51	
2 N 5838	Si	NPN	57	3	275	5	8	40	T03	JAN 2 N 5838	
2 N 5839	Si	NPN	57	3	300	5	10	50	T03	TIP 529	MJ 3028
2 N 5840	Si	NPN	57	3	375	5	10	50	T03	JAN 2 N 5840	2 N 5467
2 N 5841	Si	NPN	0,350	0,100	10	2 GHz	25		T072	2 N 5835	2 SC 1988
2 N 5842	Si	NPN	0,350	0,100	10	1,7 GHz	25		T072	2 N 5835	BFW 30
2 N 5843 d)	Si	PNP	0,500	0,050	40	200	50		T078	2 N 5844	2 N 4937
2 N 5844 d)	Si	PNP	0,500	0,050	40	250	100		T078	2 N 5843	2 N 4938
2 N 5845	Si	NPN	0,500	0,600	40	200	50		T092	2 N 5845 A	BSW 26
2 N 5845 A	Si	NPN	0,625	0,600	40	250	50		T092	MPS 2222 A	TIS 136

i) transistors doubles

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 5846	Si	NPN	10	1	18		5		T0102	2 N 6366	2 N 3925
2 N 5847	Si	NPN	20	2	18				T72	MRF 233	BLY 87, A
2 N 5848	Si	NPN	50	3,5	24		3		T72	MRF 234	
2 N 5849	Si	NPN	100	7	24		3		T75	MRF 235	2 N 5691
2 N 5851	Si	NPN	0,500	0,100	15	500	40		T072	2 N 5852	BFY 63
2 N 5852	Si	NPN	0,500	0,100	15	700	40		T072	BFY 63	2 N 5851
2 N 5853	Si	PNP	66	10	80	15	30	90	T061	2 N 5007	2 N 5623
2 N 5854	Si	PNP	66	10	80	20	30	90	T061	2 N 5009	2 N 5625
2 N 5855	Si	PNP	0,750	1	60	100	50		T0105	BC 363	BC 343
2 N 5856 c)	Si	NPN	0,750	1	60	100	50		T0105	BC 366	BC 342
2 N 5857	Si	PNP	0,750	1	80	100	50		T0105	BC 364	BC 345
2 N 5858 c)	Si	NPN	0,750	1	80	100	50		T0105	BC 367	BC 344
2 N 5859	Si	NPN	1	2	40	250	15	100	T039	MM 5189	BD 509
2 N 5860	Si	NPN	1	2	45	250	35	100	T039	TIP 541	BD 373 A
2 N 5861	Si	NPN	1	2	50	250	25	100	T039	MM 5262	2 N 1085
2 N 5862	Si	NPN	80	8	35		5		T75		2 SC 2039
2 N 5864	Si	PNP	1,2	1,5	70	50	50	500	T039	RCA 1 A 05	SK 3513
2 N 5865	Si	PNP	1,2	1	50	100	40	200	T039	RCA 1 A 02	BSS 18
2 N 5867	Si	PNP	87	5	60	4	20	100	T03	2 N 4905	2 N 4902
2 N 5868	Si	PNP	87	5	80	4	20	100	T03	2 N 4906	2 N 4903
2 N 5869 c)	Si	NPN	87	5	60	4	20	100	T03	2 N 4914	2 N 5068
2 N 5870 c)	Si	NPN	87	5	80	4	20	100	T03	2 N 4915	2 N 5069
2 N 5871	Si	PNP	115	7	60	4	20	100	T03	BDX 92	2 N 6317
2 N 5872	Si	PNP	115	7	80	4	20	100	T03	BDX 94	2 N 6318
2 N 5873 c)	Si	NPN	115	7	60	4	20	100	T03	2 N 3447	2 N 3490
2 N 5874 c)	Si	NPN	115	7	80	4	20	100	T03	2 N 3448	2 N 3491
2 N 5875	Si	PNP	150	10	60	4	20	100	T03	BD 312	2 N 3791
2 N 5876	Si	PNP	150	10	80	4	20	100	T03	BD 314	2 N 3792
2 N 5877 c)	Si	NPN	150	10	60	4	20	100	T03	BD 311	2 N 3715
2 N 5878 c)	Si	NPN	150	10	80	4	20	100	T03	BD 313	2 N 3716
2 N 5879	Si	PNP	160	15	60	4	20	100	T03	MJ 2955	2 N 6285
2 N 5880	Si	PNP	160	15	80	4	20	100	T03	BD 316	2 N 6286
2 N 5881 c)	Si	NPN	160	15	60	4	20	100	T03	BDW 51 A	BDX 61

c) complémentaires des 2 précédents (60 V-80 V)

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Matériau	Type	Ic (mA)	Vce max (V)	Fmax (MHz)	hFE	Pc (mW)		Boîte	Réf. fabricant	Autres
							continu	impulsif			
2 N 5882 c)	Si	NPN	160	15	80	4	20	100	T03	BD 315	2 N 6254
2 N 5883	Si	PNP	200	25	60	4	20	100	T03	BD 367	2 N 4399
2 N 5884	Si	PNP	200	25	80	4	20	100	T03	BD 369	2 N 6436
2 N 5885 c)	Si	NPN	200	25	60	4	20	100	T03	BD 366	2 N 5302
2 N 5886 c)	Si	NPN	200	25	80	4	20	100	T03	BD 368	2 N 2819
2 N 5887	Ge	PNP	57	7	20		15	350	T066	2 N 456-A	MP 2060
2 N 5888	Ge	PNP	57	7	30		15	350	T066	2 N 5901	2 N 457 A
2 N 5889	Ge	PNP	57	7	30		30	70	T066	2 N 5893	2 N 457 A
2 N 5890	Ge	PNP	57	7	45		30	70	T066	2 N 5894	2 N 458 A
2 N 5891	Ge	PNP	57	7	60		30	70	T066	2 N 5895	MP 2063
2 N 5892	Ge	PNP	57	7	75		30	70	T066	2 N 5896	MP 1613
2 N 5893	Ge	PNP	57	7	30		60	120	T066	2 N 5897	2 N 457 A
2 N 5894	Ge	PNP	57	7	45		60	120	T066	2 N 5898	MP 2062
2 N 5895	Ge	PNP	57	7	60		60	120	T066	2 N 5899	MP 2063
2 N 5896	Ge	PNP	57	7	75		60	120	T066	2 N 5900	MP 1613
2 N 5897	Ge	PNP	57	7	30		100	200	T066	2 N 5893	2 N 457 A
2 N 5898	Ge	PNP	57	7	45		100	200	T066	2 N 5894	MP 2062
2 N 5899	Ge	PNP	57	7	60		100	200	T066	2 N 5895	MP 2063
2 N 5900	Ge	PNP	57	7	75		100	200	T066	2 N 5896	MP 1613
2 N 5901	Ge	PNP	57	7	30		175	350	T066	2 N 5888	2 N 457 A
2 N 5902 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		gfs 0,070	(mhos) 0,250	T078	2 N 5905	NDF 9401
2 N 5903 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5904	NDF 9402
2 N 5904 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5903	NDF 9403
2 N 5905 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5902	NDF 9404
2 N 5906 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5909	NDF 9405
2 N 5907 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5908	NDF 9406
2 N 5908 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5907	NDF 9407
2 N 5909 3d)	Si	CaIn	0,367		10 (Vds)		0,070	0,250	T078	2 N 5906	NDF 9408
2 N 5910	Si	PNP	0,310	0,050	20	700	15		T0106	2 N 6003	BF 740
2 N 5911 3d)	Si	CaIn	0,367	0,001 (Ig)	10 (Vds)		gfs 5	(mhos) 10	T078	2 N 5912	MMF 1-6
2 N 5912 3d)	Si	CaIn	0,367	0,001 (Ig)	10 (Vds)		5	10	T078	2 N 5911	MMF 1-6
2 N 5913	Si	NPN	3,5	0,330	14				T039	MRF 607	40953
2 N 5914	Si	NPN	5,7	0,500	14				T78		2 N 6256

d) transistor FET doubles

c) complémentaires des 2 précédents (60 V-80 V)

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 N 5915	Si	NPN	10	1,5	14				T78	2 N 5995	
2 N 5916	Si	NPN	4	0,200	24	1 GHz	20		W42	2 N 5917	BFR 83
2 N 5917	Si	NPN	4	0,200	24	1 GHz	20		W42	2 N 5916	BFR 83
2 N 5918	Si	NPN	10	0,750	30				T78		JAN 2 N 5918
2 N 5919	Si	NPN	25	1,5	30				T78		JAN 2 N 5919 A
2 N 5919 A	Si	NPN	25	4,5	30				T0216		JAN 2 N 5919 A
2 N 5920	Si	NPN	3,5	0,250	50				X82	40836	2 N 5470
2 N 5921	Si	NPN	14	0,700	50				MM15		40909
2 N 5922	Si	NPN	5	0,425	35				T75	2 N 5923	HF 8004
2 N 5923	Si	NPN	6	0,750	35				T75		
2 N 5924	Si	NPN	10	1,5	35				T75	2 N 6202	2 N 6197
2 N 5925	Si	NPN	13	2,5	35				T75		2 N 5847
2 N 5926	Si	NPN	200	50	120		10	40	T063	2 N 6279	2 N 6275
2 N 5927	Si	NPN	200	100	120		10	40	T0114	2 N 5928	SDT 9673
2 N 5928	Si	NPN	200	100	120		10	40	T0114	2 N 5927	SDT 9673
2 N 5929	Si	NPN	100	30	80	30	20	100	F4	2 N 5935	2 N 4002
2 N 5930	Si	NPN	100	30	120	30	20	100	F4	2 N 5936	BDY 58
2 N 5931	Si	NPN	100	30	160	30	20	100	F4	2 N 5937	2 N 5584
2 N 5932	Si	NPN	100	30	60	30	20	100	F4	2 N 6326	BUY 51 A
2 N 5933	Si	NPN	100	30	100	30	20	100	F4	2 N 6328	2 N 4003
2 N 5934	Si	NPN	100	30	140	30	20	100	F4	SDT 9706	2 N 6340
2 N 5935	Si	NPN	100	30	80	30	20	100	F4	2 N 5929	2 N 4002
2 N 5936	Si	NPN	100	30	120	30	20	100	F4	2 N 5930	BDY 58
2 N 5937	Si	NPN	100	30	160	30	20	100	F4	2 N 5931	2 N 5584
2 N 5938	Si	NPN	2,5	3	50	150	30	150	T126	BD 233	BD 235
2 N 5939	Si	NPN	2	10	80	120	40	200	T0111	2 N 5940	2 N 6495
2 N 5940	Si	NPN	2	10	70	120	40	200	T0111	2 N 5939	2 N 6495
2 N 5941	Si	NPN	80	6	35	50	10		W52		S 10-28
2 N 5942	Si	NPN	140	12	35	50	10		W52		2 N 6201
2 N 5943	Si	NPN	1	0,400	30	1 GHz	25	300	T039	2 SC 1083	41039
2 N 5944	Si	NPN	5	0,400	16		20		T90		2 N 5698
2 N 5945	Si	NPN	15	0,800	16		20		T90	MRF 818	SD 1145
2 N 5946	Si	NPN	37	2	16		20		T90	MRF 824	SD 1146

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 5947	Si	NPN	16	0,400	30	1,1 GHz	25	250	T81	PT 3540	PT 4144
2 N 5949	Si	CaIN	0,360		15 (Vds)		3,5	7,5	X55	2 N 5950	2 N 5245
2 N 5950	Si	CaIN	0,360		15 (Vds)		3,5	7,5	X55	2 N 5949	2 N 5246
2 N 5951	Si	CaIN	0,360		15 (Vds)		3,5	6,5	X55	2 N 5950	2 N 5247
2 N 5952	Si	CaIN	0,360		15 (Vds)		2	6,5	X55	2 N 5953	2 N 5248
2 N 5953	Si	CaIN	0,360		15 (Vds)		2	6,5	X55	2 N 5952	2 N 5249
2 N 5954	Si	PNP	40	6	85	5	20	100	T066	TIP 42 B	MJE 42 B
2 N 5955	Si	PNP	40	6	65	5	20	100	T066	TIP 42 A	MJE 42 A
2 N 5956	Si	PNP	40	6	45	5	20	100	T066	TIP 42	MJE 42
2 N 5957	Si	NPN	100	20	100	10	30	120	F4	2 N 5959	TIP 35 C
2 N 5958	Si	PNP	100	20	100	10	30	120	T061	2 N 5960	TIP 36 C
2 N 5959	Si	NPN	100	20	100	10	30	120	F4	2 N 5957	TIP 35 C
2 N 5960	Si	PNP	100	20	100	10	30	120	T061	2 N 5958	TIP 36 C
2 N 5961	Si	NPN	0,625	0,050	60	100	150		T092	2 N 6540	2 N 6541
2 N 5962	Si	NPN	0,625	0,050	45	100	600		T092	2 N 6539	2 N 6538
2 N 5963 4)	Si	NPN	0,625	0,050	30	150	1200		T092	MPSD 04	MPSD 54
2 N 5964	Si	NPN	0,700	0,600	150	1	50		T0105	2 N 5831	2 N 3389
2 N 5965	Si	NPN	0,700	0,600	180	1	50		T0105	2 N 5833	BFW 36
2 N 5966	Si	NPN	125	30	100	10	25	120	T063	2 N 5968	2 N 6328
2 N 5967 c)	Si	PNP	125	30	100	10	25	120	T063	2 N 5969	2 N 6331
2 N 5968	Si	NPN	125	30	100	10	25	120	T063	2 N 5966	2 N 6328
2 N 5969 c)	Si	PNP	125	30	100	10	25	120	T063	2 N 5967	2 N 6331
2 N 5970	Si	NPN	85	15	80	4	20	60	T03	2 N 5971	BD 545 B
2 N 5971	Si	NPN	85	15	80	4	15	150	T03	2 N 5970	BD 545 B
2 N 5972	Si	NPN	85	15	90	4	25	75	T03	BDX 23	BD 545 C
2 N 5973	Si	NPN	85	15	100	4	25	75	T03	2 SD 375	BD 545 C
2 N 5974	Si	PNP	75	5	40	2	20	120	B16	MJE 42	TIP 42
2 N 5975	Si	PNP	75	5	60	2	20	120	B16	MJE 42 A	TIP 42 A
2 N 5976	Si	PNP	75	5	80	2	20	120	B16	MJE 42 B	TIP 42 B
2 N 5977 c)	Si	NPN	75	5	40	2	20	120	B16	MJE 41	TIP 41
2 N 5978 c)	Si	NPN	75	5	60	2	20	120	B16	MJE 41 A	TIP 41 A
2 N 5979 c)	Si	NPN	75	5	80	2	20	120	B16	MJE 41 B	TIP 41 B
2 N 5980	Si	PNP	90	8	40	2	20	120	B16	MJE 5980	BD 544

c) complémentaires des précédents : 40, 60, 80, 100 V

4) transistor DARLINGTON

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 5981	Si	PNP	90	8	60	2	20	120	B16	MJE 5981	BDX 92
2 N 5982	Si	PNP	90	8	80	2	20	120	B16	MJE 5982	BDX 94
2 N 5983 c)	Si	NPN	90	8	40	2	20	120	B16	MJE 5983	2 N 2338
2 N 5984 c)	Si	NPN	90	8	60	2	20	120	B16	MJE 5984	2 N 5037
2 N 5985 c)	Si	NPN	90	8	80	2	20	120	B16	MJE 5985	2 N 5878
2 N 5986	Si	PNP	100	12	40	2	20	120	B16	BDW 52	2 N 6594
2 N 5987	Si	PNP	100	12	60	2	20	120	B16	BDW 52 A	BDX 18
2 N 5988	Si	PNP	100	12	80	2	20	120	B16	BDW 52 B	PTC 164
2 N 5989 c)	Si	NPN	100	12	40	2	20	120	B16	BDW 51	MJE 1660
2 N 5990 c)	Si	NPN	100	12	60	2	20	120	B16	BDW 51 A	MJE 1661
2 N 5991 c)	Si	NPN	100	12	80	2	20	120	B16	BDW 51 B	2 N 3055
2 N 5992	Si	NPN	35	5	30				T78	2 N 5994	2 N 6105
2 N 5993	Si	NPN	35	5	18				T78	2 N 5996	
2 N 5994	Si	NPN	35	5	30				T78	2 N 5992	2 N 6105
2 N 5995	Si	NPN	10	1,5	14				T78		2 N 5945
2 N 5996	Si	NPN	35	5	18				T78	2 N 5993	
2 N 5998	Si	NPN	0,400	0,500	25		150		T098	2 N 5420	2 N 6008
2 N 5999 a)	Si	PNP	0,400	0,500	25		150		T098	2 N 6009	BCW 11
2 N 6000	Si	NPN	0,400	0,500	25	350	70		X55 ou T018	2 N 3402	2 N 3403
2 N 6001	Si	PNP	0,400	0,500	25	700	85		X55 ou T018	2 N 6003	
2 N 6002	Si	NPN	0,400	0,500	25	450	175		X55 ou T018	2 SC 137	MPS 3415
2 N 6003	Si	PNP	0,400	0,500	25	800	235		X55 ou T018		2 N 6001
2 N 6004	Si	NPN	0,400	0,500	40	350	70		X55 ou T018	2 N 2220 A	2 N 3904
2 N 6005	Si	PNP	0,400	0,500	40	700	85		X55 ou T018	2 N 6007	
2 N 6006	Si	NPN	0,400	0,500	40	450	175		X55 ou T018	MPSH 24	2 N 6012
2 N 6007	Si	PNP	0,400	0,500	40	800	235		X55 ou T018		2 N 6005
2 N 6008	Si	NPN	0,400	0,500	25		250		T098	MPS 6515	2 N 5420
2 N 6009 a)	Si	PNP	0,400	0,500	25		250		T098	BCW 11	2 N 5999
2 N 6010	Si	NPN	0,500	0,800	40	330	65		X55 ou T018	2 N 6012	2 N 3904
2 N 6011	Si	PNP	0,500	0,800	40	240	90		X55 ou T018	2 N 6013	BCW 96
2 N 6012	Si	NPN	0,500	0,800	40	420	155		X55 ou T018	MPSH 24	2 N 6006
2 N 6013	Si	PNP	0,500	0,800	40	360	225		X55 ou T018	PN 4917	2 N 6011
2 N 6014	Si	NPN	0,500	0,800	60	330	65		X55 ou T018	BC 431	BC 425

a) apparié avec le précédent

c) complémentaires des 3 précédents : 40, 60, 80 V

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences		
							min.	max.		La plus approchée	Approximative	
2 N 6015	Si	PNP	0,500	0,800	60	240	90		X55 ou T018	2 N 6017	2 N 5796	
2 N 6016	Si	NPN	0,500	0,800	60	420	155		X55 ou T018	2 N 6014	BCW 91	
2 N 6017	Si	PNP	0,500	0,800	60	360	225		X55 ou T018	2 N 3799	BC 313 A	
2 N 6021	Si	PNP	36	4	70		30	120	B17	2 N 6022	BD 442	
2 N 6022	Si	PNP	36	4	70		30	120	B17	2 N 6021	BD 442	
2 N 6023	Si	PNP	36	4	40		30	120	B17	2 N 6024	BD 438	
2 N 6024	Si	PNP	36	4	40		30	120	B17	2 N 6023	BD 438	
2 N 6025	Si	PNP	36	4	60		30	120	B17	2 N 6026	BD 440	
2 N 6026	Si	PNP	36	4	60		30	120	B17	2 N 6025	BD 440	
2 N 6027 2)	Si	PNP	0,300	2 μ A (Ip) 50 μ A (Iv)						T092	MPU 131	MPU 132
2 N 6028 2)	Si	PNP	0,300	0,15 μ A (Ip) 25 μ A (Iv)						T092	MPU 133	2 N 6114
2 N 6029	Si	PNP	200	16	100	1	25	100	T03	BD 318	BDW 52 C	
2 N 6030	Si	PNP	200	16	120	1	20	80	T03	2 SB 539 A	2 SB 539	
2 N 6031	Si	PNP	200	16	140	1	15	60	T03	2 SB 539 B		
2 N 6032	Si	NPN	140	50	90	50	10	50	T03	ESM 6032	2 N 6060	
2 N 6033	Si	NPN	140	40	120	50	10	50	T03	ESM 6033	2 N 6571	
2 N 6034	Si	PNP	40	4	40	1	750	15 K	B6	2 N 6414	2 N 5193	
2 N 6035	Si	PNP	40	4	60	1	750	15 K	B6	BD 678 A	BD 678	
2 N 6036	Si	PNP	40	4	80	1	750	15 K	B6	BD 680 A	BD 680	
2 N 6037 c)	Si	NPN	40	4	40	1	750	15 K	B6	2 N 6412	BD 5190	
2 N 6038 c)	Si	NPN	40	4	60	1	750	15 K	B6	BD 677 A	BD 677	
2 N 6039 c)	Si	NPN	40	4	80	1	750	15 K	B6	BD 679 A	BD 679	
2 N 6040	Si	PNP	75	8	60	4	1000	2000	B23	BD 698 A	BD 698	
2 N 6041	Si	PNP	75	8	80	4	1000	2000	B23	BD 700 A	BD 700	
2 N 6042	Si	PNP	75	8	100	4	1000	2000	B23	BD 702	BD 602	
2 N 6043 c)	Si	NPN	75	8	60	4	1000	2000	B23	BD 697 A	BD 697	
2 N 6044 c)	Si	NPN	75	8	80	4	1000	2000	B23	BD 699 A	BD 699	
2 N 6045 c)	Si	NPN	75	8	100	4	1000	2000	B23	BD 701	BD 601	
2 N 6046	Si	NPN	114	20	60	30	20	100	T063	2 N 3598	2 N 4210	
2 N 6047	Si	NPN	114	20	100	30	20	100	T063	2 N 5957	2 N 5959	
2 N 6048	Si	NPN	114	20	140	30	20	100	T063	2 N 6340	MJ 15003	
2 N 6049	Si	PNP	75	4	55	3	25	100	T066	2 N 6296	2 N 5194	
2 N 6050	Si	PNP	150	12	60	4	750	18 K	T03	MJ 2500	2 N 4908	

2) transistor unijonction c) complémentaires des 3 précédents : 40, 60, 80, 100 V

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6092 d)	Si	NPN	0,300	0,030	60	60	150		T078	2 N 6091	2 N 2920
2 N 6093	Si	NPN	83	10	35	100	20		MT67	sans cause boîtier spécial	sans
2 N 6094	Si	PNP	8	1	18		5		W52	sans	sans
2 N 6095	Si	PNP	20	2,5	18		15		W52	MRF 432	MRF 433
2 N 6096	Si	PNP	40	4	18		15		W52	sans	sans
2 N 6097	Si	PNP	60	6	18		15		W52	sans	sans
2 N 6098	Si	NPN	75	10	60		20	80	T0220	2 N 6099	RCA 41 SDH
2 N 6099	Si	NPN	75	10	60		20	80	T0220	2 N 6098	RCA 41 SDH
2 N 6100	Si	NPN	75	10	70		20	80	T0220	2 N 6101	RCA 1 C 07
2 N 6101	Si	NPN	75	10	70		20	80	T0220	2 N 6100	RCA 1 C 07
2 N 6102	Si	NPN	75	16	40		15	60	T0220	2 N 6103	RCA 41 SDH
2 N 6103	Si	NPN	75	16	40		15	60	T0220	2 N 6102	RCA 41 SDH
2 N 6104	Si	NPN	36	4,5	30				W76		2 N 6105
2 N 6105	Si	NPN	36	4,5	30				T78		2 N 6104
2 N 6106	Si	PNP	40	7	70	10	30	150	T0220	2 N 6107	40874
2 N 6107	Si	PNP	40	7	70	10	30	150	T0220	2 N 6106	40874
2 N 6108	Si	PNP	40	7	50	10	30	150	T0220	2 N 6109	40876
2 N 6109	Si	PNP	40	7	50	10	30	150	T0220	2 N 6108	40876
2 N 6110	Si	PNP	40	7	30	10	30	150	T0220	2 N 6111	41501
2 N 6111	Si	PNP	40	7	30	10	30	150	T0220	2 N 6110	41501
2 N 6112	Si	NPN	0,360		30	160	185		X149	2 N 4953	2 N 4952
2 N 6114 2)	Si	NPN	0,300	5 μ A (Ip)	1 mA (Iv)				R149	2 N 6115	D 5 E 37
2 N 6115 2)	Si	NPN	0,300	15 μ A (Ip)	1 mA (Iv)				R149	2 N 6114	D 5 E 37
2 N 6116 2)	Si	PNP	0,250	5 μ A (Ip)	70 μ A (Iv)				T018	2 N 6117	TIS 43
2 N 6117 2)	Si	PNP	0,250	2 μ A (Ip)	50 μ A (Iv)				T018	2 N 6118	2 N 6027
2 N 6118 2)	Si	PNP	0,250	1 μ A (Ip)	50 μ A (Iv)				T018	2 N 6117	2 N 6028
2 N 6119 2)	Si	PNP	0,400	5 μ A (Ip)	1,5 mA (Iv)				T018	2 N 6120	2 N 6137
2 N 6120 2)	Si	PNP	0,400	1 μ A (Ip)	1 mA (Iv)				T018	2 N 6119	2 N 6138
2 N 6121	Si	NPN	40	4	45	2,5	25	100	T0220	2 N 5190	BD 187
2 N 6122	Si	NPN	40	4	60	2,5	25	100	T0220	2 N 5191	BD 189
2 N 6123	Si	NPN	40	4	80	2,5	20	80	T0220	2 N 5192	BD 589
2 N 6124 c)	Si	PNP	40	4	45	2,5	25	100	T0220	2 N 5193	BD 188
2 N 6125 c)	Si	PNP	40	4	60	2,5	25	100	T0220	2 N 5194	BD 190

1) complémentaires des 2 précédents (60 et 80 V)

d) transistors doubles

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	N a t u r e	P o l a r i t é	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6051	Si	PNP	150	12	80	4	750	18 K	T03	MJ 2501	2 N 3792
2 N 6052	Si	PNP	150	12	100	4	750	18 K	T03		MJ 4032
2 N 6053	Si	PNP	100	8	60	4	750	18 K	T03	MJ 900	2 N 6298
2 N 6054	Si	PNP	100	8	80	4	750	18 K	T03	MJ 901	2 N 6299
2 N 6055 c)	Si	NPN	100	8	60	4	750	18 K	T03	MJ 1000	2 N 6300
2 N 6056 c)	Si	NPN	100	8	80	4	750	18 K	T03	MJ 1001	2 N 6301
2 N 6057	Si	NPN	150	12	60	4	750	18 K	T03	MJ 3000	2 N 3715
2 N 6058	Si	NPN	150	12	80	4	750	18 K	T03	MJ 3001	2 N 3716
2 N 6059	Si	NPN	150	12	100	4	750	18 K	T03		MJ 4035
2 N 6060	Si	NPN	150	60	100	10	20	120	T063	2 N 6062	2 N 6278
2 N 6061	Si	PNP	150	60	100	20	20	120	T063	2 N 6063	2 N 6381
2 N 6062	Si	NPN	150	60	100	10	20	120	T063	2 N 6060	2 N 6278
2 N 6063	Si	PNP	150	60	100	20	20	120	T063	2 N 6061	2 N 6381
2 N 6064	Ge	PNP	56	10	80		20	50	R157	2 N 2289	2 N 2526
2 N 6065	Ge	PNP	56	10	120		20	50	R157	2 N 2290	2 N 2527
2 N 6066	Ge	PNP	56	10	160		20	50	R157	2 N 5324	2 N 2528
2 N 6067	Si	PNP	0,625	0,100	40	150	40		T092	TIS 91	BSV 44 A
2 N 6076	Si	PNP	0,360	0,100	25		100		T098	2 N 4126	MPS 6519
2 N 6077	Si	NPN	25	7	300	1	12	70	T066	MJE 52	2 N 6498
2 N 6078	Si	NPN	25	7	275	1	12	70	T066	2 SD 351	185 T 2 B
2 N 6079	Si	NPN	25	7	375	1	12	50	T066	2 N 5805	BU 326
2 N 6080	Si	NPN	12	1	18		5		T72	2 N 5645	SD 1095
2 N 6081	Si	NPN	31	2,5	18		5		T72	2 N 5590	BLY 88 A
2 N 6082	Si	NPN	50	4	18	130/175	6,2		T72	MRF 222	2 N 6083
2 N 6083	Si	NPN	65	4	18	130/175	5,7		T72	MRF 222	MRF 223
2 N 6084	Si	NPN	80	6	18	130/175	4,5		T72	BLW 60	HEPS 3009
2 N 6085 d)	Si	NPN	0,300	0,030	45	60	60		T078	2 N 6087	2 N 2913
2 N 6086 d)	Si	NPN	0,300	0,030	45	60	150		T078	2 N 6088	2 N 2914
2 N 6087 d)	Si	NPN	0,300	0,030	45	60	60		T078	2 N 6085	2 N 2915
2 N 6088 d)	Si	NPN	0,300	0,030	45	60	150		T078	2 N 6086	2 N 2916
2 N 6089 d)	Si	NPN	0,300	0,030	45	60	60		T078	2 N 6087	2 N 2917
2 N 6090 d)	Si	NPN	0,300	0,030	45	60	150		T078	2 N 6088	2 N 2918
2 N 6091 d)	Si	NPN	0,300	0,030	60	60	60		T078	2 N 6092	2 N 2919

2) transistors unijonction c) avec 2 N 6126 complémentaires des 3 précédents : 45, 60, 80 V

Pc = Puissance collecteur max.

Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium

• Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 N 6126 c)	Si	PNP	40	4	80	2,5	20	80	TO220	2 N 5195	BD 590
2 N 6127	Si	PNP	67	10	80	40	30	120	TO61	2 N 5853	2 N 5854
2 N 6128	Si	NPN	67	10	80	50	30	120	TO61	BD 709	2 N 6217
2 N 6129	Si	NPN	50	7	40	2,5	20	100	TO220	RCA 1 C 14	2 N 5495
2 N 6130	Si	NPN	50	7	60	2,5	20	100	TO220	2 N 5492	2 N 5493
2 N 6131	Si	NPN	50	7	80	2,5	20	100	TO220	2 N 5496	2 N 5497
2 N 6132 c)	Si	PNP	50	7	40	2,5	20	100	TO220	RCA 1 C 11	BD 596
2 N 6133 c)	Si	PNP	50	7	60	2,5	20	100	TO220	BD 598	MJ 6700
2 N 6134 c)	Si	PNP	50	7	80	2,5	20	100	TO220	BD 600	MJ 6701
2 N 6135	Si	NPN	2,5	0,250	25	1,1 GHz	25	300	T102	sans cause boîtier spécial	sans
2 N 6136	Si	NPN	60	6	18		20		T93	MRF 449 A	
2 N 6137 2)	Si	PNP	0,400	2 μ A (Ip) 50 μ A (Iv)					TO18	2 N 6138	2 N 6117 ou
2 N 6138 2)	Si	PNP	0,400	2 μ A (Ip) 50 μ A (Iv)					TO18	2 N 6137	2 N 6118
2 N 6166	Si	NPN	117	9	35		5		W52		2 N 5942
2 N 6175	Si	NPN	20	1	250	21	30		B24	BD 127	MJE 340
2 N 6176	Si	NPN	20	1	300	21	30		B24	BD 128	MJE 341
2 N 6177	Si	NPN	20	1	350	21	30		B24	BD 129	MJE 344
2 N 6178	Si	NPN	10	2	100	50	30	130	B24	2 N 6417	BD 443
2 N 6179	Si	NPN	10	2	75	50	40	250	B24	BD 139-6	2 N 6409
2 N 6180	Si	PNP	10	2	100	50	30	130	B24	BD 140-6	RCP 702 D
2 N 6181	Si	PNP	10	2	75	50	40	250	B24	2 N 6407	RCP 700 C
2 N 6182	Si	PNP	60	10	80	30	30	120	TO59	2 N 6186	MJE 34 B
2 N 6183	Si	PNP	60	10	80	30	60	240	TO59	2 N 6187	MJE 34 B
2 N 6184	Si	PNP	60	10	100	30	30	120	TO59	2 N 6188	MJE 34 C
2 N 6185	Si	PNP	60	10	100	30	60	240	TO59	2 N 6189	MJE 34 C
2 N 6186	Si	PNP	60	10	80	30	30	120	TO59	2 N 6182	MJE 34 B
2 N 6187	Si	PNP	60	10	80	30	60	240	TO59	2 N 6183	MJE 34 B
2 N 6188	Si	PNP	60	10	100	30	30	120	TO59	2 N 6184	MJE 34 C
2 N 6189	Si	PNP	60	10	100	30	60	240	TO59	2 N 6185	MJE 34 C
2 N 6190	Si	PNP	10	5	80	30	30	120	TO39	2 N 6191	MJ 8101
2 N 6191	Si	PNP	10	5	80	30	60	240	TO39	2 N 6190	MJ 8101
2 N 6192	Si	PNP	10	5	100	30	30	120	TO39	2 N 6193	HEPS 3003
2 N 6193	Si	PNP	10	5	100	30	60	240	TO39	2 N 6192	HEPS 3003

complémentaires des 3 précédents : 40, 60, 80 V

2) transistors unijonction

TRANSISTORS

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6197	Si	NPN	10	1	35				T91	2 N 6202	C3-28
2 N 6198	Si	NPN	25	2,5	35				T91	B12-28	2 SC 1414
2 N 6199	Si	NPN	50	5	35				T91	B 25-28	
2 N 6200	Si	NPN	85	8,5	35				T91	B 40-28	2 N 6205
2 N 6201	Si	NPN	140	12	35				T92	2 N 5862	2 N 6439
2 N 6202	Si	NPN	10	0,500	33				T91	2 N 6197	B 3-28
2 N 6203	Si	NPN	20	1	33				T91	C 12-28	A 3-28
2 N 6204	Si	NPN	40	2	33				T91	C 25-28	MRF 305
2 N 6205	Si	NPN	80	4	33				T91	C 40-28	MRF 306
2 N 6206	Si	NPN	10	0,500	30				T93	D 3-28	RF 410
2 N 6207	Si	NPN	20	1	30				T93	D 10-28	RF 404
2 N 6208	Si	NPN	40	2	30				T93	D 20-28	
2 N 6211	Si	PNP	20	2	275	20	10	100	TO66	JAN 2 N 6211	
2 N 6212	Si	PNP	20	2	350	20	10	100	TO66	BUX 66 C	JAN 2 N 6212
2 N 6213	Si	PNP	20	2	400	20	10	100	TO66	JAN 2 N 6213	2 SA 739
2 N 6214	Si	PNP	20	2	450	20	10	100	TO66	TRSP 4299	
2 N 6215	Si	NPN	125	50	80	20	25	150	TO63		ESM 6032
2 N 6216	Si	NPN	71	10	150	20	20	80	TO3	SDT 7736	SDT 7766
2 N 6217	Si	NPN	71	10	80	20	20	80	TO3	SDT 7733	SDT 7765
2 N 6218	Si	NPN	0,500	0,050	300	1 GHz	20		R207	sans	sans
2 N 6219	Si	NPN	0,500	0,050	250	1 GHz	20		R207	sans	sans
2 N 6220	Si	NPN	0,500	0,050	200	1 GHz	20		R207	sans	sans
2 N 6221	Si	NPN	0,500	0,050	150	1 GHz	20		R207	sans	sans
2 N 6222	Si	NPN	0,360	0,100	60		75		R207	2 N 6224	2 N 2483
2 N 6223 c)	Si	PNP	0,360	0,100	60		75		R207	2 N 6225	BC 325
2 N 6224	Si	NPN	0,360	0,100	60		150		R207	2 N 6222	2 N 2484
2 N 6225 c)	Si	PNP	0,360	0,100	60		150		R207	2 N 6223	BC 326
2 N 6226	Si	PNP	150	6	100		25	100	F4	TIP 544	
2 N 6227	Si	PNP	150	6	120		20	80	F4	TIP 545	
2 N 6228	Si	PNP	150	6	140		15	60	F4	TIP 546	
2 N 6229	Si	PNP	150	10	100		25	100	TO3	2 SA 753	2 N 6052
2 N 6230	Si	PNP	150	10	120		20	80	TO3	2 N 6248	2 SA 753
2 N 6231	Si	PNP	150	10	140		15	60	TO3	BDX 20	TIP 519

c) complémentaire du précédent

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6232	Si	NPN	15	10	100	30	40	250	T05		2 N 6232-4
2 N 6232-4	Si	NPN	15	10	100	30	40	250	T32	6232-4	
2 N 6233	Si	NPN	50	5	225	20	25	125	T066		KSP 1092
2 N 6234	Si	NPN	50	5	275	20	25	125	T066		KSP 1094
2 N 6235	Si	NPN	50	5	325	20	25	125	T066		BU 106
2 N 6246	Si	PNP	125	15	70	10	20	100	T03	BDW 52 A	TIP 2955
2 N 6247	Si	PNP	125	15	90	10	20	100	T03	BDW 52 B	BD 546 B
2 N 6248	Si	PNP	125	10	110	10	20	100	T03	2 SA 753	BDW 52 C
2 N 6249	Si	NPN	100	10	225	2,5	10	50	T03	2 N 6573	BUX 17 A
2 N 6250	Si	NPN	100	10	300	2,5	8	50	T03	2 N 6575	BUX 17 B
2 N 6251	Si	NPN	100	10	375	2,5	6	50	T03	BUX 80	BUX 17 C
2 N 6253	Si	NPN	115	15	45		20	150	T03	MJ 2801	BD 545
2 N 6254	Si	NPN	150	15	80		20	70	T03	2 N 6359	2 N 5970
2 N 6255	Si	NPN	5	1	18		5		T039	2 N 5422	MRF 207
2 N 6256	Si	NPN	2	0,400	16		20	200	W53	MRF 628	
2 N 6257	Si	NPN	150	20	40		15	75	T03		BDX 41
2 N 6258	Si	NPN	250	30	80		15	60	F11	2 N 4002	TO 8 T 2
2 N 6259	Si	NPN	250	16	150	30	30	120	T03		2 N 1818
2 N 6260	Si	NPN	29	3	40	0,030	20	100	T066	2 N 4231	RCS 29
2 N 6261	Si	NPN	50	4	80	0,030	25	100	T066	2 N 5192	BD 589
2 N 6262	Si	NPN	150	10	150		20	70	T03	2 N 5634	BUX 17
2 N 6263	Si	NPN	20	3	120	2	20	100	T066	BDY 72	BDY 79
2 N 6264	Si	NPN	50	3	150	2	20	60	T066		2 N 3441
2 N 6265	Si	NPN	6,2	0,275	50				X111	2 N 6268	
2 N 6266	Si	NPN	14	1	50				X111	2 N 6267	
2 N 6267	Si	NPN	21	1,5	50				X111	2 N 6266	
2 N 6268	Si	NPN	6,2	0,350	45				X111	2 N 6265	
2 N 6269	Si	NPN	21	1,5	45				X111	2 N 6267	
2 N 6270	Si	NPN	150	30	80	75	20	100	T03	2 N 6272	MJ 802
2 N 6271	Si	NPN	150	30	100	75	20	100	T03	2 N 6273	MJ 802
2 N 6272	Si	NPN	150	30	80	75	20	100	T063	2 N 6270	MJ 802
2 N 6273	Si	NPN	150	30	100	75	20	100	T063	2 N 6271	MJ 802
2 N 6274	Si	NPN	250	50	100	30	30	120	F11 ou T03	JAN 2 N 6274	2 N 6278

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 N 6275	Si	NPN	250	50	120	30	30	120	F11 ou T03	BUX 20	2 N 6279
2 N 6276	Si	NPN	250	50	140	30	30	120	F11 ou T03		2 N 6280
2 N 6277	Si	NPN	250	50	150	30	30	120	F11 ou T03		2 N 6281
2 N 6278	Si	NPN	250	50	100	30	30	120	T063		2 N 6274
2 N 6279	Si	NPN	250	50	120	30	30	120	T063	2 N 5926	2 N 6275
2 N 6280	Si	NPN	250	50	140	30	30	120	T063		2 N 6276
2 N 6281	Si	NPN	250	50	150	30	30	120	T063		2 N 6277
2 N 6282	Si	NPN	160	20	60	4	10	750	F11 ou T03	MJ 3 772	BDX 40
2 N 6283	Si	NPN	160	20	80	4	10	750	F11 ou T03	2 N 5303	2 N 3237
2 N 6284	Si	NPN	160	20	100	4	10	750	F11 ou T03	2 N 6338	SDT 8765
2 N 6285 c)	Si	PNP	160	20	60	4	10	750	F11 ou T03	2 N 5879	MJ 2955
2 N 6286 c)	Si	PNP	160	20	80	4	10	750	F11 ou T03	2 N 5745	2 N 5880
2 N 6287 c)	Si	PNP	160	20	100	4	10	750	F11 ou T03	2 N 5958	2 N 5678
2 N 6288	Si	NPN	16	7	40	0,050	30	150	T0220	2 N 6289	RCA 41
2 N 6289	Si	NPN	16	7	40	0,050	30	150	T0220	2 N 6288	RCA 41
2 N 6290	Si	NPN	16	7	60	0,050	30	150	T0220	2 N 6291	RCA 41 A
2 N 6291	Si	NPN	16	7	60	0,050	30	150	T0220	2 N 6290	RCA 41 A
2 N 6292	Si	NPN	16	7	80	0,050	30	150	T0220	2 N 6293	RCA 41 B
2 N 6293	Si	NPN	16	7	80	0,050	30	150	T0220	2 N 6292	RCA 41 B
2 N 6294 4)	Si	NPN	50	4	60	4	750	18K	T066	BD 677	BD 677 A
2 N 6295 4)	Si	NPN	50	4	80	4	750	18K	T066	BD 679	BD 679 A
2 N 6296 c) 4)	Si	PNP	50	4	60	4	750	18K	T066	BD 678	BD 678 A
2 N 6297 c) 4)	Si	PNP	50	4	80	4	750	18K	T066	BD 680	BD 680 A
2 N 6298 c) 4)	Si	PNP	75	8	60	4	750	18K	T066	MJ 900	BDX 62
2 N 6299 c) 4)	Si	PNP	75	8	80	4	750	18K	T066	MJ 901	BDX 62 A
2 N 6300	Si	NPN	75	8	60	4	750	18K	T066	MJ 1000	BDX 63
2 N 6301	Si	NPN	75	8	80	4	750	18K	T066	MJ 1001	BDX 63 A
2 N 6302	Si	NPN	150	16	120		15	60	T03	BDY 77	MJ 6302
2 N 6303	Si	PNP	1	3	80	60	30	150	T05	D 43 C 11	D 43 C 12
2 N 6304	Si	NPN	0,200	0,050	15	1,4 GHz	25		T072	2 N 3570	2 N 5054
2 N 6305	Si	NPN	0,200	0,050	15	1,2 GHz	25		T072	2 N 3571	2 N 3880
2 N 6306	Si	NPN	125	8	250	5	15	75	T03	JAN 2 N 6306	RCA 1 B 05
2 N 6307	Si	NPN	125	8	300	5	15	75	T03	411	2 N 5389

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6308	Si	NPN	125	8	350	5	12	60	TO3	413	2 N 6588
2 N 6312	Si	PNP	75	5	40	4	25	100	TO66	2 N 3183	MJE 5974
2 N 6313	Si	PNP	75	5	60	4	25	100	TO66	2 N 3184	MJE 5975
2 N 6314	Si	PNP	75	5	80	4	25	100	TO66	2 N 3185	MJE 5976
2 N 6315	Si	NPN	90	7	60	4	20	100	TO66	2 N 5873	RCA 41 A
2 N 6316	Si	NPN	90	7	80	4	20	100	TO66	2 N 5874	RCA 41 B
2 N 6317 c)	Si	PNP	90	7	60	4	20	100	TO66	2 N 5871	RCA 42 A
2 N 6318 c)	Si	PNP	90	7	80	4	20	100	TO66	2 N 5872	RCA 42 B
2 N 6322	Si	NPN	200	30	200	10	40	150	TO3	2 N 2760	2 N 2772
2 N 6323	Si	NPN	200	30	300	10	30	150	TO3	2 N 2762	2 N 2774
2 N 6324	Si	NPN	200	30	200	10	40	150	TO63	2 N 2766	2 N 2778
2 N 6325	Si	NPN	200	30	300	10	30	150	TO63	2 N 2768	2 N 2780
2 N 6326	Si	NPN	114	30	60	3	6	30	TO3	2 N 5932	SDT 8303
2 N 6327	Si	NPN	114	30	80	3	6	30	TO3	2 N 5734	BDY 57
2 N 6328	Si	NPN	114	30	100	3	6	30	TO3	BUY 53 A	MJ 802
2 N 6329 c)	Si	PNP	114	30	60	3	6	30	TO3	2 N 5883	TIP 36 A
2 N 6330 c)	Si	PNP	114	30	80	3	6	30	TO3	2 N 5884	TIP 36 B
2 N 6331 c)	Si	PNP	114	30	100	3	6	30	TO3	2 N 5967	TIP 36 C
2 N 6338	Si	NPN	200	25	100	40	30	120	TO3	JAN 2 N 6338	TIP 35 C
2 N 6339	Si	NPN	200	25	120	40	30	120	TO3		2 N 5560
2 N 6340	Si	NPN	200	25	140	40	30	120	TO3	2 N 6341	2 N 2132
2 N 6341	Si	NPN	200	25	150	40	30	120	TO3	JAN 2 N 6341	2 N 2132
2 N 6350 4)	Si	NPN	5	5	80	50	2K	10K	TO33	JAN 2 N 6350	U 2 T 101
2 N 6351 4)	Si	NPN	5	10	150	50	1K	10K	TO33	JAN 2 N 6351	U 2 T 105
2 N 6352 4)	Si	NPN	25	5	80	50	2K	10K	F24	JAN 2 N 6352	U 2 T 201
2 N 6353 4)	Si	NPN	25	10	150	50	1K	10K	F24	JAN 2 N 6353	U 2 T 205
2 N 6354	Si	NPN	80	10	130	80	20	150	TO3	2 N 6496	BUY 55-10
2 N 6355 4)	Si	NPN	150	20	40		500	5K	TO3	2 N 6356	
2 N 6356 4)	Si	NPN	150	20	40		1,5K	10K	TO3	2 N 6355	
2 N 6357 4)	Si	NPN	150	20	60		500	5K	TO3	2 N 6358	
2 N 6358 4)	Si	NPN	150	20	60		1,5K	10K	TO3	2 N 6357	
2 N 6359	Si	NPN	150	16	80		15	60	TO3	2 N 6254	2 N 5970
2 N 6360	Si	NPN	150	12	100		15	60	TO3	2 N 5632	2 N 1900

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	N a t u r e	P o l a r i t é	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6361	Si	NPN	50	4	33				X123	sans	sans
2 N 6362	Si	NPN	110	6	22				W55		2 SC 1512
2 N 6363	Si	NPN	175	10	33				X123	2 N 6364	
2 N 6364	Si	NPN	175	10	33				X123	2 N 6363	
2 N 6365	Ge	PNP	0,150	1	10	200	20		T018	2 N 2402	2 N 2401
2 N 6366	Si	NPN	10	1	18	50	5	50	T0102	2 N 5846	2 N 5703
2 N 6367	Si	NPN	20	2	18	50	5	50	W52	2 N 6370	2 N 5847
2 N 6368	Si	NPN	140	8	20	50	10		W52	MRF 420	MRF 452
2 N 6369	Si	NPN	220	15	35				W55	2 N 6572	BM 70-12
2 N 6370	Si	NPN	20	1,5	35	50	5	50	W52	2 N 6367	2 N 5483
2 N 6371	Si	NPN	66	16	50		15	60	T03	BD 213-45	BDS 45 A
2 N 6372	Si	NPN	22	6	90	4	20	100	T066	2 N 6292	2 N 6293
2 N 6373	Si	NPN	22	6	70	4	20	100	T066	2 N 6290	2 N 6291
2 N 6374	Si	NPN	22	6	50	4	20	100	T066	2 N 6289	2 N 6288
2 N 6375	Si	NPN	0,580	1,5	40	300	60		T018	BSS 27	BSX 32
2 N 6376	Si	NPN	1	1,5	40	300	30	90	R169	2 N 5859	2 N 3253
2 N 6377	Si	PNP	250	50	80	25	30	120	T063	2 N 6380	2 N 5684
2 N 6378	Si	PNP	250	50	100	25	30	120	T063	2 N 6381	2 N 6061
2 N 6379	Si	PNP	250	50	120	25	30	120	T063	2 N 6382	JAN 2 N 6379
2 N 6380	Si	PNP	250	50	80	25	30	120	T063	2 N 6377	2 N 5684
2 N 6381	Si	PNP	250	50	100	25	30	120	T063	2 N 6378	2 N 6063
2 N 6382	Si	PNP	250	50	120	25	30	120	T063	2 N 6379	JAN 2 N 6379
2 N 6383 4)	Si	NPN	100	10	40	20	1K	20K	T03	BDX 83	SDM 20321
2 N 6384 4)	Si	NPN	100	10	60	20	1K	20K	T03	ESM 161	ESM 261
2 N 6385 4)	Si	NPN	100	10	80	20	1K	20K	T03	ESM 162	ESM 262
2 N 6386 4)	Si	NPN	60	8	40	20	1K	20K	T0220	BDX 85	SDM 20301
2 N 6387 4)	Si	NPN	60	10	60	20	1K	20K	T0220	BDX 85 A	RCA 8350 A
2 N 6388 4)	Si	NPN	60	10	80	20	1K	20K	T0220	BDX 85 B	2 SD 411
2 N 6389	Si	NPN	0,200	0,040	12	1GHz	25		T072	2 N 3683	2 N 6305
2 N 6390	Si	NPN	8,3	1	50		20	120	W24	MSC 2003	2 SC 1799
2 N 6391	Si	NPN	16	2,5	50		20	120	W24	2 SC 1800	B 5-8 Z
2 N 6406	Si	PNP	12	2	60	50	50	250	B16	BD 229	BC 461
2 N 6407	Si	PNP	12	2	80	50	50	250	B16	BD 231	BCX 60

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

*Ge = Germanium
 *Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6408 c)	Si	NPN	12	2	60	50	50	250	B16	BD 235	BD 137
2 N 6409 c)	Si	NPN	12	2	80	50	50	250	B16	BD 237	BD 139
2 N 6410	Si	NPN	15	4	25	50	45	180	B16	MJE 200	KS 6114
2 N 6411	Si	PNP	15	4	25	50	40	250	B16	MJE 210	BD 362 A
2 N 6412	Si	NPN	15	4	40	50	40	250	B16	MJE 220	MJE 221
2 N 6413 c)	Si	NPN	15	4	60	50	40	250	B16	BDX 36	BDX 36
2 N 6414 c)	Si	PNP	15	4	40	50	40	250	B16	MJE 230	MJE 231
2 N 6415 c)	Si	PNP	15	4	60	50	40	250	B16	MJE 233	MJE 234
2 N 6416	Si	NPN	15	3	80	40	40	250	B16	BDX 37	MJE 240
2 N 6417	Si	NPN	15	3	100	40	40	250	B16	MJE 243	MJE 244
2 N 6418 c)	Si	PNP	15	3	80	40	40	250	B16	MJE 250	MJE 251
2 N 6419 c)	Si	PNP	15	3	100	40	40	250	B16	MJE 253	MJE 254
2 N 6420	Si	PNP	35	1	175	10	40	200	T066	MJE 3583	RCA 1 E 03
2 N 6421	Si	PNP	35	2	250	10	8	80	T066	MJE 3584	BUX 66 A
2 N 6422	Si	PNP	35	2	300	10	8	80	T066	MJE 3585	BUX 66 B
2 N 6423	Si	PNP	35	2	300	15	10	100	T066	MJ 4240	BUX 66 B
2 N 6424	Si	PNP	20	0,250	225	10	40	200	T066	MJ 3738	JAN 2 N 6211
2 N 6425	Si	PNP	20	0,250	300	10	40	200	T066	MJ 3739	JAN 2 N 6212
2 N 6426 4)	Si	NPN	0,625	0,500	40	130	10K	100K	T092	2 N 6427	2 SCI 280 AS
2 N 6427 4)	Si	NPN	0,625	0,500	40	150	20K	200K	T092	2 N 6426	2 SCI 280 AS
2 N 6436	Si	PNP	200	25	80	40	10	20	T03	2 N 5884	2 N 6330
2 N 6437	Si	PNP	200	25	100	40	10	20	T03	JAN 2 N 6437	JAN 2 N 6438
2 N 6438	Si	PNP	200	25	120	40	10	20	T03		2 N 6437
2 N 6439	Si	NPN	140		33	160			W55		MRF 306
2 N 6441 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	60		T078	2 N 6443	2 N 6445
2 N 6442 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	120		T078	2 N 6444	2 N 6446
2 N 6443 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	60		T078	2 N 6445	2 N 6447
2 N 6444 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	120		T078	2 N 6446	2 N 6448
2 N 6445 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	60		T078	2 N 6447	2 N 6441
2 N 6446 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	120		T078	2 N 6448	2 N 6442
2 N 6447 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	60		T078	2 N 6441	2 N 6443
2 N 6448 d)	Si	NPN	0,550	0,010	45	160	120		T078	2 N 6442	2 N 6444
2 N 6449 3)	Si	CaIn	0,800	0,010 (I _g)30 (V _{ds})			gfs 0,5	(mhos) 3	T039	2 N 6450	A 5 T 6449

c) complémentaire du groupe précédent 3) transistor FET 4) transistors DARLINGTON d) transistors doubles

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	N a t u r e	P o l a r i t é	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de joïtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6450 ³⁾	Si	CaIN	0,800	0,010	(I _g) 30 (Vds)		gfs 0,5	(mhos) 3	T039	2 N 6449	A 5 T 6450
2 N 6451	Si	CaIN	0,360	0,010	(I _g) 10 (Vds)		15	30	T072	2 N 6452	BF 353
2 N 6452	Si	CaIN	0,360	0,010	(I _g) 10 (Vds)		15	30	T072	2 N 6451	BF 353
2 N 6453	Si	CaIN	0,360	0,010	(I _g) 10 (Vds)		20	40	T072	2 N 6454	BF 351
2 N 6454	Si	CaIN	0,360	0,010	(I _g) 10 (Vds)		20	40	T072	2 N 6453	BF 351
2 N 6455	Si	NPN	60	7	25	75	10	80	T111	2 N 6458	2 N 6456
2 N 6456	Si	NPN	75	12	25	60	10	80	T111		2 N 6459
2 N 6457	Si	NPN	140	20	25	50	10	80	T109		2 N 6460
2 N 6458	Si	NPN	75	7	25	75	10	80	W52	2 N 6455	2 N 6456
2 N 6459	Si	NPN	120	12	25	60	10	80	W52		2 N 6456
2 N 6460	Si	NPN	140	20	25	50	10	80	W52		2 N 6457
2 N 6461	Si	NPN	1	0,100	300	200	30	120	T039	2 N 6462	BF 259
2 N 6462	Si	NPN	1	0,100	300	200	100	300	T039	2 N 6461	BF 259
2 N 6463	Si	NPN	1	0,100	250	200	30	120	T039	2 N 6464	BF 258
2 N 6464	Si	NPN	1	0,100	250	200	100	300	T039	2 N 6463	BF 258
2 N 6465	Si	NPN	23	4	110	5	15	150	T066	2 N 6473	2 N 6500
2 N 6466	Si	NPN	23	4	130	5	15	150	T066	2 N 6474	BDY 79
2 N 6467 ^{c)}	Si	PNP	23	4	110	5	15	150	T066	2 N 6475	BD 592
2 N 6468 ^{c)}	Si	PNP	23	4	130	5	15	150	T066	2 N 6476	
2 N 6469	Si	PNP	71	15	50	10	20	150	T03	TIP 2955	BDW 52 A
2 N 6470	Si	NPN	71	15	50	5	20	150	T03	2 N 6371	SDT 9802
2 N 6471	Si	NPN	71	15	70	5	20	150	T03	2 N 5971	2 N 5970
2 N 6472	Si	NPN	71	15	90	5	20	150	T03	2 N 5972	2 N 5970
2 N 6473	Si	NPN	16	4	110	4	15	150	T0220	2 N 6465	2 N 6500
2 N 6474	Si	NPN	16	4	130	4	15	150	T0220	2 N 6466	BDY 79
2 N 6475	Si	PNP	16	4	110	10	15	150	T0220	2 N 6467	BD 792
2 N 6476	Si	PNP	16	4	130	10	15	150	T0220	2 N 6468	
2 N 6477	Si	NPN	20	2,5	140		25	150	T0220	RCA 3441	2 SD 578
2 N 6478	Si	NPN	20	2,5	160		25	150	T0220	2 SD 477	2 SD 578 A
2 N 6479	Si	NPN	50	12	60	100	20	300	W41	2 N 6481	2 N 3264
2 N 6480	Si	NPN	50	12	80	100	20	300	W41	2 N 6482	2 N 3263
2 N 6481	Si	NPN	67	12	60	100	20	300	W41	2 N 6479	2 N 3264
2 N 6482	Si	NPN	67	12	80	100	20	300	W41	2 N 6480	2 N 3263

• Pc = Puissance collecteur max.
 • Ic = Courant collecteur max.
 • Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 • Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6483 ^{3d)}	Si	CaIN	0,250		20 (Vds)		gfs 1	(mhos) 4	T071	2 N 6484	2 N 5561
2 N 6484 ^{3d)}	Si	CaIN	0,250		20 (Vds)		1	4	T071	2 N 6485	2 N 5562
2 N 6485 ^{3d)}	Si	CaIN	0,250		20 (Vds)		1	4	T071	2 N 6483	2 N 5563
2 N 6486	Si	NPN	30	15	50	5	20	150	T0220	2 N 6371	2 N 3667
2 N 6487	Si	NPN	30	15	70	5	20	150	T0220	BD 545 B	2 N 3055
2 N 6488	Si	NPN	30	15	90	5	20	150	T0220	RCA 1801	BD 545 B
2 N 6489 ^{c)}	Si	PNP	30	15	50	5	20	150	T0220	BD 546 A	BD 546
2 N 6490 ^{c)}	Si	PNP	30	15	70	5	20	150	T0220	BD 546 B	BD 316
2 N 6491 ^{c)}	Si	PNP	30	15	90	5	20	150	T0220	BD 546 C	BD 318
2 N 6495	Si	NPN	70	10	80	25	10	60	T066	2 N 2813	2 N 2814
2 N 6496	Si	NPN	80	15	130	60	12	100	T03	2 SD 287 A	2 N 6354
2 N 6497	Si	NPN	80	5	250	5	10	75	B23	MJE 51	BU 126 A
2 N 6498	Si	NPN	80	5	300	5	10	75	B23	MJE 52	2 N 6542
2 N 6499	Si	NPN	80	5	350	5	10	75	B23	MJE 53	MJ 424
2 N 6500	Si	NPN	20	4	110	60	15	60	T066	2 N 6465	2 N 6473
2 N 6502	Si	NPN	0,600	1	40	250	10		R131	2 N 5845 A	TIS 136
2 N 6503	Si	NPN	0,350	1	40	250	10		X22	2 N 4408	MD 2219 AF
2 N 6510	Si	NPN	120	7	200	3	10	50	T03	BUX 18	RCA 410
2 N 6511	Si	NPN	120	7	250	3	10	50	T03	2 N 6306	RCS 579
2 N 6512	Si	NPN	120	7	300	3	10	50	T03	2 N 6307	RCA 411
2 N 6513	Si	NPN	120	7	350	3	10	50	T03	2 N 6308	BUX 18 B
2 N 6514	Si	NPN	120	7	300	3	10	50	T03	2 N 6344	MJ 7160
2 N 6515	Si	NPN	0,625	0,500	250	40	35		T092	BF 298	A 5 T 6463
2 N 6516	Si	NPN	0,625	0,500	300	40	30		T092	MPSA 42	BF 299
2 N 6517	Si	NPN	0,625	0,500	350	40	20		T092	TRS 350	UPT 015
2 N 6518 ^{c)}	Si	PNP	0,625	0,500	250	40	35		T092	BF 416	BF 423
2 N 6519 ^{c)}	Si	PNP	0,625	0,500	300	40	30		T092	BF 418	MPSA 92
2 N 6520 ^{c)}	Si	PNP	0,625	0,500	350	40	20		T092	MJ 4648	BFT 19 B
2 N 6521 ⁴⁾	Si	PNP	2	1	40	175	10K	25K	R176	2 N 6522	BD 466 B
2 N 6522 ⁴⁾	Si	PNP	2	1	40	175	20K	50K	R176	2 N 6521	BD 466 B
2 N 6523	Si	NPN	5	0,600	40		15		W24	2 N 6526	2 N 6527
2 N 6524	Si	NPN	10	1,2	40		15		W24	2 N 6528	
2 N 6525	Si	NPN	20	2,5	40		15		W24	2 N 6529	

d) transistors FET doubles — 4) transistors DARLINGTON c) complémentaires des groupes précédents

- P_c = Puissance collecteur max.
- I_c = Courant collecteur max.
- $V_{ce\ max}$ = Tension collecteur émetteur max.
- F_{max} = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	P_c (W)	I_c (A)	$V_{ce\ max.}$ (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus prochaine	Approximative
2 N 6526	Si	NPN	3,9	0,500	50		15		W24		2 N 6523
2 N 6527	Si	NPN	5	1	50		15		W24		2 N 6523
2 N 6528	Si	NPN	10	1,2	50		15		W24		2 N 6524
2 N 6529	Si	NPN	20	2,5	50		15		W24		2 N 6525
2 N 6530 4)	Si	NPN	26	8	80 (V_{cb})	20	100	5K	TO220	2 N 6534	RCA 121
2 N 6531 4)	Si	NPN	26	8	100 (V_{cb})	20	100	5K	TO220	2 N 6532	2 N 6535
2 N 6532 4)	Si	NPN	26	8	100 (V_{cb})	20	100	5K	TO220	2 N 6531	2 N 6536
2 N 6533 4)	Si	NPN	26	8	120 (V_{cb})	20	100	5K	TO220	2 N 6537	2 SCI 884 H
2 N 6534 4)	Si	NPN	14	8	80 (V_{cb})	20	100	5K	TO66	2 N 6530	RCA 121
2 N 6535 4)	Si	NPN	14	8	100 (V_{cb})	20	100	5K	TO66	2 N 6536	2 N 6531
2 N 6536 4)	Si	NPN	14	8	100 (V_{cb})	20	100	5K	TO66	2 N 6535	2 N 6532
2 N 6537 4)	Si	NPN	14	8	120 (V_{cb})	20	100	5K	TO66	2 N 6533	2 SCI 884 H
2 N 6538	Si	NPN	0,625	0,200	40	200	100		TO92	2 N 6539	TIS 94
2 N 6539	Si	NPN	0,625	0,200	40	200	250		TO92	2 N 6538	TIS 94
2 N 6540	Si	NPN	0,625	0,200	60	200	100		TO92	2 N 6541	TIS 95
2 N 6541	Si	NPN	0,625	0,200	65	200	60		TO92	2 N 6540	TIS 96
2 N 6542	Si	NPN	100	5	300	6	7	35	TO3	MJ 411	BUX 16 B
2 N 6543	Si	NPN	100	5	400	6	7	35	TO3	MJ 425	2 SD 273
2 N 6544	Si	NPN	125	8	300	6	7	35	TO3	2 N 6307	2 N 6575
2 N 6545	Si	NPN	125	8	400	6	7	35	TO3	2 N 6580	2 N 6583
2 N 6546	Si	NPN	175	15	300	6	6	30	TO3	MJ 7260	2 SC 1141
2 N 6547	Si	NPN	175	15	400	6	6	30	TO3	MJ 7261	2 SD 311
2 N 6548 4)	Si	NPN	2	2	40	100	15K	150K	TO202	2 N 6549	92 PU 45
2 N 6549 4)	Si	NPN	2	2	40	100	25K	150K	TO202	2 N 6548	92 PU 45
2 N 6550	Si	CaIN	0,400		10 (V_{ds})		$\frac{g_{fs}}{25}$	$\frac{(mhos)}{150}$	TO46	ESM 4446	2 N 4466
2 N 6551	Si	NPN	2	1	60	75	80	250	TO202	MJE 29 A	BC 342
2 N 6552	Si	NPN	2	1	80	75	80	250	TO202	MJE 29 B	BC 344
2 N 6553	Si	NPN	2	1	100	75	80	250	TO202	MJE 29 C	2 N 2201
2 N 6554	Si	PNP	2	1	60	75	80	300	TO202	MJE 30 A	BC 343
2 N 6555	Si	PNP	2	1	80	75	80	300	TO202	MJE 30 B	BC 345
2 N 6556	Si	PNP	2	1	100	75	80	300	TO202	MJE 30 C	BD 240 C
2 N 6557	Si	NPN	2	0,500	250	45	40	180	TO202	BD 127	MSP 25
2 N 6558	Si	NPN	2	0,500	300	45	40	180	TO202	BD 128	MSP 30

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 N 6559	Si	NPN	2	0,500	350	45	40	180	T0202	BD 129	2 N 5092
2 N 6560	Si	NPN	220	10	450	10	10	40	T03	2 N 6562	2 N 2583
2 N 6561	Si	NPN	220	10	300	15	10	50	T03	2 N 6563	2 N 1814
2 N 6562	Si	NPN	175	10	450	10	10	40	T061	2 N 6560	SDT 13204
2 N 6563	Si	NPN	175	10	300	15	10	50	T061	2 N 6561	MJ 9000
2 N 6566	Si	NPN	0,400	0,100	30	3	100		T046	D 32 S 1	BC 282
2 N 6567	Si	PNP	0,400	0,100	30	3	30		T046	2 N 3219	2 N 3527
2 N 6569	Si	NPN	100	12	40	1,5	15	200	T03	2 N 6594	BDW 51
2 N 6570	Si	NPN	250	40	90	1	20	60	T03	2 N 6571	2 N 5489
2 N 6571	Si	NPN	250	40	105	1	20	60	T03	2 N 6570	2 N 5489
2 N 6572	Si	NPN	250	12	30				W55		2 N 6369
2 N 6573	Si	NPN	125	10	250	5	7	21	T03	BUX 17 A	2 SC 1870
2 N 6574	Si	NPN	125	10	275	5	7	21	T03	DTS 518	IR 518
2 N 6575	Si	NPN	125	10	300	5	7	21	T03	2 SC 1143	TIP 562
2 N 6576 4)	Si	NPN	120	15	60	40	2K	20K	T03	BDX 65	
2 N 6577 4)	Si	NPN	120	15	90	40	2K	20K	T03	BDX 65 A	
2 N 6578 4)	Si	NPN	120	15	120	40	2K	20K	T03	BDX 65 C	
2 N 6579	Si	NPN	125	10	350	25	7	35	T03	2 N 6582	2 N 6585
2 N 6580	Si	NPN	125	10	400	25	7	35	T03	2 N 6583	2 N 6586
2 N 6581	Si	NPN	125	10	450	25	7	35	T03	2 N 6584	2 N 6587
2 N 6582	Si	NPN	125	10	350	25	7	35	T03	2 N 6579	2 N 6588
2 N 6583	Si	NPN	125	10	400	25	7	35	T03	2 N 6580	2 N 6589
2 N 6584	Si	NPN	125	10	450	25	7	35	T03	2 N 6581	2 N 6590
2 N 6585	Si	NPN	125	10	350	25	7	35	T061	2 N 6588	2 N 6579
2 N 6586	Si	NPN	125	10	400	25	7	35	T061	2 N 6589	2 N 6580
2 N 6587	Si	NPN	125	10	450	25	7	35	T061	2 N 6590	2 N 6581
2 N 6588	Si	NPN	125	10	350	25	7	35	T061	2 N 6585	2 N 6582
2 N 6589	Si	NPN	125	10	400	25	7	35	T061	2 N 6586	2 N 6583
2 N 6590	Si	NPN	125	10	450	25	7	35	T061	2 N 6587	2 N 6584
2 N 6591	Si	NPN	2	0,500	150	70	40	200	T0202	MSP 15	HEP 714
2 N 6592	Si	NPN	2	0,500	200	70	40	200	T0202	MSP 20	MST 20
2 N 6593	Si	NPN	2	0,500	250	70	30	200	T0202	MSP 25	2 N 6557
2 N 6594	Si	PNP	100	12	40	2,5	15	200	T03	2 N 6569	BDW 51

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 N 6595	Si	NPN	0,200	0,025	15	3,5 GHz	25		T072	2 N 6596	BFT 67
2 N 6596	Si	NPN	0,200	0,035	15	4 GHz	25		T072	BFT 66	BFT 67
2 N 6597	Si	NPN	0,200	0,025	12	3,5 GHz	25		T072	2 N 6598	MRF 914
2 N 6598	Si	NPN	0,200	0,035	12	4 GHz	25		T072	BFR 15 A	MRF 914
2 N 6599	Si	NPN	0,500	0,075	15	3 GHz	25		T072	A 406	
2 N 6600	Si	NPN	0,300	0,075	15	3,5 GHz	25		T072	BFS 55 A	
2 N 6601	Si	NPN	0,250	0,050	10	1 GHz	25		T072	BFW 30	2 N 4251
2 N 6602	Si	NPN	0,375	0,025	15	3,5 GHz	25		W29		MRF 901
2 N 6603	Si	NPN	0,400	0,030	15	1,5 GHz	30		W29	2 N 6602	MRF 902
2 N 6604	Si	NPN	0,500	0,050	15	1,5 GHz	30		W29	2 N 6603	MRF 912
2 N 6609	Si	PNP	150	16	140		5		T03	2 N 3773 (NPN)	apparié avec 2 N 6609 (PNP)
2 N 6648 4)	Si	PNP	70	10	40	BF		1000	T0204	BDX 33	RCA 8203
2 N 6649 4)	Si	PNP	70	10	60	et		1000	T0204	BDX 33 A	ESM 261
2 N 6650 4)	Si	PNP	70	10	80	MF		1000	T0204	BDX 33 B	TIP 131
2 NJ 242 E	Si	NPN	3,7	0,300	20		50		W86		2 NJ 243 E
2 NJ 243 E	Si	NPN	7,5	0,600	20		50		W86		2 NJ 242 E
2 NJ 244 B	Si	NPN	15	1,5	20		50		W86	2 NJ 244 E	
2 NJ 244 E	Si	NPN	15	1,5	20		50		W86	2 NJ 244 B	
2 NJ 245 B	Si	NPN	30	3	20		50		W86	sans	sans
TRANSISTORS DARLINGTON RÉCENTS											
BDX 62 C	Si	PNP	90	12	120	7	1K		T03	BDX 64 C	SDM 21314
BDX 63 C	Si	NPN	90	12	120	7	1K		T03	BDX 65 C	STI 1020
BDX 64 C	Si	PNP	117	12	120	7	1K		T03	BDX 66 C	
BDX 65 C	Si	NPN	117	12	120	7	1K		T03	BDX 67 C	2 N 6578
BDX 66 C	Si	PNP	150	12	120	7	1K		T03	sans	sans
BDX 67 C	Si	NPN	150	12	120	7	1K		T03	sans	sans
NE 5501	Si	NPN		0,500	90				16 broches	compatible DTL, TTL PMOS et CMOS compatible avec PMOS de 14 à 25 V compatible avec TTL ou CMOS sous 5 V compatible avec PMOS ou CMOS sous 6 et 15 V	
NE 5502	Si	NPN		0,500	90				16 broches		
NE 5503	Si	NPN		0,500	90				16 broches		
NE 5504	Si	NPN		0,500	90				16 broches		
RCS 683	Si	NPN	10	4	40	BF/MF	1K	moyen	T039		MJE 3310
RCS 683 A	Si	NPN	10	4	60	BF/MF	1K	moyen	T039		MJE 3311
RCS 683 B	Si	NPN	10	4	80	BF/MF	1K	moyen	T039		MJE 3312

Pc = Puissance collecteur max.

Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium

Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 73	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	35	19	65	T044	2 N 1742	2 N 1743
2 SA 74	Ge	PNP	0,120	0,005	50 (Vcb)	70		70	T044	2 SA 474	2 N 1226
2 SA 75	Ge	PNP	0,120	0,005	20 (Vcb)	30		70	T044	ASZ 21	2 N 2090
2 SA 76	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	130		65	T044	AF 139	AF 369
2 SA 77	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	110		65	T044	AF 139	AF 369
2 SA 78	Ge	PNP	0,125	0,400	40 (Vcb)	40		80	T044	2 N 1495	2 N 1495 A
2 SA 80	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	20		90	T044	2 SA 110	SK 3007
2 SA 81	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)			80	T044	AF 114	AF 117
2 SA 82	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)			85	T044	AF 114	AF 117
2 SA 83	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)			60	T044	2 N 3127	2 N 2717
2 SA 84	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)			80	T044	2 N 3127	2 N 2717
2 SA 85	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)			85	T044	2 N 3127	2 N 2717
2 SA 86	Ge	PNP	0,225	0,050	45 (Vcb)			80	T044	2 N 1377	2 N 1375
2 SA 92	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	50		70	T044	HEP 639	AF 125
2 SA 93	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	45		170	T044	AF 124	HEP 640
2 SA 94	Ge	PNP	0,080	0,001	9 (Vcb)			55	T044	2 N 975	GT 100
2 SA 101	Ge	PNP	0,060	0,010	40 (Vcb)	15		30	T01	2 N 1749	2 N 2496
2 SA 102	Ge	PNP	0,060	0,010	40 (Vcb)	25		40	T01	2 N 1749	2 N 987
2 SA 103	Ge	PNP	0,060	0,010	40 (Vcb)	35		50	T01	ASZ 20	2 N 1224
2 SA 104	Ge	PNP	0,060	0,010	40 (Vcb)	50		100	T01	2 N 1395	ASZ 20 N
2 SA 105	Ge	PNP	0,035	0,010	6 (Vcb)	75		50	T044	2 N 2451	2 N 1427
2 SA 106	Ge	PNP	0,035	0,010	6 (Vcb)	30		50	T044	2 N 393	2 N 1427
2 SA 107	Ge	PNP	0,035	0,010	6 (Vcb)	20		40	T044	2 N 393	2 N 1427
2 SA 108	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	14		70	T044	OC 170	OC 171
2 SA 109	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	30		60	T044	2 N 1524	2 N 1526
2 SA 110	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	30		60	T044	2 N 1524	2 N 1526
2 SA 111	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	20		40	T044	2 N 1524	2 N 1526
2 SA 112	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	2		45	T044	2 N 1524	2 N 1526
2 SA 113	Ge	PNP	0,050	0,010	34 (Vcb)	20		45	T044	2 N 504	AF 114
2 SA 114	Ge	PNP	0,050	0,010	34 (Vcb)	20		40	T044	2 N 504	AF 114
2 SA 115	Ge	PNP	0,050	0,010	34 (Vcb)	30		60	T044	2 N 504	AF 114
2 SA 116	Ge	PNP	0,050	0,010	30 (Vcb)	12		60	T044	2 N 499 A	AFY 41
2 SA 117	Ge	PNP	0,050	0,010	30 (Vcb)	110		40	T044	2 N 499 A	AFY 41

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 SA 118	Ge	PNP	0,050	0,010	30 (Vcb)	100		60	T044	2 N 499 A	AFY 41
2 SA 119	Si	PNP	0,650	0,300	40 (Vcb)	200		60	T039	2 SA 120 A	MPS 3905
2 SA 120	Si	PNP	0,650	0,300	25 (Vcb)	200		60	T039	BC 328-5	BC 328-18
2 SA 120A	Si	PNP	0,650	0,300	40 (Vcb)	200		60	T039	2 SA 119	MPS 3905
2 SA 121	Ge	PNP	0,015	0,002	15 (Vcb)	100	24		R14	2 N 1109	2 N 175
2 SA 122	Ge	PNP	0,015	0,002	15 (Vcb)	100	24		R14	2 N 1108	2 N 175
2 SA 123	Ge	PNP	0,015	0,002	15 (Vcb)	100	24		R14	2 N 1111	2 N 175
2 SA 124	Ge	PNP	0,015	0,002	15 (Vcb)	120	32		R14	2 N 1111 A	2 N 220
2 SA 125	Ge	PNP	0,015	0,002	15 (Vcb)	120	49		R14	2 N 1111 B	2 N 220
2 SA 126	Ge	PNP	0,150	0,050	15	300		40	T018	2 SA 405	2 N 972
2 SA 127	Ge	PNP	0,150	0,050	70 (Vcb)	25			T044	2 G 1025	2 G 1024
2 SA 128	Ge	PNP	0,170	0,500	40	15		35	T044	2 N 1495	2 N 1495 A
2 SA 129	Ge	PNP	0,170	0,500	40	15		70	T044	2 N 1495	2 N 1495 A
2 SA 130	Ge	PNP	0,080	0,010	9 (Vcb)			80	T044	2 N 2378	2 N 2280
2 SA 131	Ge	PNP	0,080	0,010	9 (Vcb)			50	T044	2 N 2378	2 N 2280
2 SA 132	Ge	PNP	0,080	0,010	9 (Vcb)			80	T044	2 N 2378	2 N 2280
2 SA 133	Ge	PNP	0,080	0,010	9 (Vcb)			50	T044	2 N 2378	2 N 2280
2 SA 136	Ge	PNP	0,080	0,010	6 (Vcb)	10		75	R18	OC 60	OC 58
2 SA 137	Ge	PNP	0,080	0,010	6 (Vcb)	5		50	R18	OC 58	OC 57
2 SA 138	Ge	PNP	0,080	0,025	20 (Vcb)	15		70	T01	AF 114	AF 117
2 SA 139	Ge	PNP	0,080	0,050	30 (Vcb)	8		70	T01	2 N 1526	2 N 1527
2 SA 141	Ge	PNP	0,080	0,015	15	8		70	T01	2 N 581	2 N 583
2 SA 142	Ge	PNP	0,080	0,015	15	8		70	T01	2 N 581	2 N 583
2 SA 142A	Ge	PNP	0,080	0,015	35	8		70	T01	2 N 1177	2 N 1179
2 SA 143	Ge	PNP	0,080	0,015	15	15		70	T01	2 N 581	2 N 583
2 SA 144	Ge	PNP	0,083	0,010	15	12		100	T01	OC 44	OC 43 N
2 SA 145	Ge	PNP	0,083	0,010	15	6		50	T01	OC 45	OC 44 N
2 SA 150	Ge	PNP	0,050	0,040	105	0,500		35	T05	2 N 398	2 N 1670
2 SA 151	Ge	PNP	0,080	0,015	9 (Vcb)			50	T05	2 N 2378	2 N 2280
2 SA 152	Ge	PNP	0,080	0,015	9 (Vcb)			60	T05	2 N 2378	2 N 2280
2 SA 156	Ge	PNP	0,020	0,004	15 (Vcb)	55		50	T01	2 N 1108 à	2 N 1110
2 SA 160	Ge	PNP	0,020	0,004	15 (Vcb)	55		60	T01	2 N 1108 à	2 N 1110
2 SA 161	Ge	PNP	0,050	0,015	20 (Vcb)	500	13		T018	AF 139	AF 339

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 162	Ge	PNP	0,050	0,015	20 (Vcb)	500		25	T018	AF 139	AF 339
2 SA 163	Ge	PNP	0,050	0,015	20 (Vcb)	500		66	T018	AF 139	AF 339
2 SA 164	Ge	PNP	0,050	0,015	20 (Vcb)	500		13	T018	AF 139	AF 339
2 SA 165	Ge	PNP	0,050	0,015	20 (Vcb)	500		25	T018	AF 139	AF 339
2 SA 166	Ge	PNP	0,050	0,015	20 (Vcb)	500		66	T018	AF 139	AF 339
2 SA 167	Ge	PNP	0,125	0,050	18	9		70	T05	2 N 1854	AF 188
2 SA 168	Ge	PNP	0,175	0,050	18	9		70	MM4	2 SA 168 A	
2 SA 168A	Ge	PNP	0,175	0,050	18	9		70	MM4	2 SA 168	
2 SA 172	Ge	PNP	0,175	0,200	20 (Vcb)	8		40	MM4		2 SA 168 ou A
2 SA 175	Ge	PNP	0,050	0,050	18 (Vcb)	85		65	T09	2 N 982	2 N 1158
2 SA 183	Ge	PNP	0,050	0,010	15 (Vcb)	16		30	T01	2 N 501	2 N 501 A
2 SA 188	Ge	PNP	0,080	0,015	12 (Vcb)	10		65	T01	2 N 411	2 N 412
2 SA 189	Ge	PNP	0,080	0,015	12 (Vcb)	6		65	T01	2 N 409	2 N 410
2 SA 201	Ge	PNP	0,100	0,015	15 (Vcb)	8		50	T01	2 N 487	2 N 522
2 SA 202	Ge	PNP	0,100	0,015	15 (Vcb)	12		55	T01	2 N 522	2 N 523
2 SA 203	Ge	PNP	0,100	0,015	15 (Vcb)	5		30	T01	2 N 487	2 N 522
2 SA 204	Ge	PNP	0,150	0,200	10	6		65	T05	2 N 1345	2 N 394
2 SA 205	Ge	PNP	0,200	0,200	15	5		45	T05	2 G 138	2 G 139
2 SA 206	Ge	PNP	0,200	0,200	20	7		60	T05	2 N 1317	OC 74
2 SA 207	Ge	PNP	0,200	0,200	15	12		70	T05	2 N 2225	2 G 141
2 SA 208	Ge	PNP	0,120	0,400	20 (Vcb)	3	15		T05	2 N 578	2 N 1319
2 SA 208H ^{5c}	Ge	PNP	0,120	T. recouv. 350 ns		3		40	T05	2 N 425	2 N 5325
2 SA 209	Ge	PNP	0,120	0,400	20 (Vcb)	5	30		T05	2 N 578	2 N 1319
2 SA 209H ^{5c}	Ge	PNP	0,120	T. recouv. 400 ns		5		65	T05	2 SC 658	2 N 1892
2 SA 210	Ge	PNP	0,120	0,400	20 (Vcb)	10	45		T05	2 N 603 A	2 N 604 A
2 SA 210H ^{5c}	Ge	PNP	0,120	T. recouv. 400 ns		10		100	T05	2 N 599	2 N 581
2 SA 211	Ge	PNP	0,120	0,100	12			70	T05	2 N 794	2 N 582
2 SA 212	Ge	PNP	0,120	0,100	25 (Vcb)	4	30		T05	2 N 2613	2 N 584
2 SA 212H ^{5c}	Ge	PNP	0,120	T. recouv. 320 ns		4		60	T05	2 N 2930	ASY 27
2 SA 217	Ge	PNP	0,120	0,100	25 (Vcb)	14	30		T05	2 N 582	2 N 584
2 SA 217 H ^{5c}	Ge	PNP	0,120	T. recouv. 320 ns		14		60	T05	2 N 404	2 N 1308
2 SA 218	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	25		48	T044	AF 115	AF 116
2 SA 219	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	40		50	T044	AF 115	AF 116

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 220	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	50		150	T044	AF 115	AF 116
2 SA 221	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	50		75	T044	2 N 1726	2 N 1864
2 SA 222	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	70		130	T044	AF 115	AF 116
2 SA 223	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	64		50	T044	2 N 1864	2 N 1726
2 SA 224	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	80		80	T044	2 N 1726	2 N 1864
2 SA 225	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	100			T044	AF 115	AF 116
2 SA 226	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	95		120	T044	AF 115	AF 116
2 SA 227	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	80			T044	AF 115	AF 116
2 SA 228	Ge	PNP	0,100	0,010	80 (Vcb)	30		70	T017		MA 205
2 SA 229	Ge	PNP	0,075	0,005	20 (Vcb)	2	0,9		T017	2 N 2089	2 N 2090
2 SA 230	Ge	PNP	0,075	0,005	20 (Vcb)		2		T044	2 N 2089	2 N 2090
2 SA 231	Ge	PNP	2	0,400	40 (Vcb)			60	T044		2 N 1123
2 SA 232	Ge	PNP	2	0,400	30 (Vcb)			90	T044	AFY 19	AC 152
2 SA 233	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	700		70	T044	AF 139	AF 239
2 SA 234	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	700		70	T044	AF 139	AF 239
2 SA 235	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	135		90	T044	AFZ 12	2 N 3127
2 SA 235H	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	125	30		T044	AFZ 12	2 N 3127
2 SA 236	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	35		45	T044	HEP 639	HEP 640
2 SA 237	Ge	PNP	0,055	0,005	18 (Vcb)	35		50	T044	HEP 639	HEP 640
2 SA 238	Ge	PNP	0,200	0,030	20	700		30	R24	2 N 1195	HEP 2
2 SA 239	Ge	PNP	0,075	0,005	20 (Vcb)	300		10	T017	2 SA 240	2 N 2996
2 SA 240	Ge	PNP	0,075	0,005	18	200		120	T017	2 SA 239	2 N 2996
2 SA 241	Ge	PNP	0,050	0,005	20	230		100	T07	2 SA 377	AFY 12
2 SA 244	Ge	PNP	0,200	0,030	20	600		30	R24	2 N 1195	HEP 2
2 SA 245	Ge	PNP	0,200	0,030	20	700		30	R24	2 N 1195	HEP 2
2 SA 246	Ge	PNP	0,100	0,030	30 (Vcb)	155		70	T044	2 N 3281	2 N 3282
2 SA 247	Ge	PNP	0,100	0,030	10			65	T044	2 N 976	2 G 101 ou 102
2 SA 248	Ge	PNP	0,125	0,200	40	25		50	T044	MEO 413	2 N 505
2 SA 251	Ge	PNP	0,050	0,050	6	50		50	R48	2 N 3322	2 N 3321
2 SA 252	Ge	PNP	0,050	0,050	6	80		150	R48	2 N 3321	2 N 3322
2 SA 254	Ge	PNP	0,055	0,010	12 (Vcb)	10		80	R18	2 N 1752	OC 44 N
2 SA 255	Ge	PNP	0,055	0,010	12 (Vcb)	5		50	R18	2 N 1752	OC 44 N
2 SA 256	Ge	PNP	0,055	0,010	20 (Vcb)	60		75	R18	AF 106	AF 306

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 257	Ge	PNP	0.055	0.010	20 (Vcb)	50		60	R18	2 N 1864	AF 106
2 SA 258	Ge	PNP	0.055	0.010	20 (Vcb)	40		45	R18	2 N 1864	AF 106
2 SA 259	Ge	PNP	0.055	0.010	20 (Vcb)	30		45	R18	2 N 1864	AF 106
2 SA 260	Ge	PNP	0.040	0.005	20 (Vcb)	200		10	T017	2 SA 420	2 N 502
2 SA 261	Ge	PNP	0.040	0.005	20 (Vcb)	400		10	T017	AF 239	AF 139
2 SA 262	Ge	PNP	0.040	0.005	20 (Vcb)	400		10	T017	AF 239	AF 139
2 SA 263	Ge	PNP	0.040	0.005	20 (Vcb)	400		10	T017	AF 239	AF 139
2 SA 264	Ge	PNP	0.040	0.005	20 (Vcb)	600		10	T017	AF 239	2 N 3320
2 SA 265	Ge	PNP	0.040	0.005	20 (Vcb)	600		10	T017	AF 239	2 N 3320
2 SA 266	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	60		75	T01	AFZ 12	AF 114 ou 117
2 SA 267	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	50		60	T01	AFZ 12	AF 114 ou 117
2 SA 268	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	40		45	T01	AFZ 12	AF 114 ou 117
2 SA 269	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	30		45	T01	AFZ 12	AF 114 ou 117
2 SA 270	Ge	PNP	0.080	0.010	9 (Vcb)	50		75	T01	2 N 967	GT 2887
2 SA 271	Ge	PNP	0.080	0.010	9 (Vcb)	30		60	T01	2 N 967	GT 2885
2 SA 272	Ge	PNP	0.080	0.010	9 (Vcb)	20		45	T01	2 N 967	GT 2883
2 SA 273	Ge	PNP	0.080	0.010	34 (Vcb)	40		45	T01	2 N 603	2 N 604
2 SA 274	Ge	PNP	0.080	0.010	34 (Vcb)	30		40	T01	2 N 274	2 N 1673
2 SA 275	Ge	PNP	0.080	0.010	34 (Vcb)	45		60	T01	2 N 603	2 N 604
2 SA 276	Ge	PNP	0.075	0.020	15	200		60	T017	ASZ 21	2 N 607
2 SA 277	Ge	PNP	0.065	0.040	18 (Vcb)	3,5		50	T05	2 N 1742	2 N 1726
2 SA 278	Ge	PNP	0.065	0.040	18 (Vcb)	11		100	T05	2 SA 316	2 N 1726
2 SA 279	Ge	PNP	0.120	0.030	30 (Vcb)	80		100	T07	2 N 2635	2 N 645
2 SA 282	Ge	PNP	0.150	0.200	18	3,8		80	T05	AF 188	2 N 1854
2 SA 283	Ge	PNP	0.150	0.200	18	6		80	T05	AF 188	2 N 1854
2 SA 284	Ge	PNP	0.150	0.200	18	10		80	T05	AF 188	2 N 1854
2 SA 285	Ge	PNP	0.050	0.005	18 (Vcb)	40		70	T044	2 SA 221	AF 115 ou 116
2 SA 288	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	1000		20	T07	2 N 2363	2 N 4958 ou
2 SA 289	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	1000		20	T07	2 N 2363	2 N 4959
2 SA 290	Ge	PNP	0.080	0.010	20 (Vcb)	1000		20	T07	2 N 2363	(silicium)
2 SA 291	Ge	PNP	0.050	0.050	20 (Vcb)	100		40	R48	2 N 979	2 N 980
2 SA 292	Ge	PNP	0.050	0.050	15 (Vcb)	200		40	R48	2 N 1865	AF 106
2 SA 293	Ge	PNP	0.050	0.050	15 (Vcb)	300		40	R48	2 N 2487	2 N 2488

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 SA 294	Ge	PNP	0,050	0,050	15 (Vcb)	400		40	R48	2 N 2487	2 N 2488
2 SA 295	Ge	PNP	0,050	0,050	15	BF		50	R48	2 N 1787	2 N 501A
2 SA 296	Ge	PNP	0,080	0,015	15 (Vcb)	5		45	T01	2 SA 144	AC 107 N
2 SA 297	Ge	PNP	0,080	0,015	15 (Vcb)	10		65	T01	2 N 219	AC 107 N
2 SA 298	Ge	PNP	0,080	0,010	40 (Vcb)	35		55	T044	2 N 1178	2 N 1179
2 SA 304	Ge	PNP	0,065	0,040	18 (Vcb)	4,5		70	T09	2 N 1742	2 N 1864
2 SA 305	Ge	PNP	0,065	0,040	18 (Vcb)	10		70	T05	2 N 1742	2 N 1864
2 SA 306	Ge	PNP	0,080	0,010	40 (Vcb)	55		65	T044	2 N 1180	2 N 1179
2 SA 307	Ge	PNP	0,080	0,010	40 (Vcb)	75		70	T044	2 N 1180	2 N 1179
2 SA 311	Ge	PNP	0,150	0,400	40	50		60	T05	2 N 4971	2 N 49272
2 SA 312	Ge	PNP	0,150	0,200	40	50		60	T05	2 N 4964	2 N 4965
2 SA 313	Ge	PNP	0,060	0,020	18 (Vcb)	40		60	T05	2 N 1726	2 N 1728
2 SA 314	Ge	PNP	0,060	0,020	18 (Vcb)	40		80	T05	2 N 1726	2 N 1728
2 SA 315	Ge	PNP	0,060	0,020	18 (Vcb)	55		100	T05	2 N 1726	2 N 1728
2 SA 316	Ge	PNP	0,060	0,020	18 (Vcb)	75		120	T05	2 N 1726	2 N 1728
2 SA 321	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	25		40	T044	2 SA 219	AF 115 ou 116
2 SA 322	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	30		40	T044	2 SA 219	AF 115 ou 116
2 SA 323	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	35		37	T044	2 SA 219	AF 115 ou 116
2 SA 324	Ge	PNP	0,050	0,010	20 (Vcb)	60		24	T044	2 SA 223	AF 115 ou 116
2 SA 325	Ge	PNP	0,080		15 (Vcb)	5		60	T01	2 N 140	2 N 219
2 SA 326	Ge	PNP	0,080		16 (Vcb)	10		60	T01	2 N 140	2 N 219
2 SA 327	Ge	PNP	0,080			35		30	T044	2 SA 351	2 SA 353
2 SA 338	Ge	PNP	0,050	0,005	20(Vcb)	20		30	T044	2 SA 285	2 SA 219
2 SA 339	Ge	PNP	0,050	0,005	20 (Vcb)	30		60	R18	2 SA 285	2 SA 219
2 SA 340	Ge	PNP	0,063	0,010	20 (Vcb)	70		100	T072	2 SA 341	2 SA 316
2 SA 341	Ge	PNP	0,063	0,010	20 (Vcb)	70		100	T072	2 SA 340	2 SA 316
2 SA 342	Ge	PNP	0,063	0,010	20 (Vcb)	100		100	T072	2 SA 341	2 N 1748
2 SA 343	Ge	PNP	0,083	0,005	20 (Vcb)	150		100	T07	AFZ 12	OC 170 ou 171
2 SA 344	Ge	PNP	0,120	0,030	30 (Vcb)	100		200	T044	2 N 6365 A	2N 2635
2 SA 350	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	40		40	T01	AF 117	AF 114
2 SA 350 H	Ge	PNP	0,080	0,010	30 (Vcb)	45		12	T01	2 N 3588	SK 3006
2 SA 351	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	40		70	T01	AF 117	AF 114
2 SA 352	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	40		75	T01	AF 117	AF 114

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de jointier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 416	Ge	PNP	6	0,700	60	90	40	100	T03	AUY 10	2 SA 645 Silicium
2 SA 417	Ge	PNP	0,150	0,200	15	400		70	T046	2 N 2957	2 N 972
2 SA 419	Ge	PNP	0,050	0,005	20	350		20	T017	2 N 2717	AFY 16
2 SA 420	Ge	PNP	0,050	0,005	20	300		20	T017	2 N 2717	AFY 16
2 SA 421	Ge	PNP	0,050	0,005	20	400		25	T017	2 N 3399	AFY 16
2 SA 422	Ge	PNP	0,050	0,005	20	500		25	T017	AFY 16	2 N 3280
2 SA 425	Ge	PNP	0,200	0,030	30 (Vcb)	350		25	T05	2 N 2238	2 N 1142 A
2 SA 426	Ge	PNP	0,200	0,030	30 (Vcb)	500		30	T05	2 N 1142	2 N 1143
2 SA 427	Ge	PNP	0,100	0,015	20 (Vcb)	45		60	T044	2 N 2089	2 N 2090
2 SA 428	Ge	PNP	0,100	0,015	20 (Vcb)	50		80	T044	2 N 3285	2 N 3286
2 SA 429	Si	PNP	0,150	0,030	150	100		60	R67	2 SA 429 G	2 SA 845 H
2 SA 429 G	Si	PNP	0,150	0,030	150	100		240	R67	2 SA 638 S	2 SA 429
2 SA 430	Ge	PNP	0,070	0,005	20 (Vcb)	450	4,5		T072	AF 139	AF 239
2 SA 431	Ge	PNP	0,070	0,005	20 (Vcb)	800		25	T017	AF 279 S	2 N 2360
2 SA 431 A	Ge	PNP	0,070	0,005	20 (Vcb)	500		15	T072	AF 139	AF 239
2 SA 432	Ge	PNP	0,070	0,005	20 (Vcb)	800		16	T017	AF 279 S	2 N 2360
2 SA 433	Ge	PNP	0,055	0,005	18	1,7		60	T044	HEP 639	HEP 640
2 SA 434	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	400	10		T07	2 SA 435	2 N 3399
2 SA 435	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	400	10		T018	2 SA 434	2 N 3399
2 SA 436	Ge	PNP	0,060	0,010	20 (Vcb)	400	10		T018	AF 139	AF 239
2 SA 437	Ge	PNP	0,060	0,010	20 (Vcb)	400	10		T018	AF 139	AF 239
2 SA 438	Ge	PNP	0,060	0,010	20 (Vcb)	400	10		T018	AF 139	AF 239
2 SA 440 A	Ge	PNP	0,060	0,005	20 (Vcb)	350		50	R146	AF 139	AF 239
2 SA 446	Ge	PNP	0,200	0,200	15	450		70	T05	AFY 18	2 N 1094
2 SA 447	Ge	PNP	0,090	0,015	25	650		80	T012	AFY 42	2 N 3883
2 SA 448	Ge	PNP	0,040	0,005	15 (Vcb)	1600		40	T017	2 N 2999	2 N 2360
2 SA 450 H	Ge	PNP	0,150	0,100	6	530		45	T018	2 N 3449	2 N 2455
2 SA 451 H	Ge	PNP	0,150	0,100	6	530		95	T018	2 N 2455	2 N 3449
2 SA 452 H	Ge	PNP	0,150	0,100	6	530			T018	2 N 2455	2 N 3449
2 SA 453	Ge	PNP	0,060	0,010	22 (Vcb)	600		6	T018	AF 240 S	AF 139
2 SA 454	Ge	PNP	0,060	0,010	22(Vcb)	600		12	T018	AF 240	AF 139
2 SA 455	Ge	PNP	0,060	0,010	22 (Vcb)	600		24	T018	AF 240	AF 139
2 SA 456	Ge	PNP	0,060	0,010	22(Vcb)	600		48	T018	AF 240	AF 139

P_c = Puissance collecteur max.
 I_c = Courant collecteur max.
 V_{ce} max = Tension collecteur émetteur max.
 f_{max} = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Matière	Polarité	P _c (W)	I _c (A)	V _{ce} max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
SA 353	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	35		70	T01	2 N 1526	SK 3007
SA 353 A	Ge	PNP	0,080	0,010	50 (Vcb)	30		70	T01	40261	2 N 1226
SA 354	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	35		70	T01	2 N 1526	SK 3007
SA 353 A	Ge	PNP	0,080	0,010	50 (Vcb)	30		70	T01	40261	2 N 1226
SA 355	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	40		90	T01	2 N 1526	SK 3007
SA 355 A	Ge	PNP	0,080	0,010	50 (Vcb)	30		90	T01	40261	2 N 1226
SA 358	Ge	PNP	0,125	0,050	75 (Vcb)	20		90	X35	2 N 2512	MA 205
SA 359	Ge	PNP	0,350	0,020	20 (Vcb)	250		30	T05	2 N 3371	2 N 2630
SA 371	Ge	PNP	0,080	T. recouv. 900 ns		8			T01	2 N 1093	2 N 576 A
SA 372	Ge	PNP	0,100	0,200	15	450		25	T018	2 N 3281	2 N 3282
SA 373	Ge	PNP	0,250	0,150	12	640		40	T05	2 N 3995	AFY 18 C
SA 374	Ge	PNP	1500	0,300	34 (Vcb)	300		100	T05	2 N 5042 Silicium	2 N 2786
SA 377	Ge	PNP	0,050	0,005	20	230		100	T072	2 SA 420	2 SA 239
SA 378	Ge	PNP	0,050	0,005	20	290		100	R38	2 SA 420	AF 306
SA 379	Ge	PNP	0,050	0,005	20	350		100	R38	2 SA 440 A	AF 139
SA 380	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	35		50	T01	2 N 1524	2 N 1527
SA 381	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	60		70	T01	2 N 1526	AF 117
SA 382	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	30		55	T01	2 N 1524	2 N 1527
SA 383	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	40		40	T01	2 N 1524	AF 117
SA 384	Ge	PNP	0,080	0,010	25 (Vcb)	40		60	T01	2 N 1526	AF 117
SA 385	Ge	PNP	0,080	0,010	(16 Vcb)	10		120	T01	2 N 140	2 N 219
SA 400	Ge	PNP	0,080	0,010	20 (Vcb)	70		70	T01	AF 114	AF 117
SA 401	Ge	PNP	0,125	0,040	30 (Vcb)	230		70	T044	2 N 838	2 N 1094
SA 402	Ge	PNP	0,250	0,100	30	200		200	T018	2 N 2238	BF 506 Silicium
SA 405	Ge	PNP	0,150	0,050	15	300		40	T018	2 N 968	2 N 972
SA 406	Ge	PNP	0,200	0,200	15	9		50	T05	AF 188	2 N 1669
SA 407	Ge	PNP	0,200	0,200	12	14		60	T05	2 N 1300	2 N 1301
SA 408	Ge	PNP	0,050	0,050	6	50		100	R48	2 N 2059	2 N 3321
SA 409	Ge	PNP	0,050	0,050	6	80		100	R48	2 N 3321	2 N 2059
SA 412	Ge	PNP	0,150	0,200	12	60		30	T01	2 N 1301	2 N 796
SA 413	Ge	PNP	0,100	0,030	15	500		70	T018	2 N 3281	2 N 3282
SA 414	Ge	PNP	0,150	0,200	25	5,5		30	T05	HEP 635	2 N 2955
SA 415	Ge	PNP	0,150	0,200	20	8		45	T05	2 N 396	2 N 3400

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de joint	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 457	Ge	PNP	0,055	0,020	18 (Vcb)	45		200	T044	2 N 1864	2 N 501 et A
2 SA 467	Si	PNP	0,300	0,400	30	200		100	R67	BC 126	BC 213
2 SA 467 G	Si	PNP	0,300	0,400	30	100		240	R67	BC 258 B	BSW 19 A
2 SA 468	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	30		70	T01	HEP 639	2 N 1742
2 SA 469	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	30		50	T01	HEP 640	2 N 1742
2 SA 470	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	30		75	T01	HEP 639	2 N 1742
2 SA 471	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	30		50	T01	HEP 640	2 N 1742
2 SA 472	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	30		80	T01	HEP 639	2 N 1742
2 SA 473	Si	PNP	10	3	25	200	40	400	X75	BD 362	BD 362 A
2 SA 474	Ge	PNP	0,120	0,050	50(Vcb)	70		50	T01	2 N 1408	2 N 2190
2 SA 475	Ge	PNP	0,120	0,050	20(Vcb)	30		70	T01	2 N 2048	2 N 3400
2 SA 476	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	130		70	T01	2 N 2489	2 N 502
2 SA 477	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	70		70	T01	2 N 2489	2 N 502
2 SA 478	Ge	PNP	0,125	0,400	40	40		60	T01	2 N 2375	2 N 1008 A
2 SA 479	Ge	PNP	0,125	0,200	40	40		60	T01	2 N 1371	2 N 1375
2 SA 480	Si	PNP	0,150	0,100	20	140		60	T018	BC 206	2 N 5139
2 SA 482	Si	PNP	0,600	0,600	32	70		50	T039	2 N 2303	2 N 1132
2 SA 483	Si	PNP	20	1	150	9	30	250	T066	2 SA 740	2 SA 913
2 SA 489	Si	PNP	30	4	60	5	40	240	X75	2 N 6415	2 SB 509
2 SA 490	Si	PNP	25	3	40	4	40	240	X75	2 SA 670	2 SA 671
2 SA 493	Si	PNP	0,200	0,050	50	200		200	R67	BC 416 A	2 SA 640
2 SA 493 G	Si	PNP	0,200	0,050	50	80		700	R67	BC 416 C	2 SA 889
2 SA 494 GR	Si	PNP	0,200	0,030	30	10		220	R67	BC 224	PC 1008 B
2 SA 494 O	Si	PNP	0,200	0,030	30	10		90	R67	2 N 940	2 N 3344
2 SA 494 Y	Si	PNP	0,200	0,030	30	10		140	R67	BF 342	BF 341
2 SA 495	Si	PNP	0,200	0,100	20	200		80	R67	2 N 5139	BC 205
2 SA 495 G	Si	PNP	0,200	0,100	20	200	40		R67	2 N 5139	BC 205
2 SA 496	Si	PNP	5	0,800	30	100	40	240	B7	BFS 95	2 N 5583
2 SA 497	Si	PNP	0,600	0,800	80	70		70	T039	BSY 42	MPSA 56
2 SA 498	Si	PNP	0,600	0,800	50	70		70	T039	BFX 87	2 N 3081
2 SA 499	Si	PNP	0,250	0,100	40	250	30		T018	2 SA 522 A	BC 417
2 SA 500	Si	PNP	0,250	0,100	20	250	30		T018	2 SA 838	BF 936
2 SA 502	Si	PNP	0,300	0,050	70	100		60	R67	2 N 1196	2 N 1197

5 C transistor
de commutation

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 503	Si	PNP	0,800	0,600	50	130	30		T039	BFR 81	BFX 39
2 SA 504	Si	PNP	0,800	0,600	30	130	30		T039	BC 231 M	BSX 41
2 SA 505	Si	PNP	5	0,800	50	100	40	240	B7	2 N 5865	2 N 3661
2 SA 506	Ge	PNP	0,075	0,005	18	300		20	R43	2 SA 239	AF 306
2 SA 507	Ge	PNP	0,075	0,005	18	250		20	R43	2 SA 239	AF 306
2 SA 508	Ge	PNP	0,075	0,005	18	200		8	R43	2 SA 239	AF 306
2 SA 509	Si	PNP	0,600	0,050	30	140		100	R67	BF 709	2 SA 594
2 SA 510	Si	PNP	0,800	1	100	50	50		T039	2 N 3225	2 SA 850
2 SA 511	Si	PNP	0,800	1	80	50	50		T039	BFT 79	BFX 40 ou 41
2 SA 512	Si	PNP	0,800	1	60	50	50		T039	BFT 80	BFT 81
2 SA 513	Si	PNP	0,800	1	40	50	50		T039	2 N 2801	2 N 2800
2 SA 516	Si	PNP	0,800	1,5	60	50		60	T05	BFX 38	BFX 39
2 SA 516 A	Si	PNP	0,800	1,5	100	50		60	T05	2 N 3225	2 SA 850
2 SA 517	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	55		60	T01	2 N 1864	2 N 501 A
2 SA 518	Ge	PNP	0,055	0,010	18 (Vcb)	75		60	T01	2 N 1864	2 N 501 A
2 SA 522	Si	PNP	0,250	0,100	20	200		50	T018	BF 939	BF 936
2 SA 522 A	Si	PNP	0,250	0,100	40	200		50	T018	BC 116	BC 126 A
2 SA 523	Si	PNP	0,650	0,300	20	200	20		T039	2 SA 119	2 SA 120 A
2 SA 523 A	Si	PNP	0,650	0,300	40	200	20		T039	BCW 96 K	BFY 64
2 SA 524	Si	PNP	0,350	0,100	25 (Vcb)	250		50	T018	2 N 5208	MPS 6519
2 SA 525	Si	PNP	0,075	0,005	18	250		20	T017	BC 250	BCW 63
2 SA 527	Si	PNP	5	2	40	80		50	T05	2 SA 528	2 SA 257
2 SA 528	Si	PNP	5	2	40	80		70	T05	2 SA 527	2 SA 258
2 SA 530 H	Si	PNP	0,200	0,100	35	200		120	T018	BF 316 A	2 N 3307
2 SA 532	Si	PNP	0,500	0,200	50	90		80	T039	BC 560 A	BC 557 VI
2 SA 537	Si	PNP	0,750	0,700	50	200	35	200	T05	MM 1614	MM 1712
2 SA 537 A	Si	PNP	0,750	0,700	80	200	35	200	T05		40410
2 SA 537 AH _{5c}	Si	PNP	0,750	T. recouv. 300 ns		150	30		T039	2 N 5372	2 N 5375
2 SA 537 H _{5c}	Si	PNP	0,750	T. recouv. 300 ns		150	30		T039	2 N 5372	2 N 5375
2 SA 538	Ge	PNP	0,120	0,050	25 (Vcb)	8		70	T01	40359	40395
2 SA 539	Si	PNP	0,250	0,200	45	BF		80	R182	BC 417	BC 307
2 SA 542	Si	PNP	0,150	0,050	25	30		160	u23	BFV 82 C	BFV 82 A
2 SA 544	Si	PNP	0,750	0,200	45	160	40		T039	2 SA 552	MPS 2907

Pc = Puissance collecteur max.

Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium

• Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 545	Si	PNP	0,400	0,200	60	BF		80	R205	2 N 3061 avec clips	2 N 3060 avec clips
2 SA 546	Si	PNP	0,750	1	60	80	25		T039	2 N 5855	BC 311
2 SA 546 A	Si	PNP	0,750	1	80	80	25		T039	2 N 5857	BSW40-6
2 SA 547	Si	PNP	10	1	60	80	25		T037	2 N 6406	NSE 171
2 SA 547 A	Si	PNP	10	1	80	80	25		T037	2 SB 526	2 SB 548
2 SA 548	Si	PNP	0,200	0,100	35	400		100		2 N 4121	2 SA 530 H
2 SA 548 H _(5c)	Si	PNP	0,200	T. recouv. 150 ns		400	1			2 N 4121	2 N 4122
2 SA 549 AH	Si	PNP	0,200			40	30		T018	2 SA 617 K	2 SA 618 K
2 SA 550	Si	PNP	0,300	0,100	25	150		250	T018	BC 308 A	BC 308 B
2 SA 550 A	Si	PNP	0,300	0,100	45	150		250	T018	BC 204 A	BC 204 B
2 SA 552	Si	PNP	0,750	0,200	45	160	40		T039	2 SA 544	MPS 2907
2 SA 553	Si	PNP	0,250	0,300	40 (Vcb)	200		60	T018	2 SA 554 A	BC181
2 SA 554	Si	PNP	0,250	0,300	25 (Vcb)	200		60	T018	BC 419	BC 419 A
2 SA 554 A	Si	PNP	0,250	0,300	40 (Vcb)	200		60	T018	2 SA 553	BC 181
2 SA 555	Si	PNP	0,200	0,200	30	200		80	R195	2 N 4916	2 N 4917
2 SA 558	Si	PNP	0,350	0,200	35	BF		50	T018	2 SA 559 A	MPS 404 A
2 SA 559	Si	PNP	0,350	0,200	20	BF		50	T018	BC 352	BC 352 A
2 SA 559 A	Si	PNP	0,350	0,200	35	BF		50	T018	2 SA 558	MPS 404 A
2 SA 560	Si	PNP	0,800	0,800	60	150		60	T039	BFR 80	BFR 79
2 SA 561	Si	PNP	0,300	0,150	50	70		100	R67	BC 307	BC 177 A
2 SA 562	Si	PNP	0,300	0,400	30	70	40		R67	BC 221	BSW 19 VI
2 SA 564	Si	PNP	0,250	0,050	25	BF		250	T092	BC 418 B	2 SA 677
2 SA 564 A	Si	PNP	0,250	0,050	45	BF		250	T092	BC 257 B	BC 257
2 SA 565	Si	PNP	350	0,500	50		40	200	T01	sans équivalents	
2 SA 565 K	Si	PNP	0,300				40		T01	équivalents impossibles	
2 SA 566	Si	PNP	10	0,700	100	100	35	200	T066	2 N 5603	2 SB 527
2 SA 567	Si	PNP	0,200	0,100	30 (Vcb)	100		300	T01	2 N 4916	BC 158 B
2 SA 568	Si	PNP	0,200	0,300	30	120	35		T092	BC 221	BC 126
2 SA 569	Si	PNP	0,200	0,300	45	120	35		T092	BC 177 V	BC 157
2 SA 570	Si	PNP	0,200	0,300	60	120	35		T092	2 SA 628 A	BCW 56
2 SA 571	Si	PNP	0,800	1	45	200	40		T05	BC 116 A	BC 126 A
2 SA 578	Si	PNP	0,300	0,030	40	50		350	T018	2 SA 579	BC 307 B
2 SA 579	Si	PNP	0,300	0,030	40	50		350	T018	2 SA 578	BC 307 B

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus apprôché	Approximative
2 SA 580	Si	PNP	0,800	0,600	40	100		120	T039	BC313	BC 304-5
2 SA 581	Si	PNP	0,800	0,600	70	100		120	T039	BFX 40	BFX 41
2 SA 594	Si	PNP	0,750	0,200	30	200		60	T05	BC 328 -5	MPS 6535-M
2 SA 597	Si	PNP	6	1	40	0,400	10	250	T039	BSV 15	BSV 16
2 SA 603	Si	PNP	0,300	0,200	40	150	80		T018	BCW 37	2 N 4142
2 SA 604	Si	PNP	0,300	0,030	100	100	40		T018	2 N 600 A	2 N 1655
2 SA 605	Si	PNP	0,300	0,050	160	100	50		T018	2 SA 639	BFW 43
2 SA 606	Si	PNP	0,700	0,700	80	50		80	T039	BSW 40-16	BSW 40-10
2 SA 606 S	Si	PNP	0,700	0,700	80	BF		100	T039	2 SA 606	BSW 40-25
2 SA 607	Si	PNP	1	0,700	80	50	40	200	T037	2 N 5149	2 N 5147
2 SA 607 S	Si	PNP	1	0,700	80	BF	40	200	T037	2 SA 607	2 N 5147
2 SA 608	Si	PNP	0,100	0,100	15	180		100	R145	2 SC 641 K	2 N 2278
2 SA 609	Si	PNP	0,100	0,100	15	80		80	R145	2 SC 641 K	2 N 2278
2 SA 613	Si	PNP	15	2	40		30	200	T066	BD 132	BD 227
2 SA 614	Si	PNP	15	2	60		30	200	T066	SDT 3576	2 N 4388
2 SA 616	Si	PNP	25	3	60	5	30	145	T066	2 N 3026	2 N 3023
2 SA 617 K	Si	PNP	0,200		40	40		80	T018	2 SA 618 K	BC 154
2 SA 618 K	Si	PNP	0,200		40	40		80	T018	2 SA 617 K	BC 154
2 SA 623	Si	PNP	7	1,5	20	70	35	300	X51		2 N 3660
2 SA 624	Si	PNP	7	1,5	40	70	35	300	X51		40394
2 SA 625	Si	PNP	0,700	0,500	70	100		150	T039	BSV 42	BSV 43 B
2 SA 626	Si	PNP	60	6	70	10	30	120	T03	MJ 701	MJ 6701
2 SA 627	Si	PNP	60	7	80	10	30	120	T03	2 SA 648	2 SA 757
2 SA 628	Si	PNP	0,150	0,100	25	100		100	T092	2 N 3308	2 N 1225
2 SA 628 A	Si	PNP	0,150	0,100	60	100		100	T092	2 N 4249	BCY 30
2 SA 629	Si	PNP	0,150	0,030	25	100		200	T092	2 N 3308	
2 SA 634	Si	PNP	10	2	30	60	40	250	T0202	NPC 634	NSE 170
2 SA 636	Si	PNP	10	1	45	50	40	250	T0202	NPC 636	BD 227
2 SA 636 A	Si	PNP	10	5	60	40	40	250	T0202	NSE 171	NSDU 55
2 SA 637	Si	PNP	0,300	0,050	150	40	30		T018	2 SA 685	2 N 4888
2 SA 638 S	Si	PNP	0,250	0,050	150	130		120	T092	2 N 4888	2 N 4889
2 SA 639	Si	PNP	0,250	0,050	160	50		100	T092	2 SA 858	BFW 43
2 SA 639 S	Si	PNP	0,250	0,050	180	130		120	T092	BC 420 A	BC 420 VI

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	N a t u r e	P o l a r i t é	Pc [W]	Ic [A]	Vce max. [V]	F max. [MHz]	Gain		Type de jointier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 640	Si	PNP	0,250	0,050	50	100		450	R 182	2 SA 641	2 SA 750
2 SA 641	Si	PNP	0,250	0,050	50	100		450	R 182	2 SA 640	2 SA 750
2 SA 642	Si	PNP	0,250	0,300	15	150	65		T092	2 SB 542	BC 419 A
2 SA 643	Si	PNP	0,500	0,500	20	BF		120	R 205	BC 328 a)	2 SA 730 a)
2 SA 645	Si	PNP	7	0,800	60	70	35	300	X51	TIP 62A	2 N 3779
2 SA 646	Si	PNP	7	0,800	80	70	20	300	X51	TIP 62B	2 SB 526
2 SA 647	Si	PNP	7	0,800	100	70	20	300	X51	TIP 62C	2 SB 527
2 SA 648	Si	PNP	60	7	80	10	30	120	T03	2 SA 627	BDX 78
2 SA 649	Si	PNP	80	7	100	10	30	120	T03	BDX 96	2 SB 541
2 SA 652	Si	PNP	15	1	100	5	40	200	T066	2 N 5603	TIP 30 C
2 SA 653	Si	PNP	15	1	120	5	40	200	T066	2 SA 762	BDX 16
2 SA 656	Si	PNP	50	7	110	5	30	300	T03	2 SA 656 A	TIP 42 C
2 SA 656 A	Si	PNP	50	7	110	5	30	300	T03	2 SA 656	TIP 42 C
2 SA 657	Si	PNP	50	7	80	5	30	300	T03	2 SA 657 A	2 N 6134
2 SA 657 A	Si	PNP	50	7	80	5	30	300	T03	2 SA 657	2 N 6134
2 SA 658	Si	PNP	50	7	50	5	30	300	T03	2 SA 658 A	2 N 6133
2 SA 658 A	Si	PNP	50	7	50	5	30	300	T03	2 SA 658	2 N 6133
2 SA 659	Si	PNP	0,300	0,200	50	90		80	R195	BC 257 VI	BC 307 A
2 SA 661	Si	PNP	0,600	0,200	50	100		100	X161	2 N 3081	BFX 87
2 SA 663	Si	PNP	60	7	80	6	30	200	T03	2 N 6134	2 SB 518
2 SA 666	Si	PNP	0,150	0,100	25	BF		700	T092	BC 178 C	BC 308 C
2 SA 666 A	Si	PNP	0,150	0,100	45	BF		700	T092	2 SA 493 G	BCX 71 BK
2 SA 670	Si	PNP	25	3	50	11	35	200	B17	2 SA 671	2 N 3022
2 SA 671	Si	PNP	25	3	50	11	35	200	B17	2 SA 670	2 N 3022
2 SA 671 K	Si	PNP	25	3	50	8	35	200	T0220	2 SA 670 ou 71	BD 242
2 SA 672	Si	PNP	0,200	0,200	50	80	60			BC 417	BC 257 A
2 SA 673	Si	PNP	0,400	0,500	35		40	320		BC 327-25	BC 327-16
2 SA 673 A	Si	PNP	0,400	0,500	50		40	320		2 N 3136	2 N 2906
2 SA 673 AK	Si	PNP	0,400			120		320	S8	2 N 3136	2 N 2906
2 SA 675	Si	PNP	0,250	0,100	80	50		120	T092	BC 612	MPSH 54 ou 55
2 SA 677	Si	PNP	0,250	0,200	25	140		250	X 153	2 SA 704	BC 181
2 SA 678	Si	PNP	0,250	0,200	50	140		250	X 153	2 SA 705	BC 307 A
2 SA 679	Si	PNP	100	12	120	6	40	140	T03	2 SB 556	2 N 6248

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 680	Si	PNP	100	12	100	6	40	140	T03	2 N 6052	2 N 5627
2 SA 682	Si	PNP	0,600	0,750	80	100		120	B7	BFX 40	BFX 41
2 SA 683	Si	PNP	0,750	1,5	25	200	60	340	R182	2 SA 751	2 N 5583
2 SA 684	Si	PNP	1,5	1,5	50	200	60	340	R182	MM 3726	2 N 5865
2 SA 685	Si	PNP	0,300	0,050	150	40		30	T092	2 SA 637	2 N 4889
2 SA 695	Si	PNP	0,500	0,700	20	130		100	T092	2 SB 561	MPS 6562
2 SA 696	Si	PNP	0,500	0,500	40	130		100	T092	2 N 2904	2 N 2905
2 SA 697	Si	PNP	0,500	0,500	60	130		100	T092	D 29 E 10	2 N 3765
2 SA 699	Si	PNP	10	3	20	150	30	220	B15	2 SA 473	
2 SA 699 A	Si	PNP	10	3	40	150	30	220	B15	TIP 32	BD 242
2 SA 701	Si	PNP	0,100	0,050	30	80		200	R145	2 N 2185 à	2 N 2187
2 SA 702	Si	PNP	0,100	0,050	50	80		200	R145	2 N 1921	2 N 945
2 SA 704	Si	PNP	0,250	0,200	25	140		250	X153	2 SA 677	BC 181
2 SA 705	Si	PNP	0,250	0,200	50	140		250	X153	2 SA 678	BC 307 A
2 SA 706	Si	PNP	0,950	1	60	120		150	B2	BC 313 A	BC 287
2 SA 708	Si	PNP	0,800	0,700	60	100	80		T039	BC 361-10	BC 361-6
2 SA 708 A	Si	PNP	0,800	0,700	80	100	80		T039	BFX 40	2 N 4033
2 SA 709	Si	PNP	0,300	0,200	40	250		160	R221	BC 307	BC 307-5
2 SA 711	Si	PNP	0,300	0,100	40	800	70		T018	2 N 6007	BF 516
2 SA 712	Si	PNP	0,750	0,500	150	300		110	T039	2 N 5401	2 SA 912
2 SA 713 A	Si	PNP	0,250	0,300	30	180		12 k	T092	BC 178 C	BC 203
2 SA 714	Si	PNP	60	12	100	8		320	T03	2 SB 541	2 N 5738
2 SA 714 L	Si	PNP	60	12	80	8		320	T03	HEP 625	SDT 3826
2 SA 715	Si	PNP	8	1,5	35	10	35	320	B16	2 SA 715 WT	2 SB 511
2 SA 715 WT	Si	PNP	10	1,5	35	160	35	320	B7	2 SA 715	2 SB 511
2 SA 717	Si	PNP	5	1	40	280	40	200	T039	MM 4019	BFS 94
2 SA 718	Si	PNP	0,300	0,200	40	250		140	T018	BC 307	BC 307-5
2 SA 719	Si	PNP	0,400	0,500	25	200		90	T092	BSW 72	BF 249
2 SA 720	Si	PNP	0,400	0,500	50	200		90	T092	SK 3114	BCY 54
2 SA 721	Si	PNP	0,150	0,100	35	BF		1 k	T092	2 SA 880	2N 2336 ou 37
2 SA 722	Si	PNP	0,150	0,100	55	BF		1 k	T092	2 SA 726	2 N 4250 A
2 SA 723	Si	PNP	0,250	0,500	20	BF		120	R182	2 N 5142	2 N 4290
2 SA 725	Si	PNP	0,150	0,100	35	100		600	T092	2 SA 721	2 N 4285

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approché	Approximative
2 SA 726	Si	PNP	0,150	0,100	50	100		600	T092	2 N 4250 A	BC 251
2 SA 730	Si	PNP	0,600	0,500	25	200		90	R209	BSV 45 A a)	BSV 45 B a)
2 SA 731	Si	PNP	0,600	0,500	50	200		90	R209	2 N 2904 A a)	BFX 87 a)
2 SA 732	Si	PNP	0,650	0,300	30	200		60	T039	2 SA 594	BSV 45 A
2 SA 733	Si	PNP	0,250	0,100	40	180		200	T092	BC 251 A	BC 251 B
2 SA 738	Si	PNP	8	1,5	25	160	35	320	B7	BD 508	BD 506
2 SA 739	Si	PNP	50	3	400		20	300	T03		BUX 66 C
2 SA 740	Si	PNP	25	1,5	150	8	40	140	T0220	2 SA 913	2 SA 483
2 SA 741 H	Si	PNP	0,360	0,100	20	BF	30		T018	BC 352	BC 352 A
2 SA 742 H	Si	PNP	0,700	0,500	60	200	80		T039	BSV 43 B	2 N 3503
2 SA 743	Si	PNP	8	1	50	120	40	320	B7	BD 516	BD 518
2 SA 743 A	Si	PNP	8	1	80	120	40	320	B7	BD 520	BD 526
2 SA 744	Si	PNP	70	8	80	15	30		T03	BD 544 B	MJE 6041
2 SA 745	Si	PNP	70	8	100	15	30		T03	BD 544 C	MJE 6042
2 SA 746	Si	PNP	100	10	80	15	30		T03	2 N 5625	2 N 5623
2 SA 747	Si	PNP	100	10	120	15	30		T03	2 SB 539	2 SB 539 A
2 SA 748	Si	PNP	15	3	50	120	30	220	B26		BD 132
2 SA 749	Si	PNP	0,250	0,050	100	40		80	T092	BSV 68	2 N 3841
2 SA 750	Si	PNP	0,250	0,050	50	100		450	R162	2 SA 640	2 SA 641
2 SA 751	Si	PNP	1	1,5	25	200	60	340	R209	2 SC 831	BD 227
2 SA 752	Si	PNP	1	1,5	50	200	60	340	R209	2 SA 684 a)	2 N 3763 a)
2 SA 753	Si	PNP	100	10	110	20	30	200	T03	2 N 6248	2 N 5627
2 SA 754	Si	PNP	20	2	50	50	35	320	B17	2 SA 755	SDT 3579
2 SA 755	Si	PNP	20	2	50	50	35	320	B17	2 SA 754	SDT 3579
2 SA 756	Si	PNP	50	6	80	20	35	200	T03	2 SA 808	2 N 4903
2 SA 757	Si	PNP	60	7	90	24	25	200	T03	2 SB 611	MJ 6701
2 SA 758	Si	PNP	80	7	110	20	25	200	T03	2 SA 649	2 N 6042
2 SA 761	Si	PNP	0,475	2	110	80		50	T05		BCX 39
2 SA 762	Si	PNP	23	2	110	30	50	240	T066	2 N 6467	BD 582
2 SA 764	Si	PNP	40	6	60	15	30		T066	2 N 5955	2 SA 770
2 SA 765	Si	PNP	40	6	80	15	30		T066	2 N 5954	2 SA 771
2 SA 766	Si	PNP	20	1,2	150		30	150	T066	2 SA 740	BUX 66
2 SA 768	Si	PNP	30	4	60	10	40	400	B26	2 N 5194	BD 440

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 769	Si	PNP	30	4	80	10	40	400	B26	2 N 5195	BD442
2 SA 770	Si	PNP	40	6	60	10	40	400	B26	BDX 28-16	2 N 5955
2 SA 771	Si	PNP	40	6	80	10	40	400	B26	BDX 29-10	2 N 5954
2 SA 772	Si	PNP	0,750	2	16	80		250	R195	2SB861	2 SA 562
2 SA 773	Si	PNP	0,750	1	50	55		200	R195	BFR 81	BFR 81 T05
2 SA 777	Si	PNP	0,750	1	80	120	65	330	R182	BSV 17	BSV 17-6
2 SA 778 AK	Si	PNP	0,200			50	30		S8		2 N 4964
2 SA 779 K	Si	PNP	1,2			110	60	320	B11		2 N 5022
2 SA 780 AK	Si	PNP	1,2			120	40	320	B11		2 SA 683
2 SA 781	Si	PNP	0,200			550		200	S8		BFX 48
2 SA 794	Si	PNP	5	0,500	100	120	65	330	T0126		2 SA 794 A
2 SA 794 A	Si	PNP	4	0,500	120	120	65	330	T0126		2 SA 794
2 SA 795	Si	PNP	10	0,250	150		60	240	T0126		TRSP 15 X
2 SA 798	Si	PNP	0,400	caractéristiques		incomplètes pour établir équivalences					
2 SA 799	Si	PNP	1	1,5	60		54		T039	2 N 6248	TIS 141
2 SA 800	Si	PNP	0,250	0,030	12	1,5 GHz		60	T072	2 N 4260 ou 61	2 N 4080
2 SA 801	Si	PNP	0,300	0,050	12	3 GHz		60	W9		BFG 23
2 SA 807	Si	PNP	50	6	60	10	20	50	T03	2 SA 626	2 N 6133
2 SA 808	Si	PNP	50	6	80	10	20	50	T03	2 SA 756	2 N 6134
2 SA 809	Si	PNP	0,700	0,050	120	100		150	R214	2 N 3495	2 N 3495 S
2 SA 810	Si	PNP	0,700	0,050	150	100		150	R214	BF 398	BFS 90 B
2 SA 811 C5	Si	PNP	0,150	0,030	45		135		X156	BCW 69 b)	BC 177 A
2 SA 811 C6	Si	PNP	0,150	0,030	45		200		X156	BCX 17 b)	BC 327
2 SA 811 C7	Si	PNP	0,150	0,030	45		300		X156	BCX 17 b)	BC 327
2 SA 811 C8	Si	PNP	0,150	0,030	45		450		X156	BCX 17 b)	BC 327
2 SA 812 M3	Si	PNP	0,150	0,100	40		60		X156	S0 2906 b)	2 N 2906
2 SA 812 M4	Si	PNP	0,150	0,100	40		90		X156	S0 2906 b)	2 N 2906
2 SA 812 M5	Si	PNP	0,150	0,100	40		135		X156	S0 2907 b)	2 N 2907
2 SA 812 M6	Si	PNP	0,150	0,100	40		200		X156	S0 2907 b)	2 N 2907
2 SA 812 M7	Si	PNP	0,150	0,100	40		300		X156	S0 2907 b)	2 N 2907
2 SA 813 S2	Si	PNP	0,150	0,200	45		50		X156	BCX 17 b)	BC 327
2 SA 813 S3	Si	PNP	0,150	0,200	45		75		X156	BCX 17 b)	BC 327
2 SA 813 S4	Si	PNP	0,150	0,200	45		100		X156	BCX 17 b)	BC 327

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 814	Si	PNP	15	1	120	30	70	240	T0220	2 SA 653	2 SB 528
2 SA 815	Si	PNP	15	1	100	30	70	240	T0220	2 N 6180	2 SB 527
2 SA 816	Si	PNP	1,5	0,750	80	100	70	240	B26	MM 4007	2 N 6556
2 SA 817	Si	PNP	0,625	0,300	80	80	200		R67	MPSA 56	BC 490 B
2 SA 818	Si	PNP	1	0,050	150	120	70	240	B15	2 SA 899	2 N 4929
2 SA 835	Si	PNP	0,950	0,500	140	45		150	B2	MM 4001	BFS 90 B
2 SA 837	Si	PNP	50	4	80	10	40	200	T03	2 N 4906	2 N 6297
2 SA 838	Si	PNP	0,250	0,030	20	300		100	T092	BF 936	BC 309
2 SA 839	Si	PNP	1,5	1,5	150	6	40	240	B26	TIP 508	TIP 507
2 SA 840	Si	PNP	0,750	0,500	140	45		150	R195	2 SA 896	BFW 44
2 SA 841	Si	PNP	0,200	0,050	60	140	200		R67	BC 256 B	BC 256 A
2 SA 842	Si	PNP	0,200	0,050	40	140	200		R67	BF 450	BC 225
2 SA 843	Si	PNP	20	0,500	150		60	200	B26	2 SB 546	2 SB 547
2 SA 844	Si	PNP	0,300	0,100	55	200	160		X172	2 SA 844 C	2 SB 637 K
2 SA 844 C	Si	PNP	0,300	0,100	55	200		320	X172	2 SA 844 D	BC 212 LA
2 SA 844 D	Si	PNP	0,300	0,100	55	200		500	X172	2 SA 844 E	BC 212 LB
2 SA 844 E	Si	PNP	0,300	0,100	55	200		800	X172	2 SA 844 F	2 SA 726
2 SA 844 F	Si	PNP	0,300	0,100	55	200		1200	X172		2 SA 722
2 SA 845 AH	Si	PNP	0,200	0,050	180	40		80	T018	BC 393	2 N 3930
2 SA 845 H	Si	PNP	0,200	0,050	150	40		80	T018	2 SA 639 S	2 SA 637
2 SA 847	Si	PNP	0,200	0,050	90	150		500	T092	MPS 8799	BCY 97
2 SA 848	Si	PNP	1	0,050	120	100	150		R214	2 SA 898	2 N 5680
2 SA 849	Si	PNP	1	0,050	150	100	150		R214	2 N 4929	2 N 4929 S
2 SA 850	Si	PNP	0,800	0,600	30	130	30		T039	MPS 6535 M	BSX 40
2 SA 851	Si	PNP	0,500	0,100	50	100		500	T092	BCW 76-25	2 SA 532
2 SA 852	Si	PNP	0,500	0,100	35	100		500	T092	2 SA 853	2 N 6067
2 SA 853	Si	PNP	0,500	0,100	35	100		500	T092	2 SA 852	2 N 6067
2 SA 857	Si	PNP	0,500	0,050	120	100		150	R195	2 N 3495	2 N 3495 S
2 SA 858	Si	PNP	0,500	0,050	150	100		150	R195	2 SA 810	BF 398
2 SA 861	Si	PNP	0,950	2	16	80		250	B2	2 SA 772	2 SA 900
2 SA 872	Si	PNP	0,300	0,050	90	120	160		T092	2 SA 893	2 SA 893 C
2 SA 872 C	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		320	T092	2 SA 893 C	BCY 97
2 SA 872 D	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		500	T092	2 SA 893 D	BCX 30

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 872 E	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		800	T092	2 SA 893 E	D 34 J 9
2 SA 872 F	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		1200	T092	2 SA 893 F	2 SA 872 E
2 SA 873	Si	PNP	0,300	0,250	40	220		140	R212	2 SA 718	BC 307 A
2 SA 876 H 5c)	Si	PNP	1	T. recouv. 250 ns		200	20		T018	2 SA 876 HC	2 N 6013
2 SA 876 HA 5c)	Si	PNP	1	T. recouv. 250 ns		200	20		T018	2 SA 876 HB	2 N 6017.
2 SA 876 HB 5c)	Si	PNP	1	T. recouv. 250 ns		200	20		T018	2 SA 876 HA	2 N 6013
2 SA 876 HC 5c)	Si	PNP	1	T. recouv. 250 ns.		200	20		T018	2 SA 876 H	2 N 6017
2 SA 879	Si	PNP	0,600	0,070	200	80	30		T0126	MPSD 51	MPSA 93
2 SA 880	Si	PNP	0,150	0,050	35	BF		1000	S9	2 SA 721	2 SA 725
2 SA 883	Si	PNP	0,300	0,200	40	280		160	R182	2 SA 709	BF 440
2 SA 885	Si	PNP	1,2	1	35	200	60	340	T0126	2 N 3244	2 SA 886
2 SA 886	Si	PNP	1,2	1,5	40	150	30	220	T0126	MJE 710	2 SA 885
2 SA 887	Si	PNP	1,2	2	50	150	30	220	B15	BC 362	2 N 1084.
2 SA 888	Si	PNP	0,350	0,100	25	100		700	T092	BC 214 C	BC 214 LC
2 SA 889	Si	PNP	0,350	0,100	45	100		700	T092	2 N 4359	2 N 2605 A
2 SA 890	Si	PNP	0,625	1	25	200		160	T092	BC 328-5	BC 328-18
2 SA 891	Si	PNP	0,625	1	50	200		160	T092	BC 486 A	BCW 45
2 SA 893	Si	PNP	0,300	0,050	90	120	160		T092	2 SA 872	2 SA 872 C
2 SA 893 A	Si	PNP	0,300	0,050	120	120	160		T092	2 SA 857	2 N 3497
2 SA 893 AC	Si	PNP	0,300	0,050	120	120		320	T092	2 SA 893 AD	2 SA 893 A
2 SA 893 AD	Si	PNP	0,300	0,050	120	120		500	T092	2 SA 893 AE	2 SA 893 AC
2 SA 893 AE	Si	PNP	0,300	0,050	120	120		800	T092	2 SA 893 AF	2 SA 893 AD
2 SA 893 AF	Si	PNP	0,300	0,050	120	120		1200	T092		2 SA 893 AE
2 SA 893 C	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		320 b)	T092	2 SA 872 C	BCY 97.
2 SA 893 D	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		500 b)	T092	2 SA 872 D	BCX 30
2 SA 893 E	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		800 b)	T092	2 SA 872 E	D 34 J 9
2 SA 893 F	Si	PNP	0,300	0,050	90	120		1200 b)	T092	2 SA 872 F	2 SA 893 E
2 SA 896	Si	PNP	0,750	0,100	150	70		150	R195	2 SA 912	BFW 44
2 SA 897	Si	PNP	0,950	2	50	55	100		B2	MM 3726	MM 5005
2 SA 898	Si	PNP	1	0,050	120	100	150		B5	2 SA 848	2 N 5680
2 SA 899	Si	PNP	1	0,050	150	100	150		B5	2 SA 849	2 N 4929
2 SA 900	Si	PNP	4	2	18	150	90	450	T0126	BD 506	MC 328
2 SA 906	Si	PNP	0,200	0,100	40	100	250		T092	BD 257 B	BC 307 B

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SA 911	Si	PNP	0,470	0,100	550	9	30		T039		
2 SA 912	Si	PNP	0,750	0,100	150	200		150	R182	2 SA 712	BFW 44
2 SA 913	Si	PNP	15	1,5	150	120	65	330	B26	2 SA 740	2 SB 628
2 SA 917	Si	PNP	0,750	0,100	120	70		150	R195	2 N 3495	2 N 3495 S
2 SA 920	Si	PNP	0,950	0,500	200	40	70		B2		BFX 91
2 SA 924	Si	PNP	0,500	0,100	30	120	100		T092	BC 558 A	BC 558 B
2 SA 927	Si	PNP	0,500	0,250	40	220		100	R219	BSV 44 B	BSV 44 A
2 SA 931	Si	PNP	0,450	0,050	120	70		35	R179	2 SA 857	2 N 3495
2 SA 932	Si	PNP	0,450	0,050	150	70		35	R179	2 SA 858	2 N 4888
2 SA 940	Si	PNP	1,5	1,5	150	4		75	T0220	TIP 508	BFT 19
2 SA 950	Si	PNP	0,600	0,800	25	120		320	T092	2 SA 890	BC 328-5
2 SA 956 H 3	Si	PNP	0,150	0,100	40	280	80		X156	2 SA 812 M 3	BCX 71-BG
2 SA 956 H 4	Si	PNP	0,150	0,100	40	280	110		X156	2 SA 812 M 4	BCX 71-H
2 SA 956 H 5	Si	PNP	0,150	0,100	40	280	150		X156	2 SA 812 M 5	BCX 71-J
2 SA 956 H 6	Si	PNP	0,150	0,100	40	280	200		X156	2 SA 812 M 6	BCX 71-K
2 SB 16 A	Ge	PNP	1,8	0,600	20 (Vcb)		20	50	R57	BD 506 silicium	MC 328 silicium
2 SB 17 A	Ge	PNP	1,8	0,600	40 (Vcb)		20	50	R57	BC 160 silicium	BFS 95 silicium
2 SB 18 A	Ge	PNP	1,8	0,600	80 (Vcb)		20	50	R57	2 N 6555 silicium	2 N 4404 silicium
2 SB 19	Ge	PNP	5,5	2,5	16 (Vcb)		20	250	R58	2 N 255	2 N 255 A
2 SB 20	Ge	PNP	5,5	2,5	32 (Vcb)		20	250	R58	AD 148	AD 162
2 SB 21	Ge	PNP	5,5	2,5	60 (Vcb)		20	250	R58	2 N 1504/10	AD 263
2 SB 22	Ge	PNP	0,170	0,075	25 (Vcb)			95	T01	2 N 402	2 N 612
2 SB 23	Ge	PNP	0,040	0,010	15 (Vcb)				T01	2 N 1787	2 N 1754
2 SB 24	Ge	PNP	0,040	0,010	15 (Vcb)				R069	2 N 1787	2 N 1754
2 SB 25	Ge	PNP	20	1,5	60	250	34	115	T03	2 N 296	MPSU 55 silicium
2 SB 26	Ge	PNP	20	1,5	32	250	34	115	T03	2 N 301	2 N 301 A
2 SB 26 A	Ge	PNP	20	3	45		34	115	T03	2 N 1359	2 N 1360
2 SB 27	Ge	PNP		0,500	15	7	18	46	T03	AC 188-01	2 N 2826
2 SB 28	Ge	PNP		0,500	15	7	35	96	T03	AC 188-01	2 N 2826
2 SB 29	Ge	PNP		0,500	15	7	72	186	T03	AC 188-01	2 N 2826
2 SB 30	Ge	PNP		0,500	15 (Vcb)	7	68		T03	AC 188-01	2 N 2826
2 SB 31	Ge	PNP		0,500	15 (Vcb)	7	115		T03	AC 188-01	2 N 2826
2 SB 32	Ge	PNP	0,150	0,050	20 (Vcb)	0,800		40	T01	SK 3003	2 N 520 A

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 33	Ge	PNP	0,150	0,050	20 (Vcb)	1		80	T01	SK 3003	2 SB 364
2 SB 34	Ge	PNP	0,250	0,150	20 (Vcb)	0,800		85	T07	2 N 1370	2 N 1374
2 SB 37	Ge	PNP	0,150	0,050	20	1		80	T01	SK 3003	2 N 520 A
2 SB 38	Ge	PNP	0,250	0,150	20	0,800		85	T07	2 N 1370	2 N 1374
2 SB 39	Ge	PNP	0,050	0,002	10 (Vcb)	0,850		65	T01	2 N 486	2 N 485
2 SB 40	Ge	PNP	0,080	0,100	30	1		100	T01	2 N 2614	2 N 602 A
2 SB 41	Ge	PNP	44	1,2	32	0,005	35	160	T03	2 N 257	2 N 301 A
2 SB 42	Ge	PNP	44	1,2	50	0,005	35	160	T03	2 N 257 G	2 N 296
2 SB 43 a)	Ge	PNP		0,050	25 (Vcb)	1		70	T01	2 N 3284	AC 151
2 SB 43 A	Ge	PNP	0,150	0,150	45	1		70	T01	MA 891	MA 892
2 SB 44	Ge	PNP	0,080	0,050	30 (Vcb)	1		110	T01	2 N 367	SK 3006
2 SB 46	Ge	PNP	0,080	0,050	25	1		175	T01	2 N 3283	2 N 3284
2 SB 47	Ge	PNP	0,080	0,050	25 (Vcb)	1		140	T01	2 N 3283	2 N 3284
2 SB 48	Ge	PNP	0,140	0,100	16 (Vcb)	2,5		42	T05	2 N 1145	2 N 1144
2 SB 49	Ge	PNP	0,140	0,100	16 (Vcb)	3		83	T05	2 N 1098	2 N 1097
2 SB 50	Ge	PNP	0,140	0,100	16 (Vcb)	3,5		131	T05	2 N 1144	2 N 1097
2 SB 51	Ge	PNP	0,200	0,200	30 (Vcb)	2		43	T05	2 N 1145	2 N 1144
2 SB 52	Ge	PNP	0,200	0,200	30 (Vcb)	3		83	T05	2 N 1707	AC 182
2 SB 53	Ge	PNP	0,200	0,250	30 (Vcb)	3		73	T05	2 N 1707	AC 182
2 SB 54	Ge	PNP	0,150	0,150	20	1		140	T01	2 N 827	2 N 1361
2 SB 55	Ge	PNP	0,150	0,150	60	1		80	T01	2 N.2190	2 N 1408
2 SB 56	Ge	PNP	0,150	0,150	25	1		80	T01	2 SB 136	AC 151 R
2 SB 56 A	Ge	PNP	0,150	0,150	45	1		80	T01	2 N 1285	ASZ 20
2 SB 57	Ge	PNP	0,100	0,100	30 (Vcb)	1		65	R55	2 SB 135	AFY 16
2 SB 59	Ge	PNP	0,150	0,100	20	1		70	T01	2 N 1361	2 N 827
2 SB 60	Ge	PNP	0,150	0,050	20 (Vcb)	1		65	T01	2 N 3400	2 N 741 A
2 SB 60 A	Ge	PNP	0,150	0,050	20	1		70	T01	2 N 1361	2 N 827
2 SB 61	Ge	PNP	0,150	0,050	30 (Vcb)	1		85	T01	2 SB 135	AFY 16
2 SB 62	Ge	PNP	4	0,500	60	0,200	30	125	MD10	AUY 10	
2 SB 63	Ge	PNP	4	0,500	32	0,200	30	125	MD10	2 SB 180	AC 128 K
2 SB 64	Ge	PNP	25	6	100	1	30	165	T03	BD 540 C	2 SB 342
2 SB 65	Ge	PNP	0,150	0,100	20	1		65	T01	^{silicium} 2 N 1361	2 N 827
2 SB 66	Ge	PNP	0,150	0,070	30 (Vcb)	1,5		70	T01	2 SB 135	AFY 16

•Pc = Puissance collecteur max.
 •Ic = Courant collecteur max.
 •Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 •Fmax = Fréquence max.

•Ge = Germanium
 •Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 67	Ge	PNP	0,350	0,150	55 (Vcb)	1		45	T01	2 SB 67 A	ACY 18
2 SB 67 A	Ge	PNP	0,350	0,150	60 (Vcb)	1		45	T01	2 SB 67	ACY 17
2 SB 67 AH	Ge	PNP	0,200	0,030	30	BF	50		T07	2 SB 67 H	2 N 2207
2 SB 67 H	Ge	PNP	0,200	0,030	30	BF	50		T07	2 SB 67 AH	2 N 2207
2 SB 68	Ge	PNP	0,050	0,100	105 (Vcb)	0,500		60	T05	2 SB 121	2 N 1670
2 SB 69	Ge	PNP	25	6	60	1	30	165	T03	AUY 28	2 N 1666
2 SB 73	Ge	PNP	0,020	0,002	10 (Vcb)	BF		80	T01	2 SB 302	2 N 220
2 SB 74	Ge	PNP	0,080	0,015	16 (Vcb)	BF		48	T01	2 N 219	2 N 583
2 SB 75	Ge	PNP	0,150	0,100	25	2		55	T01	2 N 404 A	2 N 1404
2 SB 75 A	Ge	PNP	0,150	0,100	45	2		55	T01	2 N 1371	2 N 1375
2 SB 75 AH	Ge	PNP	0,150	0,100	45	1,2		55	T01	2 N 1371	2 N 1375
2 SB 75 H	Ge	PNP	0,150	0,100	30 (Vcb)	1,2		55	T01	2 N 565	OC 75
2 SB 76	Ge	PNP	0,150	0,070	12 (Vcb)	BF		55	T01	2 N 1346	2 N 1301
2 SB 77	Ge	PNP	0,150	0,100	25	2		70	T01	2 N 404 A	2 N 1404
2 SB 77 A	Ge	PNP	0,150	0,100	45	2		70	T01	2 N 1371	2 N 1375
2 SB 77 AH	Ge	PNP	0,150	0,100	30	1,5		70	T01	AC 125	AC 126
2 SB 77 H	Ge	PNP	0,150	0,100	30	1,5		70	T01	AC 125	AC 126
2 SB 78	Ge	PNP	0,150	0,070	12 (Vcb)	BF		70	T01	2 N 1346	2 N 1301
2 SB 80	Ge	PNP	4	1	25 (Vcb)	BF		60	T03	2 SB 367	AD 152
2 SB 81	Ge	PNP	2	0,500	60	BF		60	T03	2 SB 82	BD 138
2 SB 82	Ge	PNP	2	0,500	60	BF		65	T03	2 SB 81	^{silicium} BD 138
2 SB 83	Ge	PNP	12	3	40 (Vcb)	BF			T03	2 N 2063	2 N 2064
2 SB 84	Ge	PNP	12	3	60 (Vcb)	BF			T03	2 N 3023	TIP 32 A
2 SB 89	Ge	PNP	0,250	0,150	25	BF		55	T07	^{silicium} 2 N 1274	2 N 1370
2 SB 89 A	Ge	PNP	0,250	0,150	45 (Vcb)	BF		65	R27	2 N 1371	2 N 1373
2 SB 89 AH	Ge	PNP	0,250	0,150	45	1,5		60	T07	2 N 1375	2 N 1376
2 SB 89 H	Ge	PNP	0,250	0,150	30	1,5		60	T07	2 SB 377	2 N 2706
2 SB 90	Ge	PNP	0,040	0,005	18 (Vcb)	BF			T024	2 SA 285	2 SA 322
2 SB 91	Ge	PNP	0,040	0,030	18 (Vcb)	BF		70	T024	2 N 1742	AF 106
2 SB 94	Ge	PNP	0,150	0,050	25 (Vcb)	BF		80	T09	2 N 1094	2 N 2428
2 SB 97	Ge	PNP	0,040	0,005	18 (Vcb)	1		70	T024	2 SA 285	2 SA 322
2 SB 98	Ge	PNP	0,125	0,050	30 (Vcb)	1,5		120	T05	OC 70	OC 71
2 SB 100	Ge	PNP	0,100	0,050	30 (Vcb)	1,2		60	T05	2 N 3283	2 N 367

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 101	Ge	PNP	0,125	0,050	30 (Vcb)	1,2		60	T05		
2 SB 107	Ge	PNP	10	2	30 (Vcb)	0,5	20	120	T08	SK 3082	SK 3086
2 SB 107 A	Ge	PNP	10	2	60 (Vcb)	0,400	20	120	T03	2 N 1084 <small>silicium</small>	2 N 2881 <small>silicium</small>
2 SB 110	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1	30		T01	2 SB 115	2 SB 117
2 SB 111	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1	45		T01	2 SB 115	2 SB 117
2 SB 112	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1	60		T01	2 SB 115	2 SB 117
2 SB 113	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1	80		T01	2 SB 115	2 SB 117
2 SB 115	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1,5		85	T01	2 N 2273	2 N 582
2 SB 116	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1,5		110	T01	2 SA 538	40329
2 SB 117	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	1,5		140	T01	2 SB 486	2 N 3127
2 SB 120	Ge	PNP	0,125	0,020	32 (Vcb)	0,700		70	T01	2 SB 66 H	AF Y 16
2 SB 121	Ge	PNP	0,050	0,100	25 (Vcc)	0,500		60	T01	2 SB 68	2 N 398
2 SB 122	Ge	PNP	20	1,5	80 (Vcb)	BF		60	T03		2 N 296
2 SB 124	Ge	PNP	40	15	60	BF		70	MS1	2 N 174	2 N 173
2 SB 125	Ge	PNP	40	15	36	BF		70	MS1		SDT 3850 <small>silicium</small>
2 SB 126	Ge	PNP		3,5	16	BF	15	50	T03	2 SB 127	BD 330 <small>silicium</small>
2 SB 126 A	Ge	PNP	30	3,5	60 (Vcb)	0,006	15	50	T03	2 SB 127 A	2 N 1501
2 SB 127	Ge	PNP		3,5	16	BF	26	100	T03	2 SB 126	2 N 255 A
2 SB 127 A	Ge	PNP	30	3,5	60 (Vcb)	0,006	34	100	T03	2 SB 126 A	2 N 1501
2 SB 128	Ge	PNP		6	40	BF	16	36	T03	2 SB 129	2 N 1667
2 SB 128 A	Ge	PNP		6	60	BF	16	36	T03	2 N 1669	2 N 1906
2 SB 129	Ge	PNP		6	40	BF	30	80	T03	2 SB 128	2 N 1668
2 SB 130	Ge	PNP		1,5	16		20		F7	2 N 2064	OC 19
2 SB 131	Ge	PNP	65	1,5	32	0,005	35	160	T03	2 SB 41	AD 139
2 SB 131 A	Ge	PNP	65	8	32	0,005	40	160	T03	2 N 251 A	MP 2061
2 SB 132	Ge	PNP	65	1,5	50	0,005	35	160	T03		2 N 1172
2 SB 132 A	Ge	PNP	65	8	50	0,005	40	160	T03	2 N 2292	MP 2062
2 SB 134	Ge	PNP	0,100	0,050	30	0,800		70	T01	2 SB 135	AC 151 V
2 SB 135	Ge	PNP	0,100	0,050	30	0,800		70	T01	2 SB 134	AC 151 V
2 SB 136	Ge	PNP	0,150	0,150	25	0,800		120	T01	2 N 1404	AC 151 VII
2 SA 136 A	Ge	PNP	0,150	0,300	40	0,800		120	T01	2 N 404 A	HEP 636
2 SB 137	Ge	PNP	30	5	25	0,400	30	250	T03	2 N 1529 A	MP 1545
2 SB 138	Ge	PNP	30	5	35	0,400	30	250	T03	2 N 1534 A	2 N 297 A

• Pc = Puissance collecteur max.
 • Ic = Courant collecteur max.
 • Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 • Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 138 A	Ge	PNP	30	5	40	0,400	30	250	T03	AD 166	2 N 1530 A
2 SB 138 B	Ge	PNP	30	5	60	0,400	30	250	T03	2 N 1531 A	AD 167
2 SB 140	Ge	PNP	35	1,5	40	0,007	62	89	T03	BD 562 silicium	2 N 3205 silicium
2 SB 141	Ge	PNP	35	1,5	60	0,007	62	89	T03	2 SB 147	2 N 3206 silicium
2 SB 142	Ge	PNP	10	1	30	0,007	12	31	T03	2 SB 143	BD 508 silicium
2 SB 143	Ge	PNP	10	1	30	0,007	23	59	T03	2 SB 144	BD 508 silicium
2 SB 144	Ge	PNP	10	1	30	0,007	45	119	T03	2 SB 145	BD 508 silicium
2 SB 145	Ge	PNP	10	1	30 (Vcb)	7	37		T03	2 SB 146	BD 508 silicium
2 SB 146	Ge	PNP	10	1	30 (Vcb)	7	75		T03	2 SB 145	BD 508 silicium
2 SB 147	Ge	PNP	35	1,5	60	0,007	28	119	T03	2 SB 141	BD 508 silicium
2 SB 148	Ge	PNP	40	15	80 (Vcb)	BF	70		MS1		2 N 1120
2 SB 149	Ge	PNP	25	8	20	0,250	60	115	T03		2 N 627
2 SB 150	Ge	PNP	0,050	0,040	40	0,500		35	T01	TRM 34	2 N 506
2 SB 151	Ge	PNP	50	5	60	0,005	30	75	T03	2 N 457	AD 138/50
2 SB 152	Ge	PNP	50	5	80	0,005	30	75	T03	2 N 458	2 N 379
2 SB 155	Ge	PNP	0,150	0,300	16 (Vcb)	BF		30	T01	AC 121 IV	40396/P
2 SB 156	Ge	PNP	0,150	0,300	16 (Vcb)	BF		45	T01	AC 121 IV	40396/P
2 SB 156 A	Ge	PNP	0,150	0,300	20 (Vcb)	BF		45	T01	AC 121 IV	AC 121 IV
2 SB 167	Ge	PNP	0,200	0,500	20	1,2		80	T01	AC 121 V	AC 121 IV
2 SB 168	Ge	PNP	0,150	0,100	9 (Vcb)	0,800		60	T01	2 N 983	2 N 984
2 SB 169	Ge	PNP	0,150	0,100	9 (Vcb)	1		85	T01	2 N 983	2 N 984
2 SB 170	Ge	PNP	0,125	0,010	30 (Vcb)	0,300		30	T01	2 SB 171	AC 151 IV
2 SB 171	Ge	PNP	0,125	0,010	30 (Vcb)	0,5		50	T01	2 SB 170	AC 151 IV
2 SB 172	Ge	PNP	0,125	0,125	32 (Vcb)	1		50	T01	AC 151 IV	AC 151 V
2 SB 173	Ge	PNP	0,125	0,010	20 (Vcb)	0,500		50	T01	AC 121 IV	AC 121 V
2 SB 175	Ge	PNP		0,010	30 (Vcb)	0,600		90	T01	AC 151 VI	AC 122
2 SB 176	Ge	PNP	0,125	0,125	32 (Vcb)	100		100	T01	AC 151 V	AC 131
2 SB 177	Ge	PNP	0,125	0,125	60 (Vcb)	0,9		65	T01	OC 77	2 N 1408
2 SB 178	Ge	PNP	0,225	0,300	20 (Vcb)			65	R43	AC 121 V	AC 152 IV
2 SB 178 A	Ge	PNP	0,225	0,300	40 (Vcb)			65	R43	2 N 1125	2 N 1124
2 SB 180	Ge	PNP	5,5	0,500	30	BF	20	150	T08	2 SB 466	2 SB 181
2 SB 180 A	Ge	PNP	5,5	0,500	40	BF	20	150	T08	2 SB 467	2 SB 181 A
2 SB 181	Ge	PNP	12	0,500	30	0,013	35		T08	2 SB 466	2 SB 63

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 181 A	Ge	PNP	12	0,500	40	0,013	25	150	T08	2 SB 467	2 SB 180 A
2 SB 183	Ge	PNP	0,050	0,020	12 (Vcb)	BF			T081	2 SB 184	2 N 1785
2 SB 184	Ge	PNP	0,050	0,020	12 (Vcb)	BF			T081	2 SB 183	2 N 1786
2 SB 185	Ge	PNP	0,150	0,050	25 (Vcb)	BF		45	T01	2 N 1094	2 N 2428
2 SB 186	Ge	PNP	0,150	0,050	25 (Vcb)	BF		170	T01	2 N 1094	2 N 2428
2 SB 187	Ge	PNP	0,150	0,050	25 (Vcb)	BF		100	T01	2 N 1094	2 N 2428
2 SB 188	Ge	PNP	0,150	0,050	25 (Vcb)	BF			T01	2 N 1094	2 N 2428
2 SB 189	Ge	PNP	0,250	0,250	25 (Vcb)	1		70	X5	AC 151 V	AC 117
2 SB 199	Ge	PNP	0,250	0,300	12 (Vcb)	0,800		90	T07	2 N 1378	2 N 1273
2 SB 200 c)	Ge	PNP	0,250	0,400	32	0,500	30	150	R10	ACY 17	AC 124
2 SB 200 A c)	Ge	PNP	0,250	0,400	45	0,500	30	150	R10	ACY 39	AC 153 V
2 SB 201	Ge	PNP	0,300	0,400	35	0,500		60	T05	2 N 1125	2 N 2374
2 SB 202 i)	Ge	PNP	16	30	75	BF		100	T03		2 SB 206
2 SB 202 ii)	Ge	PNP	0,225	0,400	32 (Vcb)	BF		140	T09	AC Y 17	AC 124
2 SB 203	Ge	PNP	80	20	40 (Vcb)	BF	20	40	F10	2 SB 209	2 N 514
2 SB 204	Ge	PNP	80	30	40 (Vcb)	BF	50	100	F10	2 SB 210	2 N 514
2 SB 205	Ge	PNP	80	20	80 (Vcb)	BF	20	40	F10	2 SB 211	2 SB 430
2 SB 206	Ge	PNP	80	30	80 (Vcb)	BF	50	100	F10	2 SB 212	2 N 514 B
2 SB 207	Ge	PNP	80	20	100 (Vcb)	BF	20	40	F10	2 SB 213	2 N 2691
2 SB 207 A	Ge	PNP	80	20	140 (Vcb)	BF	20	40	F10	2 SB 213 A	2 N 2834
2 SB 208	Ge	PNP	80	30	100 (Vcb)	BF	50	100	F106	2 SB 214	2 N 1166
2 SB 208 A	Ge	PNP	80	30	140 (Vcb)	BF	50	100	F10	2 SB 214 A	
2 SB 209	Ge	PNP	80	20	40 (Vcb)	0,0025	20	40	F10	2 SB 203	2 N 514
2 SB 210	Ge	PNP	80	30	40 (Vcb)	0,0025	50	100	F10	2 SB 204	2 N 514
2 SB 211	Ge	PNP	80	20	80 (Vcb)	0,0025	20	40	F10	2 SB 205	2 SB 430
2 SB 212	Ge	PNP	80	30	80 (Vcb)	0,0025	50	100	F10	2 SB 206	2 N 514 B
2 SB 213	Ge	PNP	80	20	100 (Vcb)	0,0025	20	40	F10	2 SB 207	2 N 2691
2 SB 213 A	Ge	PNP	80	20	140 (Vcb)	0,0025	20	40	F10	2 SB 207 A	2 N 2834
2 SB 214	Ge	PNP	80	30	100 (Vcb)	0,0025	50	100	F10	2 SB 208	2 N 1166
2 SB 214 A	Ge	PNP	80	30	140 (Vcb)	0,0025	50	100	F10	2 SB 208 A	
2 SB 215	Ge	PNP		3	100 (Vcb)	BF	20	200	T03	2 N 2283	AD 163
2 SB 216	Ge	PNP		1,5	60 (Vcb)	BF	25	200	T03	2 N 301 A	AD 131
2 SB 217	Ge	PNP		1,5	20 (Vcb)	BF	25	200	T03	2 N 2062	AD 150

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 218	Ge	PNP	0,225	0,500	40	2		50	T05	2 N 1924	2 N 1925
2 SB 220	Ge	PNP	0,225	0,200	25	1,5		50	T05	AC 184	2 N 1447
2 SB 221	Ge	PNP	0,225	0,200	25	2		72	T05	AC 184	2 N 1448
2 SB 222	Ge	PNP	0,225	0,200	25	2,5		97	T05	AC 184	2 N 1175 A
2 SB 223	Ge	PNP	0,225	0,200	25	3		150	T05	AC 184	2 N 3427
2 SB 225	Ge	PNP	0,225	0,500	30	2,5		53	T05	2 N 525 A	ACY 18
2 SV 226	Ge	PNP	0,225	0,500	30	3		73	T05	2 N 526 A	ACY 17
2 SB 227	Ge	PNP	0,225	0,500	30	3,3		91	T05	2 N 527 A	ACY 19
2 SB 228	Ge	PNP	12	5	35	BF			T03	40022	2 N 3215
2 SB 229	Ge	PNP	12	5	40	BF			T03	2 N 3214	40050
2 SB 230	Ge	PNP	12	5	50	BF			T03	SK 3014	SK 3015
2 SB 231	Ge	PNP	25	6	120 (Vcb)	BF		50	T03	2 SB 342	2 N 1073 B
2 SB 234	Ge	PNP		1,5	180 (Vcb)	BF	15		T03	RCA 1 E 03 silicium	2 SB 630
2 SB 235 5c	Ge	PNP	60	15	80	0,200	25	200	T036	2 N 1358	2 N 3147
2 SB 236 5c	Ge	PNP	60	15	60	0,200	25	200	T036	2 SB 354	2 N 1538 A
2 SB 237 5c	Ge	PNP	60	15	36	0,200	25	200	T036	2 SB 352	2 N 1559
2 SB 239	Ge	PNP	13	1	45	0,500	30	90	T08	BD 227 silicium	BD 166 silicium
2 SB 239 A	Ge	PNP	13	1	50	0,500	30	90	T08	2 N 1658/13	
2 SB 240	Ge	PNP	13	1	30	0,500	30	90	T08	2 N 2835	2 N 141/13
2 SB 240 A	Ge	PNP	13	1	40	0,500	30	90	T08	2 N 1659/13	TIP 30 silicium
2 SB 241	Ge	PNP	13	1	45	0,500	30	90	T08	BD 227 silicium	BD 166 silicium
2 SB 241 A	Ge	PNP	13	1	50	0,500	30	90	T08	2 N 1658/13	
2 SB 242	Ge	PNP	13	1	20	0,500	20	60	T08		2 N 4078
2 SB 242 A	Ge	PNP	13	1	30	0,500	20	60	T08	2 N 2835	2 N 141/13
2 SB 243	Ge	PNP	13	1	20	0,500	40	150	T08		2 N 4078
2 SB 243 A	Ge	PNP	13	1	30	0,500	40	150	T08	2 N 2835	2 N 141/13
2 SB 244	Ge	PNP	13	1	40	0,500	20	60	T08	2 N 1659/13	TIP 30 silicium
2 SB 245	Ge	PNP	13	1	40	0,500	40	150	T08	2 N 1659/13	TIP 30 silicium
2 SB 247	Ge	PNP	54	5	35	0,350	40	80	T03	2 N 6312 silicium	2 N 1541 A
2 SB 248	Ge	PNP	54	5	25	0,350	40	80	T03	2 N 1540 A	2 N 1539 A
2 SB 248 A	Ge	PNP	54	5	35	0,350	40	80	T03	2 N 6312 silicium	2 N 1541 A
2 SB 249	Ge	PNP	54	5	40	0,350	40	80	T03	2 N 6312 silicium	2 N 1541 A
2 SB 250	Ge	PNP	54	5	20	0,350	20	60	T03	2 N 1534	2 N 1539 A

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 250 A	Ge	PNP	54	5	40	0,350	20	60	T03	2 N 3183 silicium	2 N 1535
2 SB 251	Ge	PNP	54	5	20	0,350	40	150	T03	2 N 1539 A	2 N 1544 A
2 SB 251 A	Ge	PNP	54	5	40	0,350	40	150	T03	2 N 6312 silicium	2 N 1541 A
2 SB 252	Ge	PNP	54	5	50	0,350	20	60	T03	2 N 3184 silicium	2 N 1542 A
2 SB 252 A	Ge	PNP	54	5	80	0,350	20	60	T03	2 N 3185 silicium	2 N 1532
2 SB 253	Ge	PNP	54	5	50	0,350	40	150	T03	2 N 6313 silicium	2 N 1542 A
2 SB 253 A	Ge	PNP	54	5	80	0,350	40	150	T03	2 N 6314 silicium	2 N 1532
2 SB 254	Ge	PNP		0,600	35 (Vcb)	BF	50	250	MD10	2 SB 63	2 SB 180
2 SB 255	Ge	PNP		0,600	35 (Vcb)		30	120	MD10	2 SB 63	2 SB 180
2 SB 256	Ge	PNP		0,600	35 (Vcb)		30	250	MD10	2 SB 63	2 SB 180
2 SB 257	Ge	PNP	0,060	0,005	18 (Vcb)	5		125	T01	AFY 12	2 N 1743
2 SB 258	Ge	PNP	60	15	115	1,500	38	280	T036	2 N 5155	2 N 2212
2 SB 259	Ge	PNP	60	15	75	1,500	25	120	T036	2 N 1358	2 N 3147
2 SB 260	Ge	PNP	60	15	45	1,500	25	120	T036	JAN 2 N 1358	2 N 1560
2 SB 261	Ge	PNP	0,065	0,030	15	2,500		45	R18	OC 45 N	OC 42 N
2 SB 262	Ge	PNP	0,065	0,030	15	3		90	R18	OC 42 N	OC 45 N
2 SB 263	Ge	PNP	0,200	0,150	18	1,500		60	T01	AF 124 à	AF 127
2 SB 264	Ge	PNP	0,070	0,050	25 (Vcb)	1		65	T01	2 N 2273	2 N 3283
2 SB 265	Ge	PNP	0,170	0,100	30	1,300		100	T05	2 N 633	AC 128
2 SB 266	Ge	PNP	0,150	0,150	25 (Vcb)	1,300		67	T01	2 N 404	ASY 27
2 SB 267	Ge	PNP	0,150	0,150	25 (Vcb)	1,300		70	T01	2 N 404	ASY 27
2 SB 269	Ge	PNP	0,150	0,150	25 (Vcb)	1,300		67	T01	2 N 404	ASY 27
2 SB 271	Ge	PNP	0,600		25 (Vcb)	BF		80	T01	MPS 6562 silicium	MPS 6563 silicium
2 SB 272	Ge	PNP	0,600		25 (Vcb)	BF		200	T01	BSV 45 B silicium	BSV 45 A silicium
2 SB 273	Ge	PNP	0,600		25 (Vcb)	BF		150	T01	BSV 45 B silicium	BSV 45 A silicium
2 SB 274	Ge	PNP	12	6	40	BF		50	T03	AL 113	2 N 1905
2 SB 275	Ge	PNP	12	6	105	BF		40	T03	2 SB 64	40872 silicium
2 SB 276	Ge	PNP	50	10	105	BF		35	T03	2 N 1430	AU 101
2 SB 282	Ge	PNP	30	6	60	0,250	15	30	T03	2 N 1666	ASZ 15
2 SB 283	Ge	PNP	30	6	48	0,250	35	80	T03	2 SB 391	ASZ 16
2 SB 284	Ge	PNP	30	6	48	0,250	20	45	T03	2 SB 391	ASZ 17
2 SB 285	Ge	PNP	30	6	60	0,250	20	65	T03	2 N 1666	ASZ 18
2 SB 290	Ge	PNP	0,065	0,040	18 (Vcb)	5		125	T05	AC 122	2 N 2168

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 291	Ge	PNP	0,150	0,150	25	1		100	T05	AC 151	ASY 26
2 SB 292	Ge	PNP	0,150	0,150	25	1		80	T05	AC 151	ASY 26
2 SB 292 A	Ge	PNP	0,150	0,150	60	1		80	T05	2 N 284 A	OC 77
2 SB 293	Ge	PNP	0,150	0,250	13	1,200		70	T01	2 N 1097	2 N 1098
2 SB 294	Ge	PNP	0,150	0,250	13	1,200		36	T01	2 N 1097	2 N 1098
2 SB 295	Ge	PNP	40	5	65	0,045	30	120	T03	2 N 1014	2 N 457
2 SB 296	Ge	PNP	35	10	130 (Vcb)	1,500		50	T03	2 N 1046 A	2 N 1046 B
2 SB 299	Ge	PNP	0,150			1,300		65	T01	SK 3003	AC 151
2 SB 300	Ge	PNP	35	10	100	BF	30	200	T03	2 N 1430	2 N 5738 silicium
2 SB 301	Ge	PNP	35	10	60	BF	30	200	T03	2 N 2869	2 N 2870
2 SB 302	Ge	PNP	0,040	0,002	10 (Vcb)	12		80	T01	2 SA 216	2 N 220
2 SB 303	Ge	PNP	0,050	0,020	30 (Vcb)	BF			T01	2 N 1867	2 N 591
2 SB 304	Ge	PNP	0,225	0,500	20	1		70	T05	AC 184	2 N 599
2 SB 304 A	Ge	PNP	0,225	0,500	30	1		70	T05	AC 184	2 N 524 A
2 SB 306	Ge	PNP	0,075	0,020	105 (Vcb)	0,900		50	T05	2 N 1670	2 N 398 A
2 SB 309	Ge	PNP	43	8	75 (Vcb)	0,017	30	125	T03	BDX 78 silicium	BDX 94 silicium
2 SB 310	Ge	PNP	43	8	140 (Vcb)	0,017	30	125	T03	TIP 519 silicium	TIP 520 silicium
2 SB 311	Ge	PNP	50	10	180 (Vcb)	0,017	30	125	T03	TIP 527 silicium	TIP 528 silicium
2 SB 318	Ge	PNP	50	5	40	2	40	200	T03	2 N 6124 silicium	BD 540 silicium
2 SB 319	Ge	PNP	50	5	60	3	40	200	T03	2 N 5613 silicium	BD 540 A silicium
2 SB 320	Ge	PNP	50	10	60	2	40	200	T03	2 N 5737 silicium	BD 706 silicium
2 SB 321	Ge	PNP	0,040	0,050	12 (Vcb)	6		100	R68	2 N 1752	2 N 501
2 SB 322	Ge	PNP	0,040	0,050	12 (Vcb)	6		50	R68	2 N 1752	2 N 501
2 SB 323	Ge	PNP	0,040	0,050	12 (Vcb)	6		100	R68	2 N 1752	2 N 501
2 SB 324	Ge	PNP	0,200	0,500	32 (Vcb)	1,500		90	T01	2 N 1316	2 N 1018
2 SB 325	Ge	PNP	1,8	0,600	100	BF	20	250	R57	2 N 6556 silicium	MM 5007 silicium
2 SB 326	Ge	PNP	0,225	0,500	30 (Vcb)	1		65	T05	AC 184	2 N 599
2 SB 327	Ge	PNP	0,225	0,500	30 (Vcb)	1		110	T05	AC 184	2 N 524 A
2 SB 328	Ge	PNP	0,150	0,300	15 (Vcb)	BF		80	T01	2 N 1344	ASY 57 N
2 SB 329	Ge	PNP	0,150	0,300	15 (Vcb)	BF		150	T01	2 N 1344	ASY 57 N
2 SB 330	Ge	PNP	0,225	0,150	110 (Vcb)	BF		35	T05	ACY 39	2 N 398 B
2 SB 331 5c)	Ge	PNP	80	15	25	0,350		65	T036	2 N 1554	2 N 1554 A
2 SB 331 H	Ge	PNP	14	T. recouv.	8 ns	0,350	20		T036		2 N 4048

5c) Commutation de puissance.

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 332 5c	Ge	PNP	80	15	45	BF		65	T036	2 N 1555	2 N 1555 A
2 SB 332 H	Ge	PNP	14	T. recouv. 8 ns		0,350	20		T036		2 N 4049
2 SB 333 5c	Ge	PNP	80	15	55	BF		60	T036	2 N 1556	2 N 1556 A
2 SB 333 H	Ge	PNP		T. recouv. 8 ns		0,350	25		T036		2 N 4050
2 SB 334 5c	Ge	PNP	80	15	60	BF		35	T036	2 N 1358 A	2 N 2210
2 SB 334 H	Ge	PNP		T. recouv. 8 ns		0,350	25		T036		2 N 4051
2 SB 335	Ge	PNP	0,083	0,060	20 (Vcb)	1		70	R18	OC 46	2 N 1517
2 SB 336	Ge	PNP	0,083	0,060	20 (Vcb)	1		80	R18	OC 47	2 N 1517
2 SB 337 5c	Ge	PNP	12	7	30	0,300	50	165	T03	2 N 457 A	HEP 623
2 SB 337 H	Ge	PNP	12	T. recouv. 8 ns		0,300		100	T03		2 N 637
2 SB 338 5c	Ge	PNP	12	7	30	0,250	50		F13	2 N 457 A	HEP 624
2 SB 338 H	Ge	PNP	12	T. recouv. 8 ns		0,300		100	T03		2 N 638
2 SB 339 5c	Ge	PNP	12	10	35	0,250	35		F13	AD 143	2 SB 338
2 SB 339 H	Ge	PNP	12	T. recouv. 8 ns		300		45	T03	2 SB 340 H	2 SB 341 H
2 SB 340 5c	Ge	PNP	12	10	40	0,250	35		F13	2 N 1073	SK 3009
2 SB 340 H	Ge	PNP	12	T. recouv. 8 ns		300		45	T03	2 SB 339 H	2 SB 341 H
2 SB 341 5c	Ge	PNP	12	10	50	0,250	35		F13	2 N 2292	2 N 2295
2 SB 341 H	Ge	PNP	12	T. recouv. 8 ns		300		45	T03	2 SB 339 H	2 SB 340 H
2 SB 342	Ge	PNP	30	6	120	1	25	250	T03	2 SB 231	2 N 1073 B
2 SB 343	Ge	PNP	30	6	150	1	25	250	T03		2 N 5324
2 SB 345	Ge	PNP	0,165	0,100	32 (Vcb)	0,017		125	T01	2 SB 346	OC 70
2 SB 346	Ge	PNP	0,165	0,100	32 (Vcb)	0,017		220	T01	AFY 18	2 SB 345
2 SB 347	Ge	PNP	0,500	0,100	32 (Vcb)	0,017		125	T01	2 SB 348	AC 122
2 SB 348	Ge	PNP	0,500	0,100	32 (Vcb)	0,017		180	T01	2 SB 347	AC 122
2 SB 349	Ge	PNP	0,050		20 (Vcb)	BF		150	T01	AF 115	AF 116
2 SB 350	Ge	PNP	0,150	0,050	25	BF		100	T01	2 SB 94	2 N 1129
2 SB 351	Ge	PNP	70	15	30	0,004	30	150	T036	2 N 1558	2 N 1558 A
2 SB 352	Ge	PNP	70	15	40	0,004	30	150	T036	2 N 1559	2 N 1559 A
2 SB 353	Ge	PNP	70	15	50	0,004	30	150	T036	2 N 1560	2 N 1560 A
2 SB 354	Ge	PNP	70	15	60	0,004	30	150	T036	2 N 1358 A	2 N 2612
2 SB 358	Ge	PNP	50	10	80	BF	10	100	T03	2 N 1073 A	2 N 6064
2 SB 359	Ge	PNP	50	10	120	BF	10	100	T03	2 N 1073 B	2 N 2290
2 SB 360	Ge	PNP	50	10	180	BF	10	100	T03	2 SB 411	2 N 5325

• Pc = Puissance collecteur max.
 • Ic = Courant collecteur max.
 • Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 • Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 361	Ge	PNP	12	5	40	0,050	90		F13	2 N 2148	SK 3014
2 SB 362	Ge	PNP	12	7	40	0,050	90		F13	AL 113	2 SB 338
2 SB 363	Ge	PNP	43	8	140 (Vcb)	BF		50	T03	2 N 1046 A	2 N 5155
2 SB 364 c)	Ge	PNP	0,150	0,400	20	1,2	60	150	T01	ASY 54 N	AC 125
2 SB 365 c)	Ge	PNP	0,150	0,400	20	1,2	35	90	T01	ASY 54 N	AC 125
2 SB 367	Ge	PNP	4	1	25	0,500	45	170	T066	AD 152	AC 180 K
2 SV 367 H	Ge	PNP	4	1	25	0,500	50	80	T066	AD 152	AC 180 K
2 SB 368	Ge	PNP	4	1	45	0,500	45	170	T066	2 N 1658/13	2 N 1659/13
2 SB 368 H	Ge	PNP	4	1	35	0,500	50	80	T066	2 SB 473	2 SB 481
2 SB 370	Ge	PNP	0,200	0,500	25	BF	70		T01	2 N 2171	2 N 1449
2 SB 370 A	Ge	PNP	0,200	0,500	32	BF	70		T01	2 N 1185	2 N 1190
2 SB 370 AH	Ge	PNP	0,200	0,500	32	1,4 GHz	70		T01	BFR 99 silicium	2 N 4260 silicium
2 SB 371	Ge	PNP	0,165	0,200	32 (Vcb)	2		125	T01	AC 132	AC 128
2 SB 372	Ge	PNP	1,5	1	25	BF		70	T05	AC 128 K	2 N 4106
2 SB 373	Ge	PNP	1,5	1	25	BF		150	T05	2 N 4106	AC 128 K
2 SB 374	Ge	PNP	1,5	1	60	BF		150	T05	2 N 3763 silicium	2 N 3762 silicium
2 SB 375	Ge	PNP	30	9	150	1	25	250	T03	TIP 519 silicium	TIP 520 silicium
2 SB 376	Ge	PNP	0,225	0,300	30	1		50	R43	OC 83 N	2 N 526
2 SB 377	Ge	PNP	0,270	0,150	30	1,4		134	T05	2 N 508 A	2 N 1189
2 SB 378	Ge	PNP	0,180	0,150	16	1,3		42	T05	2 N 611	2 N 1681
2 SB 378 A	Ge	PNP	0,270	0,300	23 (Vcb)	2,5		42		AC 121 IV	AC 121 V
2 SB 378 B	Ge	PNP	0,270	0,500	23 (Vcb)	2,5		42		AC 152 IV	AC 152 V
2 SB 379	Ge	PNP	0,180	0,150	16	1,5		84	T05	2 N 611	2 N 1681
2 SB 379 A	Ge	PNP	0,270	0,300	23 (Vcb)	3		84		AC 151r V	AC 151r VI
2 SB 379 B	Ge	PNP	0,270	0,500	23 (Vcb)	3		84		AC 152 V	AC 152 VI
2 SB 380	Ge	PNP	0,180	0,150	16	1,7		168	T05	2 N 611	2 N 1681
2 SB 380 A	Ge	PNP	0,270	0,300	23 (Vcb)	3,5		168		AC 121 VII	AC 151 VII
2 SB 381	Ge	PNP	0,270	0,300	30	1,3		42	T05	ASY 70 IV	ASY 70 V
2 SB 382	Ge	PNP	0,270	0,300	30	1,5		84	T05	2 N 2706	ACY 32 V
2 SB 383	Ge	PNP	0,270	0,500	30	3		84	T05	ACY 44	ACY 19
2 SB 384	Ge	PNP	0,080	0,030	15	BF		60	T01	2 N 581	2 N 583
2 SB 385 5c)	Ge	PNP	0,080	0,030	15	BF		50	T01	2 N 581	2 N 583
2 SB 386 5c)	Ge	PNP	0,150	T. recouv.	2 000 ns	1,5		80	T01	ASY 82	ASY 94

5c) Transistor de commutation.

c) Respectivement complémentaires avec 2 SD 104 et 2 SD 105.

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 387	Ge	PNP	0,030	0,020	12 (Vcb)	4		55	SOT-19	2 N 1122	2 N 1122-A
2 SB 389	Ge	PNP	0,080	0,010	12 (Vcb)	8		55	SOT-19	2 N 411	2 N 412
2 SB 390	Ge	PNP	30	6	80	1	25	250	T03	2 N 1136 B	2 N 954 silicium
2 SB 391	Ge	PNP	30	6	50	1	25	250	T03	2 N 1905	2 N 1906
2 SB 392	Ge	PNP	0,200	0,200	20 (Vcb)	BF		75	T05	OC 78	HEP 250
2 SB 393	Ge	PNP	0,200	0,200	28 (Vcb)	BF		38	T05	OC 81 N	2 N 653
2 SB 394	Ge	PNP	0,200	0,200	28 (Vcb)	BF		75	T05	2 N 654	2 N 1413
2 SB 395	Ge	PNP	0,200	0,200	28 (Vcb)	BF		150	T05	2 N 655	AC 182
2 SB 396	Ge	PNP	0,150	0,200	40 (Vcb)	BF		75	T05	2 N 404 A	2 N 2955
2 SB 397	Ge	PNP	0,200	0,080	48 (Vcb)	BF		45	T05	2 N 1954	2 N 1956
2 SB 398	Ge	PNP	0,200	0,080	110 (Vcb)	BF		45	T05	2 N 2043	2 N 2043 A
2 SB 399	Ge	PNP	0,200	0,080	110 (Vcb)	BF		25	T05	2 N 2043	2 N 2043 A
2 SB 400	Ge	PNP	0,100	0,040	20 (Vcb)	1		100	T01	2 N 2613	40359
2 SB 401	Ge	PNP	0,240	0,300	32	0,300		60	T05	2 N 2706	2 N 1124
2 SB 402	Ge	PNP	0,240	0,300	60	0,300		60	T05	2 N 1056	2 N 1614
2 SB 403	Ge	PNP	0,240	0,300	32	0,700		50	T05	2 N 2706	2 N 1124
2 SB 404	Ge	PNP	0,100	0,100	100 (Vcb)			100	T05	2 N 1670	2 N 398 A
2 SB 405	Ge	PNP	0,720	1	25	0,700		100	T01	2 SB 458	2 SB 525 silicium
2 SB 406	Ge	PNP	37,5	10	200 (Vcb)	BF	35		T03	40440	2 SB 411
2 SB 407	Ge	PNP	30	7	30	0,350	80		T03	2 SB 426	ASZ 16
2 SB 408	Ge	PNP	0,300	0,200	25 (Vcb)	BF		175	T01	2 N 1562	2 N 3883
2 SB 409	Ge	PNP	0,150	0,050	12 (Vcb)	BF		80	T01	2 N 710 A	2 N 725
2 SB 410	Ge	PNP	40	15	135	2	60		T03		2 N 5155
2 SB 411	Ge	PNP	40	11	200	2,5	60		T03	2 SB 406	40440
2 SB 412	Ge	PNP	40	11	300	3	60		T03	40439	MP 3730 B ou 2 N 5325
2 SB 413	Ge	PNP	12,5	1,5	60	2	30	150	F6	2 N 6406 silicium	TIS 141 silicium
2 SB 414	Ge	PNP	12,5	1,5	32	2	30	150	F6	SK 3082	SK 3086
2 SB 415	Ge	PNP	0,200	1	32	1,2	40	180	T01	OC 84 N	2 N 2431
2 SB 416	Ge	PNP	0,150	0,080	25 (Vcb)	BF	60		T05	40329	2 N 3371
2 SB 417	Ge	PNP	0,150	0,080	45 (Vcb)	BF	60		T05	HEP 632	2 N 527
2 SB 418	Ge	PNP	0,150	0,080	70 (Vcb)	BF	60		T05	2 N 1408	OC 77
2 SB 419	Ge	PNP	6	1,5	45 (Vcb)	BF	80		T03		2 N 301
2 SB 420	Ge	PNP	6	1,5	120 (Vcb)	BF	100		T03		2 N 5603 silicium

•Pc = Puissance collecteur max.
 •Ic = Courant collecteur max.
 •Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 •Fmax = Fréquence max.

•Ge = Germanium
 •Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 421	Ge	PNP	0,300	0,600	80	2,5		70	T05	BC 477 VI	2 N 4356
2 SB 422	Ge	PNP	0,060	0,040	18 (Vcb)	BF		50	T01	2 N 1744	2 N 1747
2 SB 423	Ge	PNP	0,150	0,150	30 (Vcb)	BF		70	T01	AC 125	OC 75
2 SB 424	Ge	PNP	30	3	80	0,300	34	115	T03	AD 163	AUY 34
2 SB 425	Ge	PNP	30	3	60	0,300	34	115	T03	AD 132	AUY 20
2 SB 426	Ge	PNP	30	3	32	0,300	34	115	T03	AD 130	2 N 1755
2 SB 426 A	Ge	PNP	30	3	25 (Vcb)	0,400	34	80	T03	2 N 1755	AD 130
2 SB 427	Ge	PNP	0,225	0,500	30	1		60	T05	2 N 525 A	ASY 81
2 SB 428	Ge	PNP	0,225	0,500	30	1		90	T05	2 N 527 A	2 N 526 A
2 SB 429	Ge	PNP	0,100	0,050	30 (Vcb)	BF		150	T018	2 N 3280	AFY 16
2 SB 430	Ge	PNP	80	20	70 (Vcb)	0,010	10		T036	2 N 173	HEP 237
2 SB 431	Ge	PNP	0,200	0,500	32	1,2		80	T01	2 N 1018	OC 83 N
2 SB 432	Ge	PNP	50	5	100	3	40	170	T03	2 N 459	2 N 5286 silicium
2 SB 433	Ge	PNP	56	15	60	BF	30	120	T0 36	2 N 1358 A	ADZ 12
2 SB 434	Si	PNP	25	3	50	3	15	25	X75	BD 178	BD 176
2 SB 434 G	Si	PNP	25	3	50	3		240	T0220	2 SB 503 A	2 SA 670
2 SB 435	Si	PNP	25	3	35	3	20	55	X75	MJE 370	MJE 3370
2 SB 435 G	Si	PNP	25	3	40	3		240	T0220	2 SA 490	2 N 3199
2 SB 436	Ge	PNP	0,120	0,120	25 (Vcb)	BF	60		T01	2 N 582	2 N 584
2 SB 437	Ge	PNP	0,120	0,120	45 (Vcb)	BF	60		T01	2 N 1408	2 N 2189
2 SB 438	Ge	PNP	0,120	0,120	70 (Vcb)	BF	60		T01	2 N 2190	2 N 284
2 SB 439	Ge	PNP	0,150	0,150	20	2	70	270	T01	2 SB 440	AC 151
2 SB 440	Ge	PNP	0,150	0,150	20	2	70	270	T01	2 SB 439	AC 151
2 SB 441	Ge	PNP	40	6	160 (Vcb)	BF	50		T03	2 SB 611	TIP 514
2 SB 442	Ge	PNP	40	6	160 (Vcb)	BF	50		T03	2 SB 611	TIP 514
2 SB 443	Ge	PNP	0,100	0,010	18	3		150	T01	40359	AC 121 VI
2 SB 443 A	Ge	PNP	0,100	0,010	18	2,5		110	T01	SK 3003	AC 121 VI
2 SB 443 B	Ge	PNP	0,100	0,010	18	3,5		190	T01	40395	AC 121 VII
2 SB 444	Ge	PNP	0,100	0,010	18	3		160	T01	40359	AC 121 VI
2 SB 444 A	Ge	PNP	0,100	0,010	18	2,5		110	T01	SK 3003	AC 121 VI
2 SB 444 B	Ge	PNP	0,100	0,010	18	3,5		200	T01	40395	AC 121 VII
2 SB 445	Ge	PNP	10	1,5	40	1,5	40	200	F6	2 SA 715 silicium	AD 148
2 SB 446	Ge	PNP	10	1,5	50	1,5	40	200	F6	BSS 18 silicium	2 SA 636 silicium

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 447	Ge	PNP	45	6	220 (Vcb)	1,5	15	50	T03		TIP 527 <small>silicium</small>
2 SB 448	Ge	PNP	13	1	32 (Vcb)		30	110	F7	2 N 301	2 N 301 A
2 SB 449	Ge	PNP	22	3,5	50	0,010	20	85	T03	AD 149	2 N 2566
2 SB 450	Ge	PNP	0,200	0,500	25	1,3		120	T01	2 N 1446	2 N 1447
2 SB 450 A	Ge	PNP	0,200	0,500	32	1,3		120	T01	2 N 652	2 N 652 A
2 SB 451	Ge	PNP	0,300	1	25	BF		80	T05	2 N 2648	2 G 384
2 SB 452	Ge	PNP	0,300	1	25	BF		150	T05	2 N 2648	2 G 385
2 SB 452 A	Ge	PNP	0,300	1	45	BF		150	T05	BCW 37 <small>silicium</small>	BC 297 <small>silicium</small>
2 SB 453	Ge	PNP	0,250	0,300	30	1		120	T05	2 SB 377	2 N 2706
2 SB 454	Ge	PNP	0,250	0,300	80	1		120	T05	2 SB 421	AF 118
2 SB 455	Ge	PNP	0,250	0,150	105	1		120	T05	2 N 398 B	2 N 2043
2 SB 456	Ge	PNP	13	1	80	BF	80		T08	2 N 6407	2 SA 547 A
2 SB 457	Ge	PNP	0,150	0,500	20	0,800		110	T01	ACY 30	ASY 50
2 SB 457 A	Ge	PNP	0,150	0,500	32	0,800		110	T01	2 N 1190	2 N 3427
2 SB 458	Ge	PNP	0,800	1	25	BF	28	210	F9	2 SB 525 <small>silicium</small>	2 SB 564 <small>silicium</small>
2 SB 458 A	Ge	PNP	0,800	1	45	BF	28	210	F9	BC 636 <small>silicium</small>	BC 160-16 <small>silicium</small>
2 SB 458 B	Ge	PNP	0,800	1	100	BF	28	210	F9	2 SA 510 <small>silicium</small>	2 SA 850 <small>silicium</small>
2 SB 459	Ge	PNP	0,120	0,050	18	BF		180	T01	40395	AC 122
2 SB 460	Ge	PNP	0,120	0,050	25	BF		180	T01	2 N 2613	AC 151
2 SB 461	Ge	PNP	0,300	0,400	30	1,2		60	T05	ASY 70 V	ASY 70 VI
2 SB 462	Ge	PNP	6	2	60	0,900	30	250	T066	SK 3052	D 40 E 5 <small>silicium</small>
2 SB 463	Ge	PNP	6	2	32	0,900	30	250	T066	AD148	2 N 3461
2 SB 464	Ge	PNP	30	6	100	1,6	30	170	T03	TIP 42 C	2 SB 342
2 SB 465	Ge	PNP	30	6	60	1,6	30	170	T03	2 N 1669	AUY 28
2 SB 466	Ge	PNP	12	0,500	30	1,3	25	150	F6		2 SA 496 <small>silicium</small>
2 SB 467	Ge	PNP	12	0,500	40	1,3	25	150	F6		BD 136 <small>silicium</small>
2 SB 468	Ge	PNP	32	10	90	BF	14	130	T03	AD 142	2 N 1430
2 SB 468 A	Ge	PNP	32	10	90	BF	14	130	T03	AD 142	2 N 1430
2 SB 470	Ge	PNP	0,080	0,050	18	BF		160	T01	2 N 3127	2 SB 459
2 SB 471	Ge	PNP	30	10	45	0,300	50	165	T03	AD 143	AUY 21
2 SB 472	Ge	PNP	30	10	50	0,300	50	165	T03	SK3009	2 N 2869 ou 70
2 SB 473	Ge	PNP	4,3	1	32 (Vcb)	0,010	40	180	F6	AD 162 VII	AD 162
2 SB 474	Ge	PNP	12	2	35	0,700	50	275	T03	SK 3086	SK 3082

Pc = Puissance collecteur max.

Ic = Courant collecteur max.

Vce max = Tension collecteur émetteur max.

Fmax = Fréquence max.

●Ge = Germanium

●Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
SB 475	Ge	PNP	0,150	0,300	20 (Vcb)	BF	60		T01	AF 187	2 N 1115
SB 476	Ge	PNP	0,250	2	10	1,2	75		T039	2 SB 476 S	2 SB 533
SB 476 S	Ge	PNP	0,250	2	10	1,2	80		T039	2 SB 476 W	2 SB 533
SB 476 W	Ge	PNP	0,250	2	10	1,2	100		T039	AC 153 K VI	AC 153 VI
SB 477	Ge	PNP	80	30	30 (Vcb)	BF	40		T036		2 N 514
SB 478	Ge	PNP	80	30	60 (Vcb)	BF	40		T036	2 N 6329 <small>silicium</small>	2 N 1520
SB 479	Ge	PNP	80	30	80 (Vcb)	BF	40		T036	2 N 1521	2 N 6330 <small>silicium</small>
SB 480	Ge	PNP	80	30	100 (Vcb)	BF	40		T036	2 SB 208	2 SB 214
SB 481	Ge	PNP	6	1	10 (Vcb)	BF	30	110	F5	AD 164	AD 155
SB 482	Ge	PNP	0,120	0,050	35 (Vcb)	BF		220	T01	2 N 2614	2 N 2613
SB 483	Ge	PNP	60	15	60	0,0025	40	100	T03	BDW 52 A <small>silicium</small>	2 N 2612
SB 484	Ge	PNP	60	15	75	0,0025	40	100	T03	BDW 52 B <small>silicium</small>	2 N 3147
SB 485	Ge	PNP	60	15	85	0,0025	40	100	T03	BDW 52 B <small>silicium</small>	BD 546 B <small>silicium</small>
SB 486	Ge	PNP	0,120	0,050	20	7		200	T01	40 359	2 N 1065
SB 487	Ge	PNP	5	0,500	20	1	30	150	MD26	MM 4018 <small>silicium</small>	
SB 488	Ge	PNP	5	0,500	30	1	30	150	MD26	2 SB 180	2 N 5583 <small>silicium</small>
SB 491	Ge	PNP	40	11	250 (Vcb)	BF	35			2 SB 412	2 SB 411
SB 492	Ge	PNP	6	2	25	0,700		110	T039	2 SB 523 <small>silicium</small>	2 SA 634 <small>silicium</small>
SB 493	Ge	PNP	9	5	20	0,300	40		T08		MJE 210
SB 493 W	Ge	PNP	9	5	20	0,300	60		T08		MJE 210
SB 494	Ge	PNP	0,200	1	18	1	38		T01	2 N 2002	AC 188 K
SB 495	Ge	PNP	0,200	1	18	1		110	T01	2 N 2001	AC 188 K
SB 495 A	Ge	PNP	0,200	1	25	1		110	T01	2 N 2648	2 N 601
SB 496	Ge	PNP	0,600	0,250	18	2	60		T01	AC 121	AC 162
SB 497	Ge	PNP	0,065	0,030	15	3		90	R18	2 N 695	2 N 588 A
SB 498	Ge	PNP	0,100	0,050	25 (Vcb)	BF		170	T018	2 N 2273	2 N 3283
SB 502	Si	PNP	20	3	80	1	30	280	T066	2 N 6418	2 SB 512 A
SB 502 A	Si	PNP	25	3	80	1	30	280	T066	MJ 2254	2 SB 513 A
SB 503	Si	PNP	20	3	50	1	30	280	T066	2 SA 748	2 SA 513
SB 503 A	Si	PNP	25	3	50	1	30	280	T066	2 SA 670	2 SA 671
SB 504	Si	PNP	1	3	60	BF	40	300	T039	2 SB 505	2 N 3868
SB 505	Si	PNP	1	3	60	BF	40	300	F19	2 SB 504	2 N 3868
SB 506	Si	PNP	60	7,5	100	BF	35	200	T03	2 SB 611	BD 544 C

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 506 A	Si	PNP	60	5	150	BF	35	200	T03	TIP 513	TIP 514
2 SB 507 d)	Si	PNP	30	3	60	8	40	320	X75	BD 178	BD 242 A
2 SB 508 d)	Si	PNP	30	3	60	8	40	320	X75	BD 178	BD 242 A
2 SB 509	Si	PNP	35	4	60	8	40	320	T066	BD 440	2 N 6025
2 SB 510	Si	PNP	0,800	1,5	60	50	60	320	T039	2 SA 799	2 N 5864
2 SB 510 S	Si	PNP	0,800	1	60	50	40		T039	BC 638	BFT 61
2 SB 511	Si	PNP	10	1,5	35	8	40	320	X75	MJE 710	2 N 3660
2 SB 512 d)	Si	PNP	25	3	60	0,070	40		X75	2 SB 513	TIP 32 A
2 SB 512 A d)	Si	PNP	25	3	80	0,070	40		X75	2 SB 513 A	TIP 32 B
2 SB 513	Si	PNP	25	3	60	0,070	40		X75	2 SB 512	TIP 32 A
2 SB 513 A	Si	PNP	25	3	80	0,070	40		X75	2 SB 512 A	TIP 32 B
2 SB 514	Si	PNP	20	2	50	8	40	320	X75	2 SB 515	2 SA 754
2 SB 515	Si	PNP	20	2	50	8	40	320	X75	2 SB 514	2 SA 755
2 SB 518	Si	PNP	60	7	90	3	50		T03	2 SB 611	RCA 42 C
2 SB 519	Si	PNP	100	10	110	3	50		T03	2 SA 753	2 N 6248
2 SB 520	Si	PNP	120	12	140	3	50		T03	BDX 20	2 N 6031
2 SB 521	Si	PNP	43	5	60	7	45	250	T0220	2 SB 522	2 N 6106
2 SB 522	Si	PNP	43	5	60	7	45	250	T0220	2 SB 521	2 N 6107
2 SB 523	Si	PNP	10	2	20	70	55	300		2 SB 529	BD 362
2 SB 524	Si	PNP	10	1,5	40	70	55	300		BD 136	BD 227
2 SB 525	Si	PNP	0,800	1	25	100		100	T092	2 SB 564	BFT 61
2 SB 526	Si	PNP	10	0,800	80	70	55	300		2 SB 548	2 SA 547 A
2 SB 527	Si	PNP	10	0,800	100	70	55	300		2 SB 549	RCA 1 A 16
2 SB 528	Si	PNP	10	0,800	120	70	55	300		2 SA 653	2 SB 527
2 SB 529	Si	PNP	10	2	20	70	55	300		2 SB 523	BD 362
2 SB 530	Si	PNP	80	8	100	BF	40	240	T03	BDX 96	BD 544 C
2 SB 531	Si	PNP	50	6	80	BF	40	240	T03	TIP 42 B	MJE 42 B
2 SB 533	Ge	PNP	0,250	2	10	1,2	75		T039	2 SB 476	AC 153 VI
2 SB 536	Si	PNP	20	1,5	120	BF	40	250	T0220	2 SB 537	2 SA 814
2 SB 537 d)	Si	PNP	20	1,5	120	BF	40	250	T0220	2 SB 536	2 SA 814
2 SB 539	Si	PNP	100	15	120	8	40	200	T03	2 SB 539 A	BD 546 D
2 SB 539 A	Si	PNP	100	15	120	8	40	200	T03	2 SB 539	BD 546 D
2 SB 539 B	Si	PNP	100	15	140	8	40	200	T03	2 N 6031	2 SB 539 C

(160 V)

d) Broches en équerre.

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 539 C	Si	PNP	100	15	160	8	40	200	T03	2 SB 554	2 SB 539 B (140 V)
2 SB 541	Si	PNP	80	12	100	9	40	200	T03	BD 246 C	
2 SB 542	Si	PNP	0,300	0,300	15	130		100	T092	BFX 13	BFX 12
2 SB 544	Si	PNP	0,750	1	25	180		60	R182	BCW 79-10	BF 323
2 SB 546	Si	PNP	20	2	150		40	200	T0220	2 SB 547	BUX 66
2 SB 546 A	Si	PNP	25	2	150	5	40	200	T0220	2 SB 547 A	BUX 66
2 SB 547	Si	PNP	20	2	150		40	200	T0220	2 SB 546	BUX 66
2 SB 547 A	Si	PNP	25	2	150	5	40	200	T0220	2 SB 546 A	BUX 66
2 SB 548	Si	PNP	10	0,800	80	80	40	320	T0126	2 SB 526	TIP 62 B
2 SB 549	Si	PNP	10	0,800	100	80	40	320	T0126	2 SB 527	TIP 62 C
2 SB 550	Si	PNP	25	5	80		30	200	T066	2 N 5607	2 N 5609
2 SB 551 H	Si	PNP	25	3	50	32	35	200	T066	2 SA 670	2 SA 671
2 SB 552	Si	PNP	150	15	180	4	25	80	T03	2 SB 554	2 N 6031 (140 V)
2 SB 554	Si	PNP	150	15	160	6	40	140	T03	2 SB 552	2 N 6031 (140 V)
2 SB 555	Si	PNP	100	12	140	6	40	140	T03	2 SB 520	2 N 6231
2 SB 556	Si	PNP	100	12	120	6	40	140	T03	2 SA 679	2 N 6230
2 SB 557	Si	PNP	80	8	120	7	40	140	T03	2 SB 758	BD 544 D
2 SB 558	Si	PNP	80	7	100	7	40	140	T03	2 SA 649	2 SA 758
2 SB 560	Si	PNP	0,750	0,700	80	100		320	T039	BSW 40-25	BC 640
2 SB 561	Si	PNP	0,500	0,700	20	350	60		T092	2 N 6001	BC 328
2 SB 562	Si	PNP	0,900	1	20		60		R195	BCW 80-10	BCW 79-10
2 SB 563	Si	PNP	25	3	70		40	200	T0220	MJ 2254	MJ 2253
2 SB 564	Si	PNP	0,800	1	25	110		200		BCW 80-10	BCW 79-10
2 SB 565	Si	PNP	40	4	50	15	35	320	X75	2 SB 566	2 N 6124
2 SB 565 A	Si	PNP	40	4	60	15	35	320	X75	2 SB 566 A	2 N 6125
2 SB 566 d)	Si	PNP	40	4	50	15	35	320	X75	2 SB 565	2 N 6124
2 SB 566 A d)	Si	PNP	40	4	60	15	35	320	X75	2 SB 565 A	2 N 6125
2 SB 567 d)	Si	PNP	30	2	150		60	320	X75	2 SB 608	2 SB 608 A
2 SB 568	Si	PNP	30	2	150		60	320	X75	2 SB 546 A	2 SB 547 A
2 SB 595	Si	PNP	40	5	100	4	40	240	T0220	BD 540 C	RCA 32 C
2 SB 596	Si	PNP	30	4	80	3	40	240	T0220	2 SA 769	BD 442
2 SB 598	Si	NPN	0,500	1	20	180		560	R195	2 SD 545	BC 338
2 SB 600	Si	PNP	200	15	200	4	40	200	T03	2 SB 552 (180 V)	

d) Broches en équerre.

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SB 604 d)	Si	PNP	30	4	70		40	240	X75	2 SA 769	BD 442
2 SB 605	Si	PNP	0,800	0,700	50	120		200		2 SA 503	BFX 38
2 SB 608 d)	Si	PNP	30	2	140	BF	60	320	X75	2 SB 567	2 SB 568
2 SB 608 A d)	Si	PNP	30	2	160	BF	60	320	X75	2 SB 567	2 SB 568
2 SB 609	Si	PNP	40	4	80	BF	60	320	T066	2 SA 771	2 N 6126
2 SB 611	Si	PNP	60	7	100	BF	60	200	T03	2 SA 757	TIP 42 C
2 SB 611 A	Si	PNP	60	7	120	BF	60	200	T03	2 SA 758	BD 544 D
2 SB 612	Si	PNP	100	12	140	BF	35	200	T03	2 SB 555	2 N 6231
2 SB 612 A	Si	PNP	100	12	160	BF	35	200	T03	2 SB 554	2 SB 539 C
2 SB 615 4)	Si	PNP	80	7	110	BF	2000		T03	BDX 62 B	TIP 137
2 SB 616 a)	Si	PNP	60	8	80	11	40	200	B29	BDX 78	2 N 6299
2 SB 617 a)	Si	PNP	70	6	100	7	40	200	B33	MJE 42 C	TIP 42 C
2 SB 618 a)	Si	PNP	80	7	120	6	40	200	B33	BD 544 D	2 SA 758
2 SB 628	Si	PNP	20	1,5	160	40	40	200	T0220	2 SB 546	2 SB 547
2 SB 630	Si	PNP	25	2	200	4	40	200	T0220	TIP 521	TIP 522
2 SB 637 K	Si	PNP	0,300	0,100	50	200	160		T092	BC 212 LA	BC 212 LB
2 SB 638 H 4)	Si	PNP	80	10	100	BF	1000		T03	BDX 64 B	
2 SB 639 H 4)	Si	PNP	100	10	100	BF	1000		T03	BDX 64 B	
2 SC 11	Ge	NPN	0,055	0,024	18 (Vcb)	6	48		T01	2 N 1058	2 N 517
2 SC 12	Si	NPN	0,180	0,250	60 (Vcb)	BF	20		T05	2 SC 725	BC 207 A
2 SC 13	Ge	NPN	0,065	0,040	18	3,5	48		T05	2 N 1367	2 N 1366
2 SC 14	Ge	NPN	0,065	0,040	18	15	48		T05	2 N 1367	2 N 1366
2 SC 15	Si	NPN	1	0,050	30 (Vcb)	200	60		T09	BCY 58 A	BCY 58 B
2 SC 16	Si	NPN	0,250	0,030	25 (Vcb)	BF	25		T018	2 N 3825	BC 408
2 SC 16 A	Si	NPN	0,250	0,050	25 (Vcb)	BF	30		T018	2 N 3825	BC 408
2 SC 17	Si	NPN	0,250	0,050	20 (Vcb)	150	30		T018	BFW 30	TIS 18
2 SC 17 A	Si	NPN	0,250	0,030	25 (Vcb)	150	30		T018	2 N 3825	BC 408
2 SC 18	Si	NPN	0,250	0,030	25 (Vcb)	30	20		T018	2 N 3825	BC 408
2 SC 19	Si	NPN	0,600	0,400	30	70	50		T05	2 N 3881	2 N 1420
2 SC 20	Si	NPN	0,600	0,400	40	70	50		T05	2 N 3881	2 N 697
2 SC 21	Si	NPN	60	2	60 (Vcb)	6	25		T03	BD 241 A	2 N 2383
2 SC 22	Si	NPN	13	0,600	50	110	20	100	T08	3 TX 615	3 TX 613
2 SC 23	Si	NPN	13	0,500	50	110	20	100	T08	3 TX 615	3 TX 614

4) Transistor Darlington , d) Broche en équerre ; a) Récupérer le

Dissipateur -

5c = transistor
commutation

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 841 H 5c)	Si	NPN	0,1	T. recouv.	30 ns	200		200		2 N 4403	BSY 26
2 SC 842	Si	NPN	10	1	36 (Vcb)	450	40		T060	BLY 55	2 N 5846
2 SC 843	Si	NPN	20	2	36 (Vcb)	350	50		T060	40282	2 N 5424
2 SC 844	Si	NPN	3,5	0,400	17	800	10	200	T05	BFS 22 A	2 N 3948
2 SC 845	Si	NPN	3,5	0,400	30	800	10	200	T05	2 N 3866 A	2 N 4429
2 SC 847	Si	NPN	0,500	0,200	20	70		160	T018	BC 548 A	BC 549 C
2 SC 848	Si	NPN	0,500	0,200	20	60		160	T018	BC 548 A	BC 549 C
2 SC 849	Si	NPN	0,500	0,300	20	60		160	T018	BC 548 A	BC 549 C
2 SC 850	Si	NPN	0,500	0,500	30	70		160	T018	BC 548 VI	BC 549
2 SC 851	Si	NPN	75	8	25	110	20	250	T03		BD 705
2 SC 852	Si	NPN	0,500	0,080	25	800		100	T033	2 N 4875	TIS 39
2 SC 853	Si	NPN	0,400	0,200	60	BF		80	R198	2 N 2510	TIS 99
2 SC 854	Si	NPN	2,5	0,300	20	800	10	200	T05	2 N 5109	A 203
2 SC 855	Si	NPN	3	0,400	20	800	10	200	T05	2 N 5109	2 N 3948
2 SC 856	Si	NPN	0,300	0,050	150	180	30		T01	HEPS 0005	MPSD 02
2 SC 857	Si	NPN	0,200	0,050	200	100	60		T01	BF 120	2 N 6220
2 SC 857 H 5c)	Si	NPN	0,200			50	30		T01	2 N 1387	2 N 4000
2 SC 857 K	Si	NPN	0,200			60	30		T018	2 N 4964	2 N 4965
2 SC 858	Si	NPN	0,100	0,050	20 (Vcb)	180		240	T092	BSY 95	2 N 1199
2 SC 859	Si	NPN	0,100	0,050	20 (Vcb)	180		240	T092	BSY 95	2 N 1199
2 SC 860	Si	NPN	0,200	0,030	15 (Vcb)	800		80	T0104	2 N 5031	2 N 5032
2 SC 861	Si	NPN	50	1	450 (Vcb)	7	50		T03	185 T 2B	TIP 49
2 SC 862	Si	NPN	50	5	650 (Vcb)	7	9		T03	BDY 43	2 N 6542
2 SC 863	Si	NPN	0,200	0,025	50	600		100	T072	2 N 5081	2 N 4104
2 SC 864	Si	NPN	0,200	0,025	30	600		100	T072	2 N 3933	BF 233-5
2 SC 865	Si	NPN	20	2	60 (Vcb)			50	T08	BD 371 B	MJ 2249
2 SC 866	Si	NPN	5	1,5	60 (Vcb)			50	T037	BSX 46-10	BFY 70
2 SC 867	Si	NPN	18	1	180	8,5	20	350	S0T9	41505	2 N 5660
2 SC 868	Si	NPN	0,200	0,030	40	150	35		T092	2 N 3693	2 N 3694
2 SC 869	Si	NPN	0,200	0,030	50	150	35		T092	2 N 3693	2 N 3694
2 SC 870	Si	NPN	0,200	0,030	25	150		250	T092	2 N 3691	2 N 3692
2 SC 871	Si	NPN	0,200	0,030	25	150		350	T092	2 N 3692	PCB 109
2 SC 872	Si	NPN	3,5	0,400	40 (Vcb)	800	25		T05	MM 8009	MM 8001

TRANSISTORS

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 872 M	Si	NPN	3,5	0,400	20	600			T039	41024	MRF 207
2 SC 873	Si	NPN	0,500	1	75	200	40	80		2 N 4961	2 N 4963
2 SC 874	Si	NPN	0,500	1	50	200	40	80		BC 337	BC 547 VI
2 SC 875	Si	NPN	0,500	0,500	75	170		100	T039	2 N 4961	2 N 4963
2 SC 876	Si	NPN	0,500	0,500	50	170		100	T039	BC 337	BC 547 VI
2 SC 877	Si	NPN	0,300	0,200	40 (Vcb)		60		T018	BC 183 A	BC 383
2 SC 878	Si	NPN	0,300	0,200	40 (Vcb)		70		T018	BC 183 A	BC 383
2 SC 879	Si	NPN	0,800	1	60 (Vcb)		60	100	T05	BC 120	BC 138
2 SC 880	Si	NPN	0,800	1	60 (Vcb)		60	100	T05	2 N 2192	ou 2 N 2192 A
2 SC 881	Si	NPN	0,400	0,200	45			80	R198	BCY 59 A	2 N 6004
2 SC 882	Si	NPN	25	2	150 (Vcb)	BF	50		T03	2 N 3145	2 N 3441
2 SC 883	Si	NPN	25	2	90 (Vcb)	BF	50		T03	BDY 71	BDY 78
2 SC 884	Si	NPN	15	2	80 (Vcb)	BF	60		T03	2 N 2781	2 N 2874
2 SC 885	Si	PNP	50	7	330 (Vcb)	BF	20	60	T03	BUY 185	2 N 6077
2 SC 886	Si	NPN	50	7	270 (Vcb)	BF	20	60	T03	BUY 87	2 N 6078
2 SC 887	Si	NPN	50	7	210 (Vcb)	BF	20	60	T03	BUY 86	182 T 2 B
2 SC 888	Si	NPN	50	7	150 (Vcb)	BF	20	60	T03	2 SD 218	
2 SC 889	Si	NPN	50	7	90 (Vcb)	BF	20	60	T03	2 N 5429	2 N 5497
2 SC 890	Si	NPN	4,3	0,400	20	600	20		T039	BLX 65	BLX 66
2 SC 891	Si	NPN	10	0,600	20	600	15		MT59	BLY 53 A	3 TX 632
2 SC 892	Si	NPN	17	1,2	20	400	15		MT59	3 TX 602	RE 3780
2 SC 893	Si	NPN	12	0,300	60	20	50	370	MD29 ou E17	40291	2 N 3296
2 SC 894	Si	NPN	0,100	0,100	13	200		100		BF 480	BSY 95
2 SC 895	Si	NPN	18	2,5	90	20	20	350	F9	2 N 5604	PT 655 A
2 SC 896	Si	NPN	0,300	0,200	30	200	70		T046	BSX 38 A	2 N 4140
2 SC 897	Si	NPN	60	7	90	4	25	200	F6	BUY 86	2 N 5497
2 SC 898	Si	NPN	80	7	110	15	25	200	F6	BUY 86	181 T2 C
2 SC 899	Si	NPN	0,250	0,030	25	150		115	T092	BF 594	BF 595
2 SC 900	Si	NPN	0,250	0,020	25	BF		250	T092	BC 408 A	BC 408 B
2 SC 901	Si	NPN	50	5	200	BF	14	25	T03	184 T2 C	2 N 6233
2 SC 901 A	Si	NPN	50	5	250	BF	14	25	T03	BDY 42	2 N 6234
2 SC 902	Si	NPN	75	10	150 (Vcb)	BF	25	75	T03	SDT 7604	SDT 7610
2 SC 903	Si	NPN	0,200	0,300	30	150		100	T092	BC 183 K	2 N 4436

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

SC = transistor
commutation

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 904	Si	NPN	0,200	0,300	45	150		100	T092	BC 171	PBC 107
2 SC 905	Si	NPN	0,200	0,300	60	150		100	T092	BC 682	BSY 78
2 SC 906	Si	NPN	0,600	0,500	30	BF		160	R215	2 N 2309	BFW 29
2 SC 907	Si	NPN	0,200	0,100	40 (Vcb)	240		200	T01	2 N 3646	2 N 4275
2 SC 907 A	Si	NPN	0,200	0,100	60 (Vcb)	240		120	T01	2 N 4437	BC 407
2 SC 907 H (5c)	Si	NPN	0,200			250	60		T01	BSX 76	BFY 18
2 SC 908	Si	NPN	0,860	0,500	40	800	10	180	T039	2 N 5943	2 N 4428
2 SC 909	Si	NPN	7	0,500	40	800	5		MT59		2 SC 910
2 SC 910	Si	NPN	10	1	40	800	5		MT59		2 SC 909
2 SC 911	Si	NPN	1,7	0,500	40	800	10	180	W43	2 SC 911 A	
2 SC 911 A	Si	NPN	1,7	0,500	40	800	20	180	W43	2 SC 911	
2 SC 912	Si	NPN	0,150	0,100	25	150		90	R126	2 N 1472	BC 173 A
2 SC 913	Si	NPN	0,300	0,300	35	BF	50	90	T018	BSY 75	BC 384
2 SC 914	Si	NPN	0,300	0,300	35	BF	50	90	T018	BSY 75	BC 384
2 SC 914 A	Si	NPN	0,300	0,300	35	BF	50	90	T018	BSY 75	BC 384
2 SC 915	Si	NPN	0,300	0,300	30	BF	50	90	T018	BSY 75	BC 384
2 SC 915 A	Si	NPN	0,300	0,300	30	BF	50	90	T018	BSY 75	BC 384
2 SC 916	Si	NPN	2	1,5	70	BF	70		T08	2 N 1479	2 N 1481
2 SC 917	Si	NPN	0,300	0,050	40	180	8		T01	BSX 79 A	BSX 79 B
2 SC 918	Si	NPN	0,375	0,030	20	400	20		T0104	BF 199	MPSH 02
2 SC 920	Si	NPN	0,150	0,030	25	150		75	U23		2 SC 800
2 SC 921	Si	NPN	0,150	0,010	12	450		65	U23	BFW 93	BF 480
2 SC 923	Si	NPN	0,250	0,030	25	100		400	R182	BF 594	BF 595
2 SC 924	Si	NPN	0,250	0,050	15	250		100	T092	2 N 3825	BC 408
2 SC 925	Si	NPN	0,250	0,050	15	250		130	T092	2 N 3825	BC 408
2 SC 926	Si	NPN	0,100	0,100	115	160		50	X153	2 S 743 A	2 S 746 A
2 SC 927	Si	NPN	0,150	0,020	15	500		80	T0104	2 N 5650 à	2 N 5652
2 SC 928	Si	NPN	0,150	0,020	15	500		80	T0104	2 N 5650 à	2 N 5652
2 SC 929	Si	NPN	0,120	0,030	10	300		100	R145	BF 153	2 N 3563
2 SC 930	Si	NPN	0,120	0,030	10	300		80	R145	BF 153	2 N 3563
2 SC 931	Si	NPN	10	3	50	120	70		X101	BD 131	MSC 2010
2 SC 932	Si	NPN	10	3	20	120	70		X101	BD 131	MSC 2010
2 SC 933	Si	NPN	0,200	0,300	30	500		100	T0104	2 N 3933	BFX 60

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 934	Si	NPN	0,200	0,300	15	500		100	T0104	2 N 4252	2 N 4253
2 SC 935	Si	NPN	50	2,5	300	BF	8	14	T03	2 N 5839	2 N 5838
2 SC 936	Si	NPN	22	1	500	7	30	120	T03	BUX 87	TRS 5006
2 SC 936 A	Si	NPN	22	1	500	7	45		T03	BUX 87	STI 5006
2 SC 937	Si	NPN	22	2,5	500	4	8		T03		BUX 85
2 SC 938	Si	NPN	0,250	0,200	60	150		80	T092	BSY 77	BSY 78
2 SC 939	Si	NPN	50	5	60	20	15	120	T03	2 N 3563	BD 539 A
2 SC 940	Si	NPN	50	5	90	20	15	120	T03	2 N 5620	BD 539 C
2 SC 941	Si	NPN	0,200	0,020	30	120		60	R67	2 N 4134	BF 233-2 ou 3
2 SC 942	Si	NPN	0,200	0,020	20 (Vcb)	700	50	90	R67	2 N 5179	BF 273 C
2 SC 943	Si	NPN	0,300	0,200	40	150	80		T018	BC 582	BC 582 B
2 SC 944	Si	NPN	0,250	0,100	40	200	60		T092	BC 407	BC 167 A
2 SC 944 S	Si	NPN	0,250	0,100	40	250		180	T092	BC 407 A	BC 167 A
2 SC 945	Si	NPN	0,250	0,100	50	250		200	R182	BC 407 B	BC 167 B
2 SC 945 L	Si	NPN	0,250	0,100	50	250		200	T092	BC 407 B	BC 167 B
2 SC 947	Si	NPN	0,150	0,020	20	650	20		T072	BF 182	BF 200
2 SC 948	Si	NPN	0,150	0,020	20	800	24		T072	BF 183	BF 200
2 SC 949	Si	NPN	0,200	0,050	30 (Vcb)	40		150	T018	2 N 3843 A	2 N 3843
2 SC 950	Si	NPN	0,300	0,100	30 (Vcb)	55		100	T018	2 N 729	BC 583
2 SC 952	Si	NPN	0,300	0,200	90 (Vcb)	40		90	T018	2 N 2652	2 N 2652 A
2 SC 953	Si	NPN	0,600	0,200	30 (Vcb)	90		80	T05	2 N 1252	2 N 1253
2 SC 954	Si	NPN	0,600	0,400	60 (Vcb)	90		100	T05	2 N 1959	2 N 1958
2 SC 955	Si	NPN	0,150	0,050	20 (Vcb)	150		100	T018	BSY 95	2 N 1205
2 SC 956	Si	NPN	0,150	0,050	50 (Vcb)	200		250	T018	BC 207 A	BC 207
2 SC 957	Si	NPN	0,360	0,100	30	700	13		R90	BLX 88	MPSH 24
2 SC 959	Si	NPN	0,700	0,700	80	50		80	T05	BC 489-18	2 N 4239
2 SC 959 S	Si	NPN	0,700	0,700	80	BF		100	T05	2 N 4239	BC 489
2 SC 960	Si	NPN	1	0,700	80		40	200	F47	40409	BD 139
2 SC 960 S	Si	NPN	1	0,700	80		40	100	F48	40409	BD 139
2 SC 961	Si	NPN	60	7	120 (Vcb)	13	40	80	T03	2 SD 217	
2 SC 962	Si	NPN	60	7	100 (Vcb)	13	40	80	T03	181 T2 B	MJE 41 C
2 SC 963	Si	NPN	0,250	0,050	25	200		100	R213	BC 413	BF 594
2 SC 964	Si	NPN	0,250	0,050	35	200		130	T018	BF 594	BF 595

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

transistor Double

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1571	L	Si	0,200	0,100	35	100		40	R182	2 N 3854 A	2 N 3860
2 SC 1573		Si	0,600	0,070	200	80	30		T0126	BF 355	BF 179 B
2 SC 1574		Si	0,400	0,030	20	4,5 GHz		70	T039	A 406	HP 35824 A
2 SC 1576		Si	100	8	330	10	30	150	T03	2 N 6307	2 N 6546
2 SC 1577		Si	80	8	400	7	10	30	T03	BUX 44	2 N 6545
2 SC 1578		Si	80	8	500	7	10	30	T03	BUX 15	BUY 69 C
2 SC 1579		Si	150	15	400	7	10	25	T03	2 SD 310	MJ 7261
2 SC 1580		Si	150	15	500	7	10	25	T03	BUX 15	BUY 69 C
2 SC 1581		Si	80	7	35	50	10	100	W72		2 SC 1582
2 SC 1582		Si	140	13	35	50	10	100	W72		2 SC 1581
2 SC 1583	1)	Si	0,400	0,010			0,5 à 0	8			2 SC 294
2 SC 1584		Si	150	15	100	10	30	50	T03	2 N 5973	BD 743 C
2 SC 1585		Si	150	15	150	10	30	50	T03	BDX 50	43104
2 SC 1586		Si	150	15	200	10	30	50	T03		BUX 41
2 SC 1589		Si	2,5	0,700	18	550	15	200	T0202	BFR 98	2 N 5697
2 SC 1590		Si	13	1,2	18	350	15	200	W64		2 SC 1591
2 SC 1591		Si	25	2,5	18	200	15	200	W64		2 SC 1590
2 SC 1592		Si	3,5	0,100	18	2,7 GHz	30	200	T136		BLX 37
2 SC 1593		Si	4,3	0,150	20	2 GHz	15	200	T136		BLX 37
2 SC 1594		Si	7	0,200	18	2,5 GHz	20	200	T136	2 SC 2066	
2 SC 1595		Si	7	0,300	22	2,5 GHz	20	200	T136	2 SC 2066	
2 SC 1596		Si	0,450	0,050	120	130		60	R213	2 N 5194	2 SC 1438
2 SC 1600		Si	4,375			2 GHz		200	T046	sans	sans
2 SC 1605	A	Si	35	3,5	17	500	10	180	T0117	2 SC 1178 A	2 N 5705
2 SC 1606		Si	6	0,600	18	1 GHz	10	180	T05	BLX 65	40280
2 SC 1607		Si	0,180	0,100	20	BF		50	T072	BC 173 A	PBC 108
2 SC 1608		Si	5	0,500	20			50	T072	2 N 3924	MRF 230
2 SC 1610		Si	100					30	T03	caractéristiques insuffisantes	
2 SC 1617		Si	50	7	100	10	30	150	T03	DB 539 C	2 N 5479
2 SC 1618		Si	50	6	60	10	20	180	T03	2 SD 201	2 N 6130
2 SC 1619		Si	50	6	80	10	20	180	T03	2 SD 202	2 N 6131
2 SC 1620		Si	10	0,600	18		10	200	T0131	2 SC 1405	2 N 5423
2 SC 1621	B2	Si	0,150	0,200	20	400	40		X156	BCW 31 (voir page suivante)	

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature		Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
								min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1621 B3	Si	NPN	0,150	0,200	20	400	60		X156	BCW31	} av. le précédent transistor pour circuits hybrides. (ESCSOSEM). boîtier SOT23	
2 SC 1621 B4	Si	NPN	0,150	0,200	20	400	90		X156	BCW31		
2 SC 1622	Si	NPN	0,150	0,030	25			400	X156	BSF 18		
2 SC 1622 D6	Si	NPN	0,150	0,030	25		200		X156	BFS 18	transistors	
2 SC 1622 D7	Si	NPN	0,150	0,030	25		300		X156	BFS 19	pour	
2 SC 1622 D8	Si	NPN	0,150	0,030	25		450		X156	BFS 19	circuits	
2 SC 1623	Si	NPN	0,150	0,100	40			200	X156	BCW 71 (R)	hybrides	
2 SC 1623 L3	Si	NPN	0,150	0,100	40		60		X156	BCW 71 (R)	boîtier	
2 SC 1623 L4	Si	NPN	0,150	100	40		90		X156	BCW 71 (R)	SOT23	
2 SC 1623 L5	Si	NPN	0,150	0,100	40		135		X156	BCW 72 (R)	marque	
2 SC 1623 L6	Si	NPN	0,150	0,100	40		200		X156	BCW 72 (R)	R T C	
2 SC 1623 L7	Si	NPN	0,150	0,100	40		300		X156	BCW 72 (R)		
2 SC 1624	Si	NPN	15	1	120	30	70	240	T0220	2 N 4864	SDT 5905	
2 SC 1625	Si	NPN	15	1	100	30	70	240	T0220	2 N 2783	TIC 29 C	
2 SC 1626	Si	NPN	1,5	0,750	80	100	70	240	B26	BC 367	2 N 4133	
2 SC 1627	Si	NPN	0,625	0,300	80	80	200		R67	BC 489 B	B 489 B 18	
2 SC 1628	Si	NPN	1	0,050	150	120	70	240	B14	2 N 4925	2 N 4925 S	
2 SC 1629	Si	NPN	50	8	70	10	500	1500	T03	BD 543 B	2 N 1723	
2 SC 1630	Si	NPN	0,750	0,030	175	100		100	T05	BF 292 B	BF 294	
2 SC 1635	Si	NPN	0,800	1	50	BF		50	R216	BFY 56 B	BFY 56 A	
2 SC 1636	Si	NPN	0,300	0,020	25	30	180		X153	2 N 702	2 N 703	
2 SC 1637	Si	NPN	0,300	0,020	25	20		200	X153	2 N 702	2 N 703	
2 SC 1638	Si	NPN	0,600	0,300	20	1 GHz		100	R176	2 SC 651	BFW 17	
2 SC 1656	Si	NPN	0,250	0,030	6	7 GHz		100	W18		2 SC 1559	
2 SC 1660	Si	NPN	0,350	0,080	8	6 GHz		100	W12		2 SC 1559	
2 SC 1663	Si	NPN	0,950	0,500	140	50		150	B2	2 N 6591	2 N 4069	
2 SC 1664	Si	NPN	40	6	60	10	500	1500	T066	2 SC 1618	2 N 6130	
2 SC 1667	Si	NPN	50	4	80	10	40	200	T03	BDW 53 B	2 N 6295	
2 SC 1668	Si	NPN	40	6	18		10		T106	2 SC 1476		
2 SC 1669	Si	NPN	1,5	1,5	150	6	40	240	B26		40349 V 2	
2 SC 1670	Si	NPN	0,750	0,500	140	50		150	R195	BF 157	2 N 3712	
2 SC 1672	Si	NPN	120				21		T03	caractéristiques	insuffisantes	
2 SC 1674 K	Si	NPN	0,250	0,020	20	600	90		R182	2 N 4254	BF 199	

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1674 L	Si	NPN	0,250	0,020	20	600	60		R182	2 N 4996	BF 199
2 SC 1674 M	Si	NPN	0,250	0,020	20	600	40		R182	2 N 4255	BF 199
2 SC 1675 K	Si	NPN	0,250	0,020	30	250	90		R182	BF 594	TIS 125
2 SC 1675 L	Si	NPN	0,250	0,020	30	250	60		R182	BF 594	TIS 125
2 SC 1675 M	Si	NPN	0,250	0,020	30	250	40		R182	BF 595	TIS 125
2 SC 1676	Si	NPN	30	3	25	200	10		T121		2 SC 1677
2 SC 1677	Si	NPN	45	5	25	200	10		T121		2 SC 1676
2 SC 1678	Si	NPN	10	3	65	100	15		T0220	2 N 3420	2 N 3418
2 SC 1679	Si	NPN	10	3	65	100	15		T0220	2 N 3420	2 N 3418
2 SC 1680	Si	NPN	15	2	18	400	10		T106	2 SC 1725	
2 SC 1681	Si	NPN	0,200	0,050	60	130	200		R67	BC 190 B	2 N 3858 A
2 SC 1682	Si	NPN	0,200	0,050	40	130	200		R67	BC 207 B	BC 207
2 SC 1683	Si	NPN	20	0,500	150	150	60	200	B17	MJE 341	BD 173
2 SC 1684	Si	NPN	0,250	0,100	25	150		650	T092	BC 408 C	BC 409 C
2 SC 1685	Si	NPN	0,250	0,100	50	150		650	T092	BC 407 B	BC 407 A
2 SC 1686	Si	NPN	0,250	0,025	30	550	26		T092	TIS 84	TIS 83
2 SC 1687	Si	NPN	0,400	0,030	25	820	38		T092	BF 375 D	MA 9002
2 SC 1688	Si	NPN	0,400	0,030	40	820	38		T092	2 SC 1164	MA 9001
2 SC 1689	Si	NPN	45	3	35	400	10	180		2 SC 1314	
2 SC 1706 H	Si	NPN	0,200	0,050	150	60	30		T018	2 N 5550	MPSD 02
2 SC 1707 AH	Si	NPN	0,200	0,100	50	100	100		T018	BC 171	BC 182 KB
2 SC 1707 H	Si	NPN	0,200	0,100	30	100	100		T018	2 N 3856 A	BC 184 K
2 SC 1708	Si	NPN	0,200	0,050	90	150		500	T092	BSX 21	2 N 5175
2 SC 1710	Si	NPN	1	0,130	10	7 GHz		80	T130	sans	sans
2 SC 1711 A	Si	NPN	0,200	0,030	13	7,5 GHz		80	W82	FT 1720 AR	FT 1720 R
2 SC 1712	Si	NPN	0,200	0,030	8	8 GHz		80	W82	FT 1720 AR	FT 1720 R
2 SC 1713	Si	NPN	0,200	0,030	8	8 GHz		80	W84		FT 5720 R
2 SC 1714	Si	NPN	0,200	0,030	8	8 GHz		80	W85		FT 5726 CR
2 SC 1715	Si	NPN	0,200	0,030	8	8 GHz		80	W85		FT 5726 CR
2 SC 1716	Si	NPN	0,200	0,030	8	8 GHz		80	W85		FT 5728 CR
2 SC 1717	Si	NPN	10	1	20			20	F17	BFS 22 A	2 N 5846
2 SC 1718	Si	NPN	30	4,5	18			10	T106	2 SC 1476	2 SC 1242 A
2 SC 1719	Si	NPN	1	0,050	120	130	50		R214	2 N 5185	2 SC 1903

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1720	Si	NPN	1	0,050	150	130	50		R214	2 N 4069	2 SC 1904
2 SC 1721	Si	NPN	0,500	1	60	BF		50	R195	2 N 2895	2 N 2898
2 SC 1722	Si	NPN	12	0,200	300	80	50	300	B17	2 SC 1507	MJE 3440
2 SC 1723	Si	NPN	15	0,200	300	70	40	200	B17	MJE 3439	2 N 3739
2 SC 1724	Si	NPN	7,5	0,800	17	200	10		T106		2 SC 1765
2 SC 1725	Si	NPN	15	1,4	17	1,6 GHz	10		T106	2 SC 1197 A	2 SC 1241 A
2 SC 1726	Si	NPN	30	2,8	17	1,2 GHz	10		T106	2 SC 1503	2 SC 1718
2 SC 1727	Si	NPN	0,300	0,025	35	700	50		T092	MPSH 33	BF 371
2 SC 1728	Si	NPN	0,950	0,500	50	80		250	B2	40537	40537 S
2 SC 1729	Si	NPN	35	3,5	17	500	10	180	T0117	2 SC 1605 A	2 SC 1178 A
2 SC 1730	Si	NPN	0,250	0,050	18	1,1 GHz		80	R182	SCA 3021	2 N 5053
2 SC 1734 H	Si	NPN	0,100	0,030	30	BF	160		T018	BF 167	BCW 83
2 SC 1735	Si	NPN	0,800	0,500	100	130		130	T092	2 N 2941	2 N1340
2 SC 1736	Si	NPN	0,500	0,100	50	150		500	T092	BC 550 C	2 N 1711/46
2 SC 1737	Si	NPN	0,500	0,100	35	150		500	T092	2 N 2222 A	2 N 2222
2 SC 1738	Si	NPN	0,500	0,100	35	150		500	T092	2 N 2222 A	2 N 2222
2 SC 1742	Si	NPN	0,150	0,030	10	5,5 GHz		120	W69		2 SC 1743
2 SC 1743	Si	NPN	0,175	0,030	15	3,5 GHz		70	W69	HXTR 6101	2 SC 1742
2 SC 1744	Si	NPN	70	10	18	300	10		W58	sans	sans
2 SC 1747	Si	NPN	0,300	0,100	20	1,4 GHz	25		T072	MS 175 H	2 N 5201
2 SC 1748	Si	NPN	0,800	0,100	300	50	30		T039	BF 259	BFR 89
2 SC 1749	Si	NPN	1,2	0,100	220	80	35	230	B15	BF 179 B	BF 179 C
2 SC 1755	Si	NPN	15	0,700	300	50		200	T0220		BD 215
2 SC 1756	Si	NPN	15	0,700	300	50		200	B8		BD 215
2 SC 1757	Si	NPN	15	0,700	300	50		200	T0220		BD 215
2 SC 1760	Si	NPN	0,950	0,500	50	80		250	B2	2 SC 1728	40537 S
2 SC 1761	Si	NPN	0,950	2	16	80	200		B2	BD 505	BD 505-1
2 SC 1762	Si	NPN	0,470	0,150	400	13	30		T039	TRS 401	TRS 425
2 SC 1763	Si	NPN	80	7	35	50	10		W34		2 N 5941
2 SC 1764	Si	NPN	140	12	35	50	10		W34		2 N 5942
2 SC 1765	Si	NPN	7,5	0,800	17	50	10		F17		2 SC 1724
2 SC 1766	Si	NPN	0,310	0,100	30	230		150	T092	A 5 T 4123	A 5 T 4124
2 SC 1768	Si	NPN	50	5	150	15	400	3000	T03		BU 409

• Ic = Puissance collecteur max.

• Ic = Courant collecteur max.

• Vce max = Tension collecteur émetteur max.

• Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium

• Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1775	Si	NPN	0,300	0,050	90	200	160		T092	BC 449	MPSH 04 ou 05
2 SC 1775 A	Si	NPN	0,300	0,050	120	200	160		T092	2 SC 1890 A	BC 285
2 SC 1776	Si	NPN	0,300	0,250	40	220		150	R212	BC 167 A	BC 171 A
2 SC 1777	Si	NPN	50	6	70	10	30	150	T03	2 N 5616 ou 18	SK 3054
2 SC 1778	Si	NPN	0,150	0,015	20	600		50	T092	BF 200*	BF 182
2 SC 1779	Si	NPN	0,150	0,020	20	450	25		T092	BF 200	BF 182
2 SC 1780	Si	NPN	0,150	0,015	18			50	S9	2 N 1205	TI 492
2 SC 1781 H	Si	NPN	0,350	0,500	50	150	80		T018	2 N 3642	BCW 34
2 SC 1787	Si	NPN	0,150	0,050	35		260	50	S9	2 N 2534	2 N 2903
2 SC 1788	Si	NPN	0,600	0,500	20	150		220	T092	2 N 2959	BC 338
2 SC 1789	Si	NPN	0,200	0,050	18	1,6 GHz	20		T092		2 N 3839
2 SC 1790	Si	NPN	0,150	0,015	18			50	T072	2 N 1205	TI 492
2 SC 1791	Si	NPN	11	1	23	1 GHz	15	250	T59	PT 3503	2 SC 1040
2 SC 1792	Si	NPN	22	2	23	600 k min	15	250	T59	3 TX 602	2 SC 892
2 SC 1793	Si	NPN	42	4	23	300 k min	15	250	T59	PT 5693	2 SC 704
2 SC 1797	Si	NPN	6	0,300	50		20	150	W77	MSC 3001 SP	MSC 80118
2 SC 1798	Si	NPN	11	1	50		20	150	W77	MSC 3003 SP	MSC 4003 SP
2 SC 1799	Si	NPN	19	2	50		20	150	W77	MSC 3005 SP	MSC 2005
2 SC 1800	Si	NPN	29	3	50		20	150	W77	MSC 4005 SP	MSC 2010
2 SC 1804	Si	NPN	10	1	47	1,2 GHz	10	180			DM 10 P
2 SC 1805	Si	NPN	30	2	45	1 GHz	10	180			DM 30 P
2 SC 1806	Si	NPN	50	4	45	1 GHz	10	180			DM 50 P
2 SC 1807	Si	NPN	0,300	0,100	8,5	1 GHz		50	T018	2 N 3633	2 N 2784
2 SC 1808	Si	NPN	10	1	17	1,2 GHz	10	180		2 SC 1966	BLY 68
2 SC 1810	Si	NPN	0,950	1	300	13	30		B2	40886	BF 417
2 SC 1811	Si	NPN	0,750	0,100	150	250		150	R195	2 N 3501	BF 257
2 SC 1812	Si	NPN	0,210	0,020	22	1 GHz	20			2 SC 1260	2 N 4934
2 SC 1815	Si	NPN	0,300	0,100	40	200		400	T092	BSX 79 B	BC 237
2 SC 1816	Si	NPN	16	4	60	140	28	252	T0220	2 N 6413	BDY 78
2 SC 1819	Si	NPN	10	0,100	250	100	50	250	B17	2 SC 1550	BD 127
2 SC 1820	Si	NPN	3	0,500	35		50		T039	2 N 4428	2 N 1092
2 SC 1821	Si	NPN	7	0,500	35		50		T129	2 SC 1561	BLX 92
2 SC 1822	Si	NPN	12	1	35		50		T129	2 SC 1524	2 N 5918

A. Darlington

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	N a t u r e	P o l a r i t é	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1823	Si	NPN	25	2	35		50		T129	2 SC 1563	2 SC 1526
2 SC 1824	Si	NPN	40	4	35		50		T129	2 SC 1564	41504
2 SC 1825	Si	NPN	75	8	35		50		W81		2 N 5691
2 SC 1826	Si	NPN	30	4	60	10	40	400	B26	BD 439	2 N 5295
2 SC 1827	Si	NPN	30	4	80	10	40	400	B26	BD 441	2 N 5293
2 SC 1828	Si	NPN	40	3	400	7	30	200	T066	TIP 75 C	2 N 5468 ou 69
2 SC 1829	Si	NPN	100	5	150	15	400	3000	T03		2 N 3431
2 SC 1830 4)	Si	NPN	150	15	140	10	500		T03	MJ 3521	MJ 3520
2 SC 1833	Si	NPN	0,300	0,200	40	280		160	R182	BC 107	BC 167
2 SC 1835	Si	NPN	8	1	15	500	10	180		BLY 55	40281
2 SC 1836	Si	NPN	30	5	15	500	10	180	T0129	2 SC 1190	2 N 5705
2 SC 1837	Si	NPN	7,5	0,600	20		50		W16		MRF 237
2 SC 1838	Si	NPN	15	1,5			50		W16	caractéristiques	insuffisantes
2 SC 1846	Si	NPN	1,2	1	35	200	60	340	T0126	2 N 5079	2 N 5080
2 SC 1847	Si	NPN	1,2	1,5	40	150	30	220	T0126	2 SC 1516 K	PE 8051
2 SC 1848	Si	NPN	1,2	2	50	150	30	220	B15		MM 5262
2 SC 1849	Si	NPN	0,350	0,200	25	150		150	T092	BC 318 A	BC 319
2 SC 1850	Si	NPN	0,350	0,200	50	150		150	T092	BC 317 A	BC237
2 SC 1851	Si	NPN	0,650	1	25	200		160	T092	BC 338-5	BC 338-18
2 SC 1852	Si	NPN	0,650	1	50	200		160	T092	BC 485 A5	BC 485 A18
2 SC 1855	Si	NPN	0,250	0,020	20	550	20		T092	2 N 4255	2 N 4997
2 SC 1856	Si	NPN	0,250	0,020	20	550	20		T092	2 N 4255	2 N 4997
2 SC 1863	Si	NPN	40	7	100	BF	15		F12	Tt 1132	40871
2 SC 1864	Si	NPN	40	7	250	BF	15		F12	TIP 55 A	18512 A ou B
2 SC 1865	Si	NPN	40	7	400	BF	10		F12	TIP 58 A	2 N 6079
2 SC 1866	Si	NPN	80	7	100	BF	15		T03	181 T2 A	BD 543 C
2 SC 1867	Si	NPN	80	7	250	BF	15		T03	2 N 6511	2 N 5388
2 SC 1868	Si	NPN	80	7	400	BF	10		T03	FT 443	TIP 152
2 SC 1869	Si	NPN	100	10	100	BF	15		T03	2 N 5632	2 N 5288
2 SC 1870	Si	NPN	100	10	250	BF	15		T03	BUX 17 A	BUX 17 B
2 SC 1871	Si	NPN	100	10	400	BF	10		T03	BUY 69 A	SDT 1058
2 SC 1876 H 4)	Si	NPN	0,800	0,500	100		1000		T039	sans	sans
2 SC 1879 H 4)	Si	NPN	8	2	120		1000		T039	2 SC 2165 H	

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1881 K 4)	Si	NPN	30	3	60		1000		B17	BD 262	BD 263
2 SC 1882 H 4)	Si	NPN	8	5	120		1000	20000	R90	2 SC 2165 H	
2 SC 1884 H 4)	Si	NPN	50	8	120		1000		T066	BD 651	BD 335
2 SC 1885	Si	NPN	0,750	0,100	150	200		150	R182	2 SC 589	
2 SC 1888	Si	NPN	0,800	3	60	15	500		T05	BSX 63-16	BSX 63-10
2 SC 1889	Si	NPN	0,800	3	80	15	500		T05	BSX 64-10	
2 SC 1890	Si	NPN	0,300	0,050	90	200	160		T092	2 SC 1775	BC 449
2 SC 1890 A	Si	NPN	0,300	0,050	120	200	160		T092	2 SC 1775 A	BC 285
2 SC 1891	Si	NPN	50	1,5	1200	3	8	20	T03		BDX 32
2 SC 1892	Si	NPN	50	2,5	1500	3	8	30	T03	BU 105	IR 721
2 SC 1893	Si	NPN	50	3,5	500	3	8	30	T03	2 N 5157	IR 665
2 SC 1894	Si	NPN	50	6	600	3	8	20	T03		BU 126
2 SC 1895	Si	NPN	50	6	600	2	8	30	T03		BU 126
2 SC 1896	Si	NPN	50	7	600	2	8	40	T03		BU 126
2 SC 1903	Si	NPN	1	0,050	120	130	150		B5	2 SC 1719	2 N 5185
2 SC 1904	Si	NPN	1	0,050	150	130	150		B5	2 SC 1720	2 N 3500
2 SC 1906	Si	NPN	0,300	0,050	19	1 GHz	40		T092	2 N 5201	2 N 6600
2 SC 1907	Si	NPN	0,300	0,050	19	1,1 GHz	40		T092	2 N 5201	2 N 6600
2 SC 1909	Si	NPN	10	3	75	160	20	150	T0220	2 SC 2092	2 N 6416
2 SC 1910 a)	Si	NPN	0,200		15 (Vcb)	6 GHz	30		W35	sans équivalents	
2 SC 1911 a)	Si	NPN	0,150		20 (Vcb)	5 GHz	40		W35	causes boîtier	
2 SC 1912 a)	Si	NPN	0,150		20 (Vcb)	5 GHz	40		W35	et fréquence	
2 SC 1913	Si	NPN	15	1,5	150	120	65	330	B26	UPT 321	2 SC 680 A
2 SC 1919	Si	NPN	0,200	0,030	50	150	250		T092	2 N 3694	BC 207
2 SC 1920 a)	Si	NPN	0,200		15 (Vcb)	6 GHz	30		W35	voir ci-dessus à W35	
2 SC 1921	Si	NPN	0,600	0,050	200	130	30		R195	BF 179 B	2 N 6220
2 SC 1922	Si	NPN	50	2,5	800				T03	IR 709	IR 710
2 SC 1923	Si	NPN	0,100	0,020	30	550		140	T092	BF 251	BF261
2 SC 1928	Si	NPN	0,315	0,050	50	10	200		X153	2 N 5232	2 N 5311
2 SC 1929	Si	NPN	25	1	300	80	35	330	B17	MJE 48	TIP 48
2 SC 1931	Si	NPN	0,150	0,030	8	7 GHz	80		W84		2 SC 1713
2 SC 1932	Si	NPN	0,200	0,030	8	7 GHz	80		W85		2 SC 1714
2 SC 1933	Si	NPN	0,200	0,040	10	5 GHz	80		W84	FT 5720 R	

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

Ge = Germanium
 Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SC 1934	Si	NPN	0,500	0,080	10	5 GHz	80		T131	FT 5735 R	
2 SC 1936	Si	NPN	0,200	0,030	10	5 GHz	80		W84	FT 5720 R	
2 SC 1938	Si	NPN	0,200	0,030	10	5 GHz	80		W85	FT 5726 CR	FT 5728 CR
2 SC 1939	Si	NPN	0,200	0,030	10	5 GHz	80		W85	FT 5726 CR	FT 5728 CR
2 SC 1942	Si	NPN	50	3	800				T03	IR 708	IR 709
2 SC 1945	Si	NPN	10	6	40	150	10	180	B26		2 N 3624
2 SC 1946	Si	NPN	50	7	17	400	10	180		sans : cause boîtier	
2 SC 1947	Si	NPN	1	1	17	500	10	180	T039	2 N 4427	BSY 81
2 SC 1954	Si	NPN	0,450	0,150	20	1,5 GHz		100	R195	MS 12 H	MST 75 H
2 SC 1957	Si	NPN	0,750		40	250		90	B16	2 N 2218 A	2 N 2224
2 SC 1962	Si	NPN	0,950	0,500	200	45	70		B2	BF 292 B	BF 292 C
2 SC 1964	Si	NPN	12	3,5	40	150	10	180	B26	2 SC 1239	2 N 5786
2 SC 1965	Si	NPN	1,5	1	17	500	10	180	F19	BFS 22	BFR 98
2 SC 1966	Si	NPN	10	1	17	1 GHz	10	180		2 SC 1808	BLY 68
2 SC 1967	Si	NPN	20	2	17	1 GHz	10	180			BLW 18
2 SC 1968	Si	NPN	40	5	17	600	10	180			CD 1803
2 SC 1968 A	Si	NPN	40	5	17	800	10				CD 1803
2 SC 1969	Si	NPN	20	6	30	150	10	180	B26		KS 6116
2 SC 1973	Si	NPN	0,750	0,500	50 (Vcb)	300	20		R182	2 N 3724	2 N 5145
2 SC 1975	Si	NPN	15	2	90	150	50	200	B26	2 N 2782	2 N 2783
2 SC 1983	Si	NPN	30	3	60	15	500	3000	B26	BD 177	TIP 31 A
2 SC 1984	Si	NPN	30	3	80	15	500	3000	B26	BD 179	TIP 31 B
2 SC 1985	Si	NPN	40	6	60	10	40	400	B26	BDW 63 A	2 N 6130
2 SC 1986	Si	NPN	40	6	80	10	40	400	B26	BDW 63 B	2 N 6131
2 SC 1987	Si	NPN	50	6	90				T066	TIP 41 B	BD 243 B
2 SC 1988	Si	NPN	0,350	0,070	12	4,5 GHz		70	T072	MRF 914	BFS 55 A
2 SC 2017	Si	NPN	100	10	400		8		T03	2 N 6251	BUY 69 A
2 SC 2018	Si	NPN	100	15	300		7		T03	BDY 46	2 SD 376 A
2 SC 2019	Si	NPN	100	15	200		10		T03	BUX 41	2 SD 376
2 SC 2025	Si	NPN	0,350	0,050	18	2,2 GHz		100	T072	MS 175 H	MS 12 H
2 SC 2026	Si	NPN	0,250	0,050	14	2 GHz		80	T092	2 SC 2037	2 N 5762
2 SC 2027	Si	NPN	50	5	800				T03	BU 126	STI 801
2 SC 2034	Si	NPN	12	2	90	150	50	200	T039	2 N 5152	2 N 6409

• Pc = Puissance collecteur max.
 • Ic = Courant collecteur max.
 • Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 • Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SD 73	Si	NPN	60	7,5	60		25	80	T03	TIP 41 A <small>marque RCA</small>	2 N 1616 A
2 SD 74	Si	NPN	60	7,5	90		25	80	T03	TIP 41 C <small>marque RCA</small>	2 N 1618 A
2 SD 75	Ge	NPN	0,150	0,100	25	4		40	T01	2 N 1605	2 N 2426
2 SD 75 A	Ge	NPN	0,150	0,100	45	4		40	T01	2 N 1473	2 N 1605-A
2 SD 75 AH	Ge	NPN	0,150	0,100	30	3		40	T01	SK 3010-RT	2 N 1102/5
2 SD 75 H	Ge	NPN	0,150	0,100	30	3		40	T01	SK 3010-RT	2 N 1102/5
2 SD 77	Ge	NPN	0,150	0,100	25	3,5		55	T01	2 N 1605	2 N 2426
2 SD 77 A	Ge	NPN	0,150	0,100	45	3,5		55	T01	2 N 1473	2 N 1605-A
2 SD 77 AH	Ge	NPN	0,150	0,100	30	3,5		55	T01	SK 3010-RT	2 N 1102/5
2 SD 77 H	Ge	NPN	0,150	0,100	30	3,5		55	T01	SK 3010-RT	2 N 1102/5
2 SD 78	Si	NPN	1	2	60		80		T05	BD 373 B	2 N 5414
2 SD 78 A	Si	NPN	15	2	80		40	160	T05	2 N 2874	2 N 2781
2 SD 79	Si	NPN	15	2	60		40	160	F19	BD 167	2 N 5598
2 SD 80	Si	NPN	50	6	20	1,5	40	60	T03		BD 195
2 SD 81	Si	NPN	50	6	40	1,5	40	60	T03	2 N 6129	BD 539
2 SD 82	Si	NPN	50	6	60	1,5	40	60	T03	2 N 5494	BD 243 A
2 SD 83	Si	NPN	50	6	75	1,5	40	60	T03	2 N 6131	BD 589 B
2 SD 84	Si	NPN	50	6	85	1,5	40	60	T03	2 SD 202	S 1350
2 SD 88	Si	NPN	83	5	300 (Vcb)	10	34	517	T03	183 T 2 C	TIP 150
2 SD 88 A	Si	NPN	125	10	300 (Vcb)	12	34	517	T03	2 N 6249	PTC 118
2 SD 88-1	Si	NPN	80	5	50	BF	34	230	T03	180 T 2 C	2 N 5977
2 SD 88-2	Si	NPN	80	5	58	BF	34	230	T03	181 T 2 C	2 N 5979
2 SD 88-3	Si	NPN	80	5	100	BF	34	230	T03	181 T 2 C	BLX 20
2 SD 90	Si	NPN	20	3	20		20	40	F5	MJE 520	2 N 3927
2 SD 91	Si	NPN	20	3	40		20	40	F5	BDY 12-6	TIP 29
2 SD 92	Si	NPN	20	3	55		20	40	F5	BDY 13-6	TIP 29 A
2 SD 93	Si	NPN	20	3	70		20	40	F5	BDY 13-6	TIP 29 B
2 SD 94	Si	NPN	20	3	80		20	40	F5	BD 179	TIP 29 B
2 SC 96	Ge	NPN	0,300	0,250	18	4		90	T01	40396/N	AC 187
2 SD 100	Ge	NPN	0,250	0,400	32	1,5		75	R10	2 N 1473	2 N 2430
2 SD 100 A	Ge	NPN	0,250	0,400	45	1,5		75	R10	2 N 2430	2 N 1473
2 SD 101	Ge	NPN	0,250	0,600	80			70	R93	BSX 21	MPSH 04 ou 5
2 SD 102	Si	NPN	25	3	80	1,5	30	300	T066	<small>silicium</small> 2 SD 877	<small>silicium</small> TIP 29 B

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SD 103	Si	NPN	25	3	50	1	30	300	T066	BDY 12-16	BDY 12-10
2 SD 104	Ge	NPN	0,150	0,400	20 (Vcb)	2,800	60		T01	2 N 1306	ASY 29
2 SD 105	Ge	NPN	0,150	0,400	20 (Vcb)	2,800	35		T01	2 N 1304	ASY 28
2 SD 107	Si	NPN	50	5	60	30	1 000	10 000	T03	TIP 620	TIP 625
2 SD 108	Si	NPN	50	5	40		1 000	10 000	T03	2 N 6034	2 N 6037
2 SD 110	Si	NPN	100	10	110	2	20	40	T03	2 N 5628	TIP 602
2 SD 111	Si	NPN	100	10	80	2	20	40	T03	2 N 5624	2 N 5626
2 SD 113	Si	NPN	200	30	80	0,500	10	60	T03	2 N 6327	MJ 802
2 SD 114	Si	NPN	200	30	50	0,500	10	60	T03	2 N 6326	MJ 3771
2 SD 116	Si	NPN	75	7	100 (Vcb)	BF	80	120	T03	TI 1133	40369
2 SD 117	Si	NPN	75	7	150 (Vcb)	BF	80	120	T03	TI 1135	2 SD 218
2 SC 118	Si	NPN	100	7	110	2	30	200	T03	BD 550	RCA1 B06
2 SD 118 BL	Si	NPN	100	7	110	2	80	200	T03	BD 550	RCA1 B06
2 SD 118 R	Si	NPN	100	7	110	2	30	70	T03	BD 550	RCA1 B06
2 SD 118 Y	Si	NPN	100	7	110	2	50	120	T03	BD 550	RCA1 B06
2 SD 119	Si	NPN	100	7	80	2	30	200	T03	2 N 5874	
2 SD 119 BL	Si	NPN	100	7	80	2	80	200	T03	2 N 5874	
2 SD 119 R	Si	NPN	100	7	80	2	30	70	T03	2 N 5874	
2 SD 119 Y	Si	NPN	100	7	80	2	50	120	T03	2 N 5874	
2 SD 120	Si	NPN	1	1,5	40		15	100	T05	2 N 6376	MC 160
2 SD 120 H 5c	Si	NPN			T. recouv. 0,7 ns	0,800		60	T039	2 N 5559	ACY 40
2 SD 121	Si	NPN	1	1,5	55		15	100	T05	2 N 3735	40367
2 SD 121 H 5c	Si	NPN			T. recouv. 0,7 ns	0,800		60	T039	2 N 5559	ACY 40
2 SD 122	Si	NPN	15	3	60 (Vcb)	0,600	20	60	T08	BD 131	BD 617
2 SD 123	Si	NPN	15	3	100 (Vcb)	0,600	20	60	T08	BD 133	BD 619
2 SD 124	Si	NPN	60	6	60 (Vcb)	0,500	30		T03	TIP 41 A	BD 197
2 SD 124 A	Si	NPN	60	7	75 (Vcb)	1	30		T03	2 N 5492	2 N 5346
2 SD 124 AH	Si	NPN	60	7	50	1	20	80	F6	2 N 5490	2 N 5491
2 SD 125	Si	NPN	60	6	100 (Vcb)	0,500	30		T03	TIP 41 C	BD 601
2 SD 125 A	Si	NPN	60	7	100 (Vcb)	1	30		T03	2 N 5497	2 N 5479
2 S125 AH	Si	NPN	60	7	75	1	20	80	F6	2 N 5496	2 N 5477
2 SD 126	Si	NPN	60	7	150 (Vcb)	0,500	10		T03	2 SC 2199	BD 543 D
2 SD 126 H	Si	NPN	60	7	100	1	20	40	F6	181 T2A	181 T2B

- Pc = Puissance collecteur max.
- Ic = Courant collecteur max.
- Vce max = Tension collecteur émetteur max.
- Fmax = Fréquence max.

- Ge = Germanium
- Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SD 127	Ge	NPN	0,250	0,500	20			82	T01	AC 185	2 N 576 A
2 SD 127 A	Ge	NPN	0,250	0,500	20		46		T01	AC 185	2 N 576 A
2 SD 128	Ge	NPN	0,250	0,500	30			82	T01	2 N 1473	2 N 576 A
2 SD 128 A	Ge	NPN	0,250	0,500	30		46		T01	2 N 1473	2 N 576 A
2 SD 129	Si	NPN	25	3	80	1	30	200	T066	TIP 31 B	2 N 2308
2 SD 130	Si	NPN	25	3	50	1	30	200	T066	BDY 12-10	BDY 12-16
2 SD 131	Si	NPN	50	5	100 (Vcb)		40	80	T03	2 SD 175	BD 539 A
2 SD 132	Si	NPN	150	20	65		20	60	T03	40444	BDY 76
2 SD 134	Ge	NPN	0,030	0,005	60 (Vcb)			40		2 N 1311	2 N 1510
2 SD 136	Si	NPN	4	0,100	200		30	250	F6	BF 257	2 N 4926
2 SD 137	Si	NPN	4	0,100	300		30	250	F6	BF 259	HEPS 5024
2 SD 138	Si	NPN	30	1	200		50	100	S0T9	SK 3104	2 N 3583
2 SD 139	Si	NPN	30	1	300		50	100	S0T9	2 SD 766	TIP 48
2 SD 141	Si	NPN	15	3	12		30	240	F6		MRF 475
2 SD 142	Si	NPN	15	3	20		30	240	F6	BD 361	BD 361 A
2 SD 143	Si	NPN	15	2	40		30	240	F6	BD 613	UPT 221
2 SD 144	Si	NPN	15	2	50		30	240	F6	BD 615	BD 131
2 SD 146	Si	NPN	20	1	35	1,400	30	150	F6	2 N 2948	BD 165
2 SD 147	Si	NPN	20	1	50	1,400	20	150	F6	2 N 3766	3005
2 SD 148	Si	NPN	20	2	70	1,200	35		F12	2 N 5598	2 N 5600
2 SD 149	Si	NPN	0,800	1	70	1,200		40	T039	2 N 1252 A	2 N 4897
2 SD 150	Si	NPN	15	1	40	0,010	30	240	F6	SK 3049	TIP 29
2 SD 151	Si	NPN	120	15	70	1	30		T03	2 N 3055	BDX 10
2 SD 152	Si	NPN	15	1	70		30	70	F6	TIS 140	NSD 104
2 SD 153	Si	NPN	120	5	200	10	30	160	T063	STA 8309	MJ 410
2 SD 154	Si	NPN	20	3	60		40	145	F6	2 SD 255	2 N 4232
2 SD 155	Si	NPN	20	3	60		4	145	T066	2 SD 255	2 N 4232
2 SD 156	Si	NPN	4	0,100	200		20	250	T066	BF 257	2 N 4926
2 SD 157	Si	NPN	4	0,100	300		20	250	T066	BF 259	HEPS 5024
2 SD 158	Si	NPN	30	1	200	16	20	250	T066	SK 3104	2 N 3583
2 SD 159	Si	NPN	30	1	300	16	20	250	T066	2 SD 766	TIP 48
2 SD 160	Si	NPN	25	1,5	55		50		T08	2 N 2947	2 N 3297
2 SD 161	Si	NPN	100	10	70	1	30		T03	2 N 5624	2 N 5006

Pc = Puissance collecteur max.
 Ic = Courant collecteur max.
 Vce max = Tension collecteur émetteur max.
 Fmax = Fréquence max.

• Ge = Germanium
 • Si = Silicium

TRANSISTORS

TYPE	Nature	Polarité	Pc (W)	Ic (A)	Vce max. (V)	F max. (MHz)	Gain		Type de boîtier	Équivalences	
							min.	max.		La plus approchée	Approximative
2 SD 162	Ge	NPN	0,065	0,030	15	3		60	R18	2 N 164	2 N 440
2 SD 163	Si	NPN	100	10	40	0,800	15	30	T03	BD 205	BD 605
2 SD 164	Si	NPN	100	10	55	0,800	15	30	T03	2 N 5622	2 N 5049
2 SD 165	Si	NPN	100	10	70	0,800	15	30	T03	2 N 5624	2 N 5622
2 SD 166	Si	NPN	100	10	85	0,800	15	30	T03	2 N 5624	2 N 5626
2 SD 167	Ge	NPN	0,200	0,500	20 (Vcb)			120	R16	2 N 576	2 N 1102/5
2 SD 168 4)	Si	NPN	50	10	70		2500		T03	BDX 85 A (100 W)	BDX 85 B (100 W)
2 SD 170	Ge	NPN	0,600	0,500	18		70	300	T01	AC 187 K	40396/N
2 SD 170 A	Ge	NPN	0,600	0,500	25		70	300	T01	2 SD 72	AC 176
2 SD 171	Si	NPN	125	3,5	150		30	100	T03		SDT 1626
2 SD 171-1	Si	NPN	125	3,5	150		30	200	T03		SDT 1626
2 SD 171-2	Si	NPN	125	3,5	200		30	200	T03	SDT 410	STI 410
2 SD 172	Si	NPN	100	10	40	1,200	10	60	T03	BD 205	BD 605
2 SD 173	Si	NPN	100	10	60	1,200	10	60	T03	2 N 5622	BD 607
2 SD 174	Si	NPN	50	5	40	1,200	6	60	T03	2 N 4395	BD 947
2 SD 175	Si	NPN	50	5	60	1,200	10	60	T03	2 SD 131	BD 539 A
2 SD 175 M	Si	NPN	50	5	60	0,500	15	45	T03	2 SD 131	BD 539 A
2 SD 176	Si	NPN	100	10	50	1,200	10	50	T03	2 N 5049	BD 205
2 SD 177	Si	NPN	100	10	70	1,200	10	50	T03	2 N 2624	2 N 5622
2 SD 177 M	Si	NPN	100	10	70	0,500	15	45	T03	2 N 2624	2 N 5622
2 SD 178	Ge	NPN	0,225	0,300	20 (Vcb)	1,500		90	R43	2 N 576	2 N 1431
2 SD 178 A	Ge	NPN	0,225	0,300	40 (Vcb)	1,500		90	R43	2 N 576 A	2 N 1605 A
2 SD 179	Si	NPN	580	40	300		10	100	MT99	SDT 55460	SDT 55560
2 SD 180	Si	NPN	60	6	70	10	30	120	T03	BD 293	BD 295
2 SD 181	Si	NPN	100	15	100	10	30	180	T03	BD 451	2 N 3055-3
2 SD 181 A	Si	NPN	100	10	200	10	30	180	T03	2 N 6249	BUY 69 C
2 SD 182	Si	NPN	10	1	30		15	120	T08		SK 3049
2 SD 183	Si	NPN	10	1	55		15	120	T08	TIS 139	BD 228
2 SD 184	Si	NPN	25	1,5	40	1,500	20	100	T08	BD 239	BD 165
2 SD 185	Si	NPN	25	1,5	55	1,500	20	100	T08	2 N 2947	2 N 3297
2 SD 186	Ge	NPN	0,200	0,150	20 (Vcb)			150	T01	2 N 576	2 N 1102/5
2 SD 187	Ge	NPN	0,200	0,150	25 (Vcb)			150	T01	2 N 1102/5	2 N 214 A
2 SD 188	Si	NPN	60	7	80	10	30	120	T03	2 SD 217	2 N 5496